

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6324214号
(P6324214)

(45) 発行日 平成30年5月16日 (2018. 5. 16)

(24) 登録日 平成30年4月20日 (2018. 4. 20)

(51) Int. Cl.

F I

HO 1 L 29/786 (2006. 01)
 HO 1 L 21/336 (2006. 01)
 HO 1 L 51/50 (2006. 01)
 HO 5 B 33/08 (2006. 01)

HO 1 L 29/78 6 1 7 N
 HO 1 L 29/78 6 1 2 Z
 HO 1 L 29/78 6 1 8 B
 HO 5 B 33/14 A
 HO 5 B 33/08

請求項の数 5 (全 86 頁)

(21) 出願番号 特願2014-110113 (P2014-110113)
 (22) 出願日 平成26年5月28日 (2014. 5. 28)
 (65) 公開番号 特開2015-15459 (P2015-15459A)
 (43) 公開日 平成27年1月22日 (2015. 1. 22)
 審査請求日 平成29年5月18日 (2017. 5. 18)
 (31) 優先権主張番号 特願2013-119149 (P2013-119149)
 (32) 優先日 平成25年6月5日 (2013. 6. 5)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(73) 特許権者 000153878
 株式会社半導体エネルギー研究所
 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地
 (72) 発明者 山崎 舜平
 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内
 (72) 発明者 三宅 博之
 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内
 (72) 発明者 井上 聖子
 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内
 (72) 発明者 松田 慎平
 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

発光素子と、
 前記発光素子の駆動トランジスタとして機能する第 1 のトランジスタと、
 前記第 1 のトランジスタと電気的に接続し、選択トランジスタとして機能する第 2 のトランジスタと、を含む画素を有し、
 前記第 1 のトランジスタは、
 絶縁表面上の第 1 のゲート電極と、
 前記第 1 のゲート電極上の第 1 の絶縁膜と、
 前記第 1 の絶縁膜を介して前記第 1 のゲート電極と重なる領域を有する第 1 の酸化物半
 導体膜と、
 前記第 1 の酸化物半導体膜と電気的に接続され、前記第 1 の酸化物半導体膜上に端部を
 有する一対の電極と、
 前記第 1 の酸化物半導体膜上の第 2 の絶縁膜と、
 前記第 2 の絶縁膜を介して、第 1 の酸化物半導体膜上に設けられ、前記第 1 のゲート電
 極と重なる領域を有する第 2 のゲート電極と、を有し、
 前記第 1 のゲート電極は、前記第 2 のゲート電極と接する領域を有し、
 前記第 2 のゲート電極は、チャネル幅方向において前記第 2 の絶縁膜を介して前記酸化
 物半導体膜の側面と対向する領域を有し、
 前記第 2 のトランジスタは、

10

20

前記絶縁表面上の第3のゲート電極と、
前記第3のゲート電極上の前記第1の絶縁膜と、
前記第1の絶縁膜を介して前記第3のゲート電極と重なる領域を有する第2の酸化物半
導体膜と、
前記第2の酸化物半導体膜と電氣的に接続され、前記第2の酸化物半導体膜上に端部を
有する一対の電極と、
前記第2の酸化物半導体膜上の前記第2の絶縁膜と、を有し、
前記第2のトランジスタの前記一対の電極の間隔は、前記第1のトランジスタの前記一
対の電極の間隔よりも大きいことを特徴とする表示装置。

【請求項2】

10

発光素子と、
前記発光素子の駆動トランジスタとして機能する第1のトランジスタと、
前記第1のトランジスタと電氣的に接続し、選択トランジスタとして機能する第2のト
ランジスタと、を含む画素を有し、
前記第1のトランジスタは、
絶縁表面上の第1のゲート電極と、
前記第1のゲート電極上の第1の絶縁膜と、
前記第1の絶縁膜を介して前記第1のゲート電極と重なる領域を有する第1の酸化物半
導体膜と、

前記第1の酸化物半導体膜と電氣的に接続され、前記第1の酸化物半導体膜上に端部を
有する一対の電極と、

20

前記第1の酸化物半導体膜上の第2の絶縁膜と、
前記第2の絶縁膜を介して、第1の酸化物半導体膜上に設けられ、前記第1のゲート電
極と重なる領域を有する第2のゲート電極と、を有し、
前記第1のゲート電極は、前記第2のゲート電極と接する領域を有し、

前記第2のゲート電極は、チャネル幅方向において前記第2の絶縁膜を介して前記酸化
物半導体膜の側面と対向する領域を有し、

前記第2のトランジスタは、
前記絶縁表面上の第3のゲート電極と、
前記第3のゲート電極上の前記第1の絶縁膜と、
前記第1の絶縁膜を介して前記第3のゲート電極と重なる領域を有する第2の酸化物半
導体膜と、

30

前記第2の酸化物半導体膜と電氣的に接続され、前記第2の酸化物半導体膜上に端部を
有する一対の電極と、

前記第2の酸化物半導体膜上の前記第2の絶縁膜と、を有し、
前記第2のトランジスタの前記一対の電極の間隔は、前記第1のトランジスタの前記一
対の電極の間隔よりも大きく、且つ、前記第2のトランジスタのカットオフ電流の値は前
記第1のトランジスタのカットオフ電流の値より小さいことを特徴とする表示装置。

【請求項3】

40

請求項1又は2において、
前記第2のトランジスタは、
前記第2の絶縁膜を介して前記第2の酸化物半導体膜上に設けられ、前記第3のゲート
電極と重なる第4のゲート電極を有し、
前記第3のゲート電極及び前記第4のゲート電極は、互いに接する領域を有することを
特徴とする表示装置。

【請求項4】

請求項1乃至3のいずれかーにおいて、
前記第1のゲート電極のチャネル長方向の幅は、前記第2のゲート電極のチャネル長方
向の幅よりも大きいことを特徴とする表示装置。

【請求項5】

50

請求項 1 乃至 4 のいずれか一において、
前記第 1 のトランジスタの前記一対の電極の間隔は、前記第 2 のゲート電極のチャンネル長方向の幅よりも大きいことを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本明細書等で開示する発明は、表示装置及びその作製方法に関する。特に、本発明の一態様は、酸化物半導体膜を有するトランジスタを備えた表示装置及びその作製方法に関する。

【背景技術】

10

【0002】

有機エレクトロルミネッセンス (Electroluminescence、以下 EL と記す) 等の発光素子を用いた表示装置は視認性が高く、薄型化に最適であると共に、視野角にも制限が無いため、CRT (cathode ray tube) や液晶表示装置に替わる表示装置として注目されている。発光素子を用いたアクティブマトリクス型の表示装置は通常、少なくとも発光素子と、画素へのビデオ信号の入力を制御するトランジスタ (スイッチング (選択) 用トランジスタ) と、当該発光素子に供給する電流値を制御するトランジスタ (駆動用トランジスタ) とが、各画素に設けられている。

【0003】

表示装置に用いられているトランジスタは、ガラス基板上に形成された非晶質シリコン、単結晶シリコンまたは多結晶シリコンなどのシリコン半導体によって構成されている。

20

【0004】

また、近年、シリコン半導体に代わって、半導体特性を有する金属酸化物 (酸化物半導体) をトランジスタに用いる技術が注目されている。例えば、酸化物半導体として、酸化亜鉛、または In - Ga - Zn 酸化物を用いたトランジスタを作製し、該トランジスタを表示装置の画素のスイッチング用トランジスタなどに用いる技術が開示されている (特許文献 1 参照)。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

30

【特許文献 1】特開 2007 - 123861 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

発光素子を含む表示装置では、駆動用トランジスタのドレイン電流が発光素子に供給される。従って、駆動用トランジスタが劣化し、しきい値電圧が変動すると、発光素子の輝度も変動する。従って、駆動用トランジスタのしきい値電圧の変動を抑制することは、表示装置の画質向上を図る上で重要な課題である。

【0007】

また、表示装置の高速駆動のためには、駆動用トランジスタとして、電界効果移動度の高いトランジスタを用いることが望まれる。

40

【0008】

一方、表示装置の低消費電力化のためには、選択用トランジスタとして、しきい値電圧がプラスとなる電気特性 (ノーマリーオフ特性ともいう。) のトランジスタを適用することが望まれる。または、選択用トランジスタとして、ドレイン電流 (I_d) - ゲート電圧 (V_g) 特性カーブにおいて、ゲート電圧が 0 V の時のドレイン電流 (カットオフ電流 (I_{cut})) の値が低減されたトランジスタを適用することが望まれる。

【0009】

上述の問題に鑑み、本発明の一態様は、トランジスタのしきい値電圧の変動による影響が低減された表示装置を提供することを課題の一とする。または、本発明の一態様は、信

50

頼性の高い表示装置を提供することを課題の一とする。

【0010】

また、本発明の一態様は、良好な表示特性を有する表示装置を提供することを課題の一とする。

【0011】

また、本発明の一態様は、低消費電力化を達成した表示装置を提供することを課題の一とする。

【0012】

なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。本発明の一態様は、これらの課題の全てを解決する必要はないものとする。また、上記以外の課題は、明細書等の記載から自ずと明らかになるものであり、明細書等の記載から上記以外の課題を抽出することが可能である。

【課題を解決するための手段】

【0013】

選択トランジスタ、駆動トランジスタ及び発光素子を含む画素において、駆動トランジスタとして、酸化物半導体膜にチャネルが形成され、そのチャネル長が $0.5\mu\text{m}$ 以上 $4.5\mu\text{m}$ 以下、好ましくは $1\mu\text{m}$ より大きく $4\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $1\mu\text{m}$ より大きく $3.5\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $1\mu\text{m}$ より大きく $2.5\mu\text{m}$ 以下であるトランジスタを適用する。また、該駆動トランジスタとして、酸化物半導体膜の上層及び下層にそれぞれ重なる第1のゲート電極及び第2のゲート電極を有し、各ゲート電極が互いに電氣的に接続している構成とする。これによって、駆動トランジスタの電界効果移動度及びオン電流を向上させることができ、高駆動周波数においても良好な表示を行うことが可能な表示装置とすることができる。また、駆動トランジスタほどの電界効果移動度が要求されない画素の選択トランジスタのチャネル長を、少なくとも駆動トランジスタのチャネル長よりも大きくすることで、画素の開口率を高めながら低消費電力化を達成することが可能となる。

【0014】

より具体的には、例えば以下の構成とすることができる。

【0015】

本発明の一態様は、発光素子と、発光素子の駆動トランジスタとして機能する第1のトランジスタと、第1のトランジスタと電氣的に接続し、選択トランジスタとして機能する第2のトランジスタと、を含む画素を有し、第1のトランジスタは、絶縁表面上の第1のゲート電極と、第1のゲート電極上の第1の絶縁膜と、第1の絶縁膜を介して第1のゲート電極と重なる第1の酸化物半導体膜と、第1の酸化物半導体膜と電氣的に接続し、第1の酸化物半導体膜上に端部を有する一対の電極と、第1の酸化物半導体膜上の第2の絶縁膜と、第2の絶縁膜を介して、第1の酸化物半導体膜上に設けられ、第1のゲート電極と重なる第2のゲート電極と、を有し、第2のゲート電極は、チャネル幅方向において第2の絶縁膜を介して第1の酸化物半導体膜の側面と対向する領域を有し、第2のトランジスタは、絶縁表面上の第3のゲート電極と、第3のゲート電極上の第1の絶縁膜と、第1の絶縁膜を介して第3のゲート電極と重なる第2の酸化物半導体膜と、第2の酸化物半導体膜と電氣的に接続し、第2の酸化物半導体膜上に端部を有する一対の電極と、を有し、第1のトランジスタの一対の電極の間隔は、 $0.5\mu\text{m}$ 以上 $4.5\mu\text{m}$ 以下であり、第2のトランジスタの一対の電極の間隔は、第1のトランジスタの一対の電極の間隔よりも広いことを特徴とする表示装置である。

【0016】

また、本発明の一態様は、発光素子と、発光素子の駆動トランジスタとして機能する第1のトランジスタと、第1のトランジスタと電氣的に接続し、選択トランジスタとして機能する第2のトランジスタと、を含む画素を有し、第1のトランジスタは、絶縁表面上の第1のゲート電極と、第1のゲート電極上の第1の絶縁膜と、第1の絶縁膜を介して第1のゲート電極と重なる第1の酸化物半導体膜と、第1の酸化物半導体膜と電氣的に接続し

10

20

30

40

50

、第1の酸化物半導体膜上に端部を有する一対の電極と、第1の酸化物半導体膜上の第2の絶縁膜と、第2の絶縁膜を介して、第1の酸化物半導体膜上に設けられ、第1のゲート電極と重なる第2のゲート電極と、を有し、第2のゲート電極は、チャネル幅方向において第2の絶縁膜を介して第1の酸化物半導体膜の側面と対向する領域を有し、第2のトランジスタは、絶縁表面上の第3のゲート電極と、第3のゲート電極上の第1の絶縁膜と、第1の絶縁膜を介して第3のゲート電極と重なる第2の酸化物半導体膜と、第2の酸化物半導体膜と電氣的に接続し、第2の酸化物半導体膜上に端部を有する一対の電極と、を有し、第1のトランジスタの一対の電極の間隔は、 $0.5\mu\text{m}$ 以上 $4.5\mu\text{m}$ 以下であり、第2のトランジスタの一対の電極の間隔は、第1のトランジスタの一対の電極の間隔よりも広く、且つ、第2のトランジスタのカットオフ電流の値は第1のトランジスタのカットオフ電流の値より小さいことを特徴とする表示装置である。

10

【0017】

また、上記の表示装置において、第2のトランジスタは、第2の絶縁膜を介して第2の酸化物半導体膜上に設けられ、第3のゲート電極と重なる第4のゲート電極を有し、第3のゲート電極及び第4のゲート電極は、互いに接する領域を有していてもよい。

【0018】

また、上記の表示装置において、第1のゲート電極と第2のゲート電極は、互いに接する領域を有することが好ましい。

【0019】

また、上記の表示装置において、第1の絶縁膜及び第2の絶縁膜の少なくとも一は、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜を有することが好ましい。

20

【発明の効果】

【0020】

本発明の一態様によって、酸化物半導体膜を含むトランジスタのしきい値電圧の変動による影響が低減された表示装置を提供することができる。

【0021】

また、本発明の一態様によって、信頼性の高い表示装置を提供することができる。

【0022】

また、本発明の一態様によって、良好な表示特性を有する表示装置を提供することができる。

30

【0023】

また、本発明の一態様によって、低消費電力化を達成した表示装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0024】

【図1】表示装置の一態様を示す概念図及び画素の一態様を示す回路図。

【図2】表示装置の一態様を示す平面図及び断面図。

【図3】表示装置の作製方法の一態様を説明する断面図。

【図4】表示装置の作製方法の一態様を説明する断面図。

40

【図5】表示装置の作製方法の一態様を説明する断面図。

【図6】表示装置の作製方法の一態様を説明する断面図。

【図7】表示装置の一態様を示す平面図及び断面図。

【図8】表示装置の一態様を示す平面図及び断面図。

【図9】表示装置の一態様を示す平面図、断面図及び回路図。

【図10】回路記号とトランジスタの構成を示す図。

【図11】表示装置の一態様を示す平面図及び断面図。

【図12】表示装置の一態様を示す平面図及び断面図。

【図13】表示装置の作製方法の一態様を説明する断面図。

【図14】表示装置の作製方法の一態様を説明する断面図。

50

- 【図 1 5】表示装置の作製方法の一態様を説明する断面図。
【図 1 6】表示装置の画素構成の一態様を説明する平面図。
【図 1 7】表示装置の画素構成の一態様を説明する断面図。
【図 1 8】表示装置の画素構成の一態様を説明する断面図。
【図 1 9】表示装置の一形態を説明する断面図。
【図 2 0】表示装置の一形態を説明する平面図及び断面図。
【図 2 1】表示装置の一形態を説明する断面図。
【図 2 2】トランジスタのバンド構造を説明する図。
【図 2 3】表示装置の画素構成の一態様を説明する回路図。
【図 2 4】表示装置を説明する上面図および断面図。
【図 2 5】電子機器の一例を説明する図。
【図 2 6】実施例に係る、トランジスタの $V_g - I_d$ 特性。
【図 2 7】実施例に係る、トランジスタの $V_g - I_d$ 特性。
【図 2 8】実施例に係る、トランジスタの $V_g - I_d$ 特性。
【図 2 9】計算に用いたトランジスタの構造と、計算により得られた電界効果移動度及びオン電流を説明する図。
【図 3 0】計算に用いたトランジスタのモデルを説明する図。
【図 3 1】計算によって得られた飽和移動度のチャネル長依存性を説明する図。
【図 3 2】計算によって得られたオン電流のチャネル長依存性を説明する図。
【図 3 3】計算によって得られたトランジスタの $V_g - I_d$ 特性及び酸化物半導体膜中の電流分布を説明する図。
【図 3 4】計算によって得られたトランジスタの $V_g - I_d$ 特性及びシリコン膜中の電流分布を説明する図。
【図 3 5】計算に用いた電子トラップ及び計算によって得られた飽和移動度のチャネル長依存性を説明する図。
【図 3 6】トランジスタのオフ状態及びオン状態におけるキャリアの流れを説明する図。
【発明を実施するための形態】

10

20

【0025】

以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれば容易に理解される。したがって、本発明は、以下に示す実施の形態及び実施例の記載内容に限定して解釈されるものではない。また、以下に説明する実施の形態及び実施例において、同一部分又は同様の機能を有する部分には同一の符号又は同一のハッチパターンを異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。

30

【0026】

なお、本明細書で説明する各図において、各構成の大きさ、膜の厚さ、又は領域は、明瞭化のために誇張されている場合がある。よって、必ずしもそのスケールに限定されない。

【0027】

また、本明細書にて用いる第 1、第 2 等の序数詞は、構成要素の混同を避けるために付したものであり、数的に限定するものではない。そのため、例えば、「第 1 の」を「第 2 の」又は「第 3 の」等と適宜置き換えて説明することができる。

40

【0028】

また、「ソース」や「ドレイン」の機能は、回路動作において電流の方向が変化する場合などには入れ替わることがある。このため、本明細書等においては、「ソース」や「ドレイン」の用語は、入れ替えて用いることができるものとする。

【0029】

また、電圧とは、2 点間における電位差のことをいい、電位とはある一点における静電場の中にある単位電荷が持つ静電エネルギー（電気的な位置エネルギー）のことをいう。

50

ただし、一般的に、ある一点における電位と基準となる電位（例えば接地電位）との電位差のことを、単に電位もしくは電圧と呼び、電位と電圧が同義語として用いられることが多い。このため、本明細書では特に指定する場合を除き、電位を電圧と読み替えてもよいし、電圧を電位と読み替えてもよいこととする。

【0030】

本明細書において、フォトリソグラフィ工程を行った後にエッチング工程を行う場合は、フォトリソグラフィ工程で形成したマスクは除去するものとする。

【0031】

（実施の形態1）

本実施の形態では、本発明の一態様の表示装置及びその作製方法について、図面を参照して説明する。

10

【0032】

<表示装置の構成例>

図1（A）に、表示装置の一例のブロック図を示す。図1（A）に示す表示装置は、画素部600と、走査線駆動回路604と、信号線駆動回路606と、各々が平行又は略平行に配置され、且つ走査線駆動回路604によって電位が制御されるm本の走査線607と、各々が平行又は略平行に配置され、且つ信号線駆動回路606によって電位が制御されるn本の信号線609と、を有する。さらに画素部600はマトリクス状に配置された複数の画素601を有する。また、走査線駆動回路604及び信号線駆動回路606をまとめて駆動回路部という場合がある。

20

【0033】

各走査線607は、画素部600においてm行n列に配置された画素601のうち、いずれかの行に配置されたn個の画素601と電氣的に接続される。また、各信号線609は、m行n列に配置された画素601のうち、いずれかの列に配置されたm個の画素601に電氣的に接続される。m、nはともに1以上の整数である。また、各容量線615は、m行n列に配置された画素601のうち、いずれかの行に配置されたn個の画素601と電氣的に接続される。なお、容量線615が、信号線609に沿って、各々が平行又は略平行に配置されている場合は、m行n列に配置された画素601のうち、いずれかの列に配置されたm個の画素601と電氣的に接続される。

【0034】

<画素の構成例>

図1（B）は、図1（A）に示す表示装置の画素601に用いることができる回路構成の一例を示している。

30

【0035】

図1（B）に示す画素601は、選択トランジスタとして機能するトランジスタ400bと、駆動トランジスタとして機能するトランジスタ400aと、容量素子370と、発光素子350と、を有する。

【0036】

トランジスタ400aのソース電極及びドレイン電極の一方は、発光素子350の一方の電極に電氣的に接続され、トランジスタ400aのソース電極及びドレイン電極の他方は、高電源電位が与えられるアノード線（図示せず）と電氣的に接続される。また、トランジスタ400aは、半導体膜を間に挟んで重なり合う一対のゲート電極を有しており、トランジスタ400aのゲート電極の一方は、トランジスタ400aのゲート電極の他方、トランジスタ400bのソース電極及びドレイン電極の一方、及び容量素子370の一方の電極に電氣的に接続される。トランジスタ400bのゲート電極は、走査線607に電氣的に接続され、トランジスタ400bのソース電極及びドレイン電極の他方は、信号線609に電氣的に接続される。また、容量素子370の他方の電極は、容量線615に電氣的に接続され、発光素子350の他方の電極は、低電源電位が与えられるカソード線（図示せず）に電氣的に接続される。

40

【0037】

50

トランジスタ400aは、オン状態又はオフ状態になることにより、発光素子350に流れる電流を制御する機能を有する。

【0038】

駆動トランジスタとして機能するトランジスタ400aは、発光素子350に十分な輝度を得るために、オン電流の高いトランジスタを適用することが求められる。また、表示装置の駆動周波数を向上させてより滑らかな動画表示を実現するために、電界効果移動度が高いトランジスタを適用することが求められる。

【0039】

そこで、本実施の形態の表示装置においては、トランジスタ400aとして、チャンネル長が0.5μm以上4.5μm以下、好ましくは1μmより大きく4μm以下、より好ましくは1μmより大きく3.5μm以下、より好ましくは1μmより大きく2.5μm以下であるトランジスタを適用する。トランジスタのオン電流は、チャンネル幅に対するチャンネル長の比(L/W比)が小さいほど増加するため、トランジスタ400aのチャンネル長を上述の範囲程度に縮小することで、オン電流を向上させることができる。または、チャンネル長を上述の範囲程度に縮小し、且つチャンネル幅も縮小することで、オン電流を一定に保ったままトランジスタサイズを小さくすることができ、画素の開口率を向上させることができる。

10

【0040】

また、トランジスタ400aは、チャンネルが形成される酸化物半導体膜と、酸化物半導体膜を間に挟んで重なり合う第1のゲート電極と第2のゲート電極を有する。また、トランジスタ400aに含まれる第1のゲート電極及び第2のゲート電極は電氣的に接続している。このように、酸化物半導体膜を挟んで一对のゲート電極を設け、且つ該一对のゲート電極を電氣的に接続させることで、一对のゲート電極の片方にだけ一定の電位を与える場合とは異なり、一对のゲート電極に同じ電位が与えられるので、チャンネル形成領域が増え、トランジスタ400aのドレイン電流の増加を実現することができる。よって、オン電流の低下を抑えつつトランジスタ400aのサイズを小さく抑えることができる。

20

【0041】

さらに、第1のゲート電極と第2のゲート電極とを接続するために、酸化物半導体膜のチャンネル幅方向の側面の少なくとも一方に重なるように第2のゲート電極が設けられる。これによって、酸化物半導体膜のチャンネル幅方向の側面にも電界が印加されることとなり、電流の流れる領域を拡大することが可能となる。したがって、トランジスタ400aの電界効果移動度を向上させることができる。

30

【0042】

また、電氣的に接続された一对のゲート電極を設けることで、酸化物半導体膜に空乏層ができやすくなるため、トランジスタ400aのサブスレッショルド特性を改善することができる。

【0043】

また、チャンネル長を短縮することで、トランジスタのしきい値電圧がマイナス方向に変動する場合がある。しかしながら、トランジスタ400aでは、第1のゲート電極に加えて、バックチャンネル領域側に第2のゲート電極(バックゲート電極)を設けることで、バックチャンネル領域にマイナスの電荷が生じるのを防ぎ、トランジスタのしきい値電圧がマイナス方向ヘシフトするのを抑えることができる。

40

【0044】

トランジスタ400bは、オン状態又はオフ状態となることにより、データ信号の書き込みを制御する機能を有する。

【0045】

トランジスタ400bとしては、しきい値電圧がプラスとなる電気特性(ノーマリーオフ特性ともいう。)を有するトランジスタを適用することが好ましい。また、カットオフ電流の低減されたトランジスタを適用することが好ましい。

【0046】

50

上述したように、トランジスタのチャネル長を小さくすることで、高いオン電流が得られる一方で、トランジスタのしきい値電圧がマイナス方向に変動（マイナスシフト）する場合がある。本実施の形態の表示装置では、高いオン電流、高い電界効果移動度が要求される駆動トランジスタとして機能するトランジスタ400aのチャネル長を $0.5\mu\text{m}$ 以上 $4.5\mu\text{m}$ 以下とし、且つ電氣的に接続された一対のゲート電極を設けることで、オン電流及び電界効果移動度を向上させつつ、しきい値電圧のマイナスシフトを抑制する。

【0047】

一方、選択トランジスタとして機能するトランジスタ400bは、トランジスタ400aほど高い電界効果移動度を要しないため、そのチャネル長をトランジスタ400aのチャネル長よりも大きくすることで、トランジスタ400bのしきい値電圧のマイナスシフトを抑制する。これによって、表示装置の高速動作及び低消費電力化を図ることが可能となる。

【0048】

例えば、トランジスタ400aのチャネル長を $0.5\mu\text{m}$ 以上 $4.5\mu\text{m}$ 以下とした場合には、トランジスタ400bのチャネル長を $6\mu\text{m}$ とすることができる。ただし、トランジスタ400bのチャネル長は、少なくともトランジスタ400aのチャネル長よりも大きければよく、表示装置に求められる特性によって適宜設定することができる。

【0049】

また、トランジスタ400bのカットオフ電流の値は、トランジスタ400aのカットオフ電流の値よりも小さいことが好ましい。例えば、トランジスタ400bのチャネル幅に対するチャネル長の比（ L/W 比）をトランジスタ400aの L/W 比よりも大きくすることにより、トランジスタ400bのカットオフ電流の値を、トランジスタ400aのカットオフ電流の値よりも小さくできる。また、トランジスタ400aとトランジスタ400bのチャネル幅が同等の場合には、トランジスタ400bのチャネル長をトランジスタ400aのチャネル長よりも大きくすることで、トランジスタ400bのカットオフ電流の値を低減することが可能となる。

【0050】

なお、トランジスタ400bを、トランジスタ400aと同様に、電氣的に接続された一対のゲート電極を有する構成としてもよい。ただし、トランジスタ400bを前述の構成とした場合、一対のゲート電極を接続するための領域が必要になり、結果として、トランジスタ400bの面積が大きくなり、画素の開口率が低下してしまう。そのため、トランジスタ400bはシングルゲート構造が好ましい。また、表示装置が大型化した場合、トランジスタ400bのゲート配線の寄生容量が表示装置の動作速度に影響を与えるようになる。そのため、トランジスタ400bは、ゲート配線の寄生容量が小さいシングルゲート構造が好ましい。

【0051】

発光素子350としては、例えば、有機エレクトロルミネセンス素子（有機EL素子）、又は無機EL素子を用いることができる。

【0052】

<トランジスタの回路記号>

ここで、本明細書で用いる、酸化物半導体膜を間に挟んで重なり合う一対のゲート電極を有するトランジスタの回路記号について、図10(A)に示す。図10(A)に示す回路記号では、一対のゲート電極をFG、BGで示し、ソース電極をS、ドレイン電極をDで示している。

【0053】

図10(B2)は、図10(B1)の回路記号で表すことのできるトランジスタ400aの断面図の一例を示している。図10(B2)に示すトランジスタ400aは、ソース電極またはドレイン電極として機能する一対の電極20a、20bが、酸化物半導体膜17a上において、ゲート電極31と部分的に重なっている。図10(B1)に示す回路記号では、図10(A)に示す回路記号と同様に、一対のゲート電極をFG、BGで示し、

10

20

30

40

50

ソース電極をS、ドレイン電極をDで示している。

【0054】

図10(B2)に示すトランジスタ400aは、チャネル長方向において、一对の電極20a、20bの端部の距離 Wsd が、ゲート電極31の端部間の距離 Wbg に比べて短い。そして、チャネル長方向における断面図では、ゲート電極31の一对の端部が、一对の電極20a、20bと重なっている。

【0055】

図10(C2)は、図10(C1)の回路記号で表すことのできるトランジスタ400aの断面図の一例を示している。図10(C2)に示すトランジスタ400aは、ソース電極またはドレイン電極として機能する一对の電極20a、20bが、酸化物半導体膜17a上において、ゲート電極31と重なっていない。図10(C1)に示す回路記号では、図10(A)に示す回路記号と同様に、一对のゲート電極をFG、BGで示し、ソース電極をS、ドレイン電極をDで示している。

【0056】

図10(C2)に示すトランジスタ400aは、チャネル長方向において、一对の電極20a、20bの距離 Wsd が、ゲート電極31の端部間の距離 Wbg に比べて長い。そして、チャネル長方向における断面図では、ゲート電極31の一对の端部が、一对の電極20a、20bと重なってない。

【0057】

本明細書に添付された図面では、図10(A)に示す回路記号が、図10(B1)の回路記号で表される構造のトランジスタ400aと、図10(C1)の回路記号で表される構造のトランジスタ400aとを、含むものとする。

【0058】

<画素に含まれるトランジスタの構成例>

次いで、表示装置の画素に含まれるトランジスタの具体的な構成について説明する。

【0059】

図2(A1)乃至図2(C2)に、表示装置の画素601に含まれるトランジスタ400a及びトランジスタ400bの上面図及び断面図を示す。図2(A1)は駆動トランジスタとしての機能を有するトランジスタ400aの上面図であり、図2(A2)は選択トランジスタとしての機能を有するトランジスタ400bの上面図であり、図2(B)は、図2(A1)の一点鎖線A1-B1間及び図2(A2)の一点鎖線A2-B2間の断面図であり、図2(C1)は、図2(A1)の一点鎖線C1-D1間の断面図であり、図2(C2)は、図2(A2)の一点鎖線C2-D2間の断面図である。なお、図2(A1)及び図2(A2)では、明瞭化のため、基板11及び絶縁膜15などを省略している。

【0060】

図2(A1)、図2(B)及び図2(C1)に示すトランジスタ400aは、チャネルエッチ型のトランジスタであり、基板11上に設けられるゲート電極13aと、基板11及びゲート電極13a上に形成される絶縁膜15と、絶縁膜15を介して、ゲート電極13aと重なる酸化物半導体膜17aと、酸化物半導体膜17aに接する一对の電極20a、20bとを有する。また、絶縁膜15、酸化物半導体膜17a、及び一对の電極20a、20b上に、酸化物絶縁膜23、酸化物絶縁膜25、及び窒化物絶縁膜27で構成される絶縁膜28と、絶縁膜28上に形成されるゲート電極31とを有する。ゲート電極31は、絶縁膜15及び絶縁膜28に設けられた開口部42、43においてゲート電極13aと接続する。また、一对の電極20a、20bの一方、ここでは電極20bに接続する電極32が、窒化物絶縁膜27上に形成される。なお、電極32は画素電極として機能する。

【0061】

図2(B)及び図2(C2)に示すトランジスタ400bは、チャネルエッチ型のトランジスタであり、基板11上に設けられるゲート電極13bと、基板11及びゲート電極13b上に形成される絶縁膜15と、絶縁膜15を介して、ゲート電極13bと重なる酸

10

20

30

40

50

化物半導体膜 17b と、酸化物半導体膜 17b に接する一対の電極 20c、20d とを有する。また、絶縁膜 15、酸化物半導体膜 17b、及び一対の電極 20c、20d 上に、酸化物絶縁膜 23、酸化物絶縁膜 25、及び窒化物絶縁膜 27 で構成される絶縁膜 28 と、を有する。

【0062】

トランジスタ 400a 及びトランジスタ 400b において、絶縁膜 15 は、ゲート絶縁膜（トランジスタ 400a においては第 1 のゲート絶縁膜）として機能する。また、絶縁膜 28 は、トランジスタ 400a の第 2 のゲート絶縁膜として機能し、トランジスタ 400b においては、保護絶縁膜として機能する。

【0063】

本実施の形態に示すトランジスタ 400a は、チャネル長が $0.5\mu\text{m}$ 以上 $4.5\mu\text{m}$ 以下、好ましくは $1\mu\text{m}$ より大きく $4\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $1\mu\text{m}$ より大きく $3.5\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $1\mu\text{m}$ より大きく $2.5\mu\text{m}$ 以下である。また、トランジスタ 400a は、チャネル幅方向において、ゲート電極 13a 及びゲート電極 31 の間に、絶縁膜 15 及び絶縁膜 28 を介して酸化物半導体膜 17a が設けられている。また、ゲート電極 31 は図 2 (A1) に示すように、上面から見て、絶縁膜 28 を介して酸化物半導体膜 17a の端部と重なる。

【0064】

トランジスタ 400a に含まれる酸化物半導体膜 17a は、チャネル長方向の側面が、一対の電極 20a、20b と重なり、チャネル幅方向の側面が、ゲート電極 31 と重なる構成を有する。酸化物半導体膜 17a の端部は、酸化物半導体膜 17a を島状に加工するためのエッチング処理でプラズマに曝される際に、エッチングガスから生じた塩素ラジカル、フッ素ラジカル等が、酸化物半導体を構成する金属元素と結合しやすい。よって、酸化物半導体膜 17a の端部では、当該金属元素と結合していた酸素が脱離しやすい状態にあるため、酸素欠損が形成され、n 型化しやすい場合がある。特に、酸化物半導体膜 17a の端部のうち、破線 33 及び破線 34 で囲まれた領域が n 型化すると、この領域を介して、一対の電極 20a、20b の間にリーク電流が流れやすい。しかしながら、トランジスタ 400a では、上述の領域がゲート電極 31 と重なるため、ゲート電極 31（ゲート電極 31 と同電位のゲート電極 13a を含む）の電位を制御することにより、当該領域に印加される電界を制御することができる。よって、酸化物半導体膜 17a の端部が n 型化されていたとしても、一対の電極 20a、20b 間に流れうるリーク電流を、一対のゲート電極に与える電位によって制御することができる。

【0065】

具体的に、トランジスタ 400a が非導通状態となるような電位を一対のゲート電極に与えたときには、破線 33 及び破線 34 で囲まれた酸化物半導体膜 17a の端部を介して一対の電極 20a、20b 間に流れるオフ電流を小さく抑えることができる。そのため、トランジスタ 400a では大きなオン電流を得るためにチャネル長を短くし、その結果、酸化物半導体膜 17a の端部における一対の電極 20a、20b 間の長さが短くなっても、オフ電流を小さく抑えることが可能となる。すなわち、トランジスタ 400a は、導通状態の場合には、大きなオン電流を得ることができ、非導通状態の場合には、オフ電流を小さく抑えることが可能なトランジスタである。

【0066】

また、本実施の形態に示すトランジスタ 400b のチャネル長は、トランジスタ 400a のチャネル長よりも大きい。これにより、シングルゲート構造であるトランジスタ 400b のしきい値電圧のマイナス方向への変動を抑制し、カットオフ電流の値を小さく抑えることができる。

【0067】

絶縁膜 15 及び絶縁膜 28 には複数の開口部を有する。代表的には、図 2 (B) に示すように、一対の電極 20a、20b の一方を露出する開口部 41 を有する。また、図 2 (C1) に示すように、チャネル幅方向において、酸化物半導体膜 17a を挟む開口部 42

10

20

30

40

50

、43を有する。即ち、酸化物半導体膜17aの側面の外側に開口部42、43を有する。開口部41において、一对の電極20a、20bの一方、ここでは電極20bと電極32が接続する。また、開口部42、43において、ゲート電極13a及びゲート電極31が接続する。即ち、チャネル幅方向において、ゲート電極13a及びゲート電極31は、絶縁膜15及び絶縁膜28を介して酸化物半導体膜17aを囲む。また、当該開口部42、43の側面において、ゲート電極31は酸化物半導体膜17aの側面と対向する。

【0068】

なお、図2(C1)に示すように、チャネル幅方向において、酸化物半導体膜17aの側面と開口部42、43におけるゲート電極31との距離dは、絶縁膜15の膜厚t1と絶縁膜28の膜厚t2を足し合わせた膜厚の1倍以上7.5倍以下とする。酸化物半導体膜17aの側面と開口部42、43におけるゲート電極31との距離dが、絶縁膜15の膜厚t1と絶縁膜28の膜厚t2を足し合わせた膜厚の1倍以上の場合、図2(D)の電気力線444で示すように、ゲート電極31の電界が酸化物半導体膜17aの側面、または側面及びその近傍を含む端部に影響するため、酸化物半導体膜17aの側面または端部における寄生チャネルの発生を抑制することができる。一方、酸化物半導体膜17aの側面と開口部42、43におけるゲート電極31との距離dが、絶縁膜15の膜厚t1と絶縁膜28の膜厚t2を足し合わせた膜厚の7.5倍以下の場合、トランジスタの面積をより小さくすることができる。

【0069】

トランジスタ400aに含まれる酸化物半導体膜17aと、トランジスタ400bに含まれる酸化物半導体膜17bは、同一の作製工程にて形成することが可能である。酸化物半導体膜17a及び酸化物半導体膜17bは、少なくともIn若しくはZnを含む金属酸化物で形成され、代表的には、In-Ga酸化物、In-Zn酸化物、In-M-Zn酸化物(MはAl、Ga、Y、Zr、La、Ce、またはNd)等で形成される。

【0070】

なお、酸化物半導体膜17a及び酸化物半導体膜17bがIn-M-Zn酸化物であるとき、ZnおよびOを除いてのInおよびMの原子数比率は、Inが25atôm%以上、Mが75atôm%未満、さらに好ましくはInが34atôm%以上、Mが66atôm%未満とする。

【0071】

酸化物半導体膜17a及び酸化物半導体膜17bは、エネルギーギャップが2eV以上、好ましくは2.5eV以上、より好ましくは3eV以上である。このように、エネルギーギャップの広い酸化物半導体を用いることで、トランジスタ400a及びトランジスタ400bのオフ電流を低減することができる。

【0072】

酸化物半導体膜17a及び酸化物半導体膜17bの厚さは、3nm以上200nm以下、好ましくは3nm以上100nm以下、さらに好ましくは3nm以上50nm以下とする。

【0073】

酸化物半導体膜17a及び酸化物半導体膜17bがIn-M-Zn酸化物(MはAl、Ga、Y、Zr、La、Ce、またはNd)の場合、In-M-Zn酸化物を成膜するために用いるスパッタリングターゲットの金属元素の原子数比は、In M、Zn Mを満たすことが好ましい。このようなスパッタリングターゲットの金属元素の原子数比として、In:M:Zn=1:1:1、In:M:Zn=1:1:1.2、In:M:Zn=3:1:2が好ましい。なお、成膜される酸化物半導体膜17a及び酸化物半導体膜17bの原子数比はそれぞれ、誤差として上記のスパッタリングターゲットに含まれる金属元素の原子数比のプラスマイナス40%の変動を含む。

【0074】

酸化物半導体膜17a及び酸化物半導体膜17bとしては、キャリア密度の低い酸化物半導体膜を用いる。例えば、酸化物半導体膜17a及び酸化物半導体膜17bは、キャリ

10

20

30

40

50

ア密度が 1×10^{17} 個 / cm^3 以下、好ましくは 1×10^{15} 個 / cm^3 以下、さらに好ましくは 1×10^{13} 個 / cm^3 以下、より好ましくは 1×10^{11} 個 / cm^3 以下の酸化物半導体膜を用いる。

【0075】

なお、これらに限られず、必要とするトランジスタの半導体特性及び電気特性（電界効果移動度、しきい値電圧等）に応じて各々の酸化物半導体膜に適切な組成のものを用いればよい。また、必要とするトランジスタの半導体特性を得るために、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b のキャリア密度や不純物濃度、欠陥密度、金属元素と酸素の原子数比、原子間距離、密度等を適切なものとするのが好ましい。

【0076】

なお、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b として、不純物濃度が低く、欠陥準位密度の低い酸化物半導体膜を用いることで、さらに優れた電気特性を有するトランジスタを作製することができ好ましい。なお、不純物としては、水素、窒素、アルカリ金属、またはアルカリ土類金属等が挙げられる。本明細書では、不純物濃度が低く、欠陥準位密度の低い（酸素欠損の少ない）ことを高純度真性または実質的に高純度真性とよぶ。高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体は、キャリア発生源が少ないため、キャリア密度を低くすることができる。従って、当該酸化物半導体膜にチャネル領域が形成されるトランジスタは、しきい値電圧がプラスとなる電気特性（ノーマリーオフ特性ともいう。）になりやすい。また、高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜は、欠陥準位密度が低いため、トラップ準位密度も低くなる場合がある。また、高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、オフ電流が著しく小さく、ソース電極とドレイン電極間の電圧（ドレイン電圧）が 1V から 10V の範囲において、オフ電流が、半導体パラメータアナライザの測定限界以下、すなわち 1×10^{-13} A 以下という特性を得ることができる。従って、当該酸化物半導体膜にチャネル領域が形成されるトランジスタは、電気特性の変動が小さく、信頼性が高い。なお、酸化物半導体膜のトラップ準位に捕獲された電荷は、消失するまでに要する時間が長く、あたかも固定電荷のように振る舞うことがある。そのため、トラップ準位密度の高い酸化物半導体膜にチャネル領域が形成されるトランジスタは、電気特性が不安定となる場合がある。

【0077】

酸化物半導体膜に含まれる水素は金属原子と結合する酸素と反応して水になり、水素と反応した酸素は金属原子から脱離して、格子（または酸素が脱離した部分）に酸素欠損を形成する。当該酸素欠損に水素が入ることで、キャリアである電子が生成される場合がある。また、水素の一部が金属原子と結合する酸素と結合することで、キャリアである電子を生成する場合がある。従って、水素が含まれている酸化物半導体を用いたトランジスタはノーマリーオン特性となりやすい。

【0078】

このため、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b は酸素欠損と共に、水素ができる限り低減されているのが好ましい。具体的には、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b において、二次イオン質量分析法（SIMS: Secondary Ion Mass Spectrometry）により得られる水素濃度を、 2×10^{20} atoms / cm^3 以下、好ましくは 5×10^{19} atoms / cm^3 以下、より好ましくは 1×10^{19} atoms / cm^3 以下、より好ましくは 5×10^{18} atoms / cm^3 以下、より好ましくは 1×10^{18} atoms / cm^3 以下、より好ましくは 5×10^{17} atoms / cm^3 以下、さらに好ましくは 1×10^{16} atoms / cm^3 以下とする。

【0079】

酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b において、第 14 族元素の一つであるシリコンや炭素が含まれると、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b において酸素欠損が増加し、n 型化してしまう。このため、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導

体膜 17b におけるシリコンや炭素の濃度（二次イオン質量分析法により得られる濃度）を、 $2 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、好ましくは $2 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$ 以下とする。

【0080】

また、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b において、二次イオン質量分析法により得られるアルカリ金属またはアルカリ土類金属の濃度を、 $1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、好ましくは $2 \times 10^{16} \text{ atoms/cm}^3$ 以下にする。アルカリ金属及びアルカリ土類金属は、酸化物半導体と結合するとキャリアを生成する場合があります、トランジスタのオフ電流が増大してしまうことがある。このため、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b のアルカリ金属またはアルカリ土類金属の濃度を低減することが好ましい。

10

【0081】

また、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b に窒素が含まれていると、キャリアである電子が生じ、キャリア密度が増加し、n 型化しやすい。この結果、窒素が含まれている酸化物半導体を用いたトランジスタはノーマリーオン特性となりやすい。従って、当該酸化物半導体膜において、窒素はできる限り低減されていることが好ましい、例えば、二次イオン質量分析法により得られる窒素濃度は、 $5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下にすることが好ましい。

【0082】

酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b に含まれる不純物濃度を上述の値まで低減することで、トランジスタ 400a、400b にしきい値電圧がプラスとなる電気特性（ノーマリーオフ特性ともいう。）を付与することが可能となる。

20

【0083】

また、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b は、例えば非単結晶構造でもよい。非単結晶構造は、例えば、後述する CAAC-OS (C Axis Aligned Crystalline Oxide Semiconductor)、多結晶構造、後述する微結晶構造、または非晶質構造を含む。非単結晶構造において、非晶質構造は最も欠陥準位密度が高く、CAAC-OS は最も欠陥準位密度が低い。

【0084】

なお、酸化物半導体膜 17a を CAAC-OS 膜で形成することで、チャネル長の小さい、代表的には $0.5 \mu\text{m}$ 以上 $4.5 \mu\text{m}$ 以下、好ましくは $1 \mu\text{m}$ より大きく $4 \mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $1 \mu\text{m}$ より大きく $3.5 \mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $1 \mu\text{m}$ より大きく $2.5 \mu\text{m}$ 以下とした場合であってもチャネルエッチ型のトランジスタを作製することが可能であるため、好ましい。

30

【0085】

なお、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b が、非晶質構造の領域、微結晶構造の領域、多結晶構造の領域、CAAC-OS の領域、単結晶構造の二種以上を有する混合膜であってもよい。混合膜は、例えば、非晶質構造の領域、微結晶構造の領域、多結晶構造の領域、CAAC-OS の領域、単結晶構造の領域のいずれか二種以上の領域を有する場合があります。また、混合膜は、例えば、非晶質構造の領域、微結晶構造の領域、多結晶構造の領域、CAAC-OS の領域、単結晶構造の領域のいずれか二種以上の領域の積層構造を有する場合があります。

40

【0086】

酸化物半導体膜を有するトランジスタは、蓄積型のトランジスタである。ここで、酸化物半導体膜を有するトランジスタのオフ状態及びオン状態におけるキャリアの流れについて、図 36 に示す模式図を用いて説明する。また、図 36 (A) 及び図 36 (B) は、チャネル長方向の断面図であり、図 36 (C) は、チャネル幅方向の断面図である。

【0087】

図 36 において、酸化物半導体膜を有するトランジスタは、ゲート電極 GE_1 と、ゲート電極 GE_1 上のゲート絶縁膜 GI_1 と、ゲート絶縁膜 GI_1 上の酸化物半導体

50

膜OSと、酸化物半導体膜OS上の電極S、Dと、酸化物半導体膜OS及び電極S、D上のゲート絶縁膜GI₂と、ゲート絶縁膜GI₂上のゲート電極GE₂とを有する。酸化物半導体膜OSは、チャンネル領域iと、電極S、Dに接する低抵抗領域n⁺とを有する。ゲート電極GE₁及びゲート電極GE₂は、図36(C)に示すように、接続されている。

【0088】

トランジスタがオフ状態の場合、図36(A)に示すように、ゲート電極GE₁、GE₂に負の電圧が印加されると、酸化物半導体膜OSのチャンネル領域iから電子が排斥され、チャンネル領域iは完全に空乏化する。この結果、トランジスタのオフ電流が極めて小さくなる。

10

【0089】

一方、オン状態の場合、図36(B)に示すように、電極Sと接する低抵抗領域n⁺から電極Dと接する低抵抗領域n⁺へかけて電子が蓄積され、矢印で示すように電流パスが形成される。図36(C)に示すように、ゲート電極GE₁及びゲート電極GE₂を同電位とし、且つ酸化物半導体膜OSの側面がゲート電極GE₂と対向することで、さらには、チャンネル幅方向において、ゲート電極GE₁及びゲート電極GE₂が、ゲート絶縁膜GI₁及びゲート絶縁膜GI₂を介して酸化物半導体膜OSを囲むことで、図36(B)に示すように、酸化物半導体膜OSにおいてキャリアが、ゲート絶縁膜GI₁、GI₂と酸化物半導体膜OSとの界面のみでなく、酸化物半導体膜OS中の広い範囲において流れるため、トランジスタにおけるキャリアの移動量が増加する。この結果、トランジスタのオン電流が大きくなると共に、電界効果移動度が高くなり、代表的には電界効果移動度が10 cm²/V・s以上、さらには20 cm²/V・s以上となる。なお、ここでの電界効果移動度は、酸化物半導体膜の物性値としての移動度の近似値ではなく、トランジスタの飽和領域における電界効果移動度である。なお、トランジスタのチャンネル長(L長ともいう。)を0.5 μm以上6.5 μm以下、好ましくは1 μmより大きく6 μm未満、より好ましくは1 μmより大きく4 μm以下、より好ましくは1 μmより大きく3.5 μm以下、より好ましくは1 μmより大きく2.5 μm以下とすることで、電界効果移動度の増加が顕著である。また、チャンネル長が0.5 μm以上6.5 μm以下のように小さいことで、チャンネル幅も小さくすることが可能である。このため、図36(C)に示すように、ゲート電極GE₁及びゲート電極GE₂の接続部となるための領域を設けても、トランジスタの面積を縮小することが可能である。

20

30

【0090】

図2(A1)、図2(B)、図2(C1)、及び図2(D)に示すトランジスタ400aでは、ゲート電極13a及びゲート電極31を有することで、それぞれが外部からの電界を遮蔽する機能を有するため、基板11及びゲート電極13aの間、ゲート電極31上に存在する固定電荷が酸化物半導体膜17aに影響しない。この結果、ストレス試験(例えば、ゲート電極にマイナスの電位を印加する-GBT(Gate Bias-Temperature)ストレス試験)の劣化が抑制されると共に、異なるドレイン電圧におけるオン電流の立ち上がり電圧の変動を抑制することができる。

【0091】

なお、BTストレス試験は加速試験の一種であり、長期間の使用によって起こるトランジスタの特性変化(即ち、経年変化)を、短時間で評価することができる。特に、BTストレス試験前後におけるトランジスタのしきい値電圧の変動量は、信頼性を調べるための重要な指標となる。BTストレス試験前後において、しきい値電圧の変動量が少ないほど、信頼性が高いトランジスタであるといえる。

40

【0092】

トランジスタのチャンネル長を微細化すると、しきい値電圧がマイナス方向にシフトする場合がある。しかしながら、本実施の形態の表示装置においては、画素の選択トランジスタとして機能するトランジスタ400bのチャンネル長を駆動トランジスタとして機能するトランジスタ400aよりも長くすることで、表示装置の高速動作と低消費電力化を図る

50

ことができる。

【0093】

また、酸化物半導体膜17a及び酸化物半導体膜17b上に設けられる絶縁膜28において、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜が含まれることが好ましい。化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜は、加熱により酸素の一部が脱離する。化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜は、表面温度が100 以上700 以下、または100 以上500 以下の範囲で行われるTDS (Thermal Desorption Spectroscopy) 分析にて、酸素原子に換算しての酸素の脱離量が $1.0 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以上、好ましくは $3.0 \times 10^{20} \text{ atoms/cm}^3$ 以上である酸化物絶縁膜である。

10

【0094】

絶縁膜28において、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜が含まれると、絶縁膜28に含まれる酸素の一部を酸化物半導体膜17a及び酸化物半導体膜17bに移動させ、該酸化物半導体膜に含まれる酸素欠損を低減することが可能である。

【0095】

酸化物半導体膜中に酸素欠損が含まれている酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、しきい値電圧がマイナス方向に変動しやすく、ノーマリーオン特性となりやすい。これは、酸化物半導体膜に含まれる酸素欠損に起因して電荷が生じ、酸化物半導体膜が低抵抗化するためである。トランジスタがノーマリーオン特性を有すると、動作時に動作不良が発生しやすくなる、または非動作時の消費電力が高くなるなどの、様々な問題が生じる。また、時間経過やストレス試験により、トランジスタの電気特性、代表的にはしきい値電圧の変動量が増大するという問題がある。

20

【0096】

しかしながら、本実施の形態に示すトランジスタ400a及びトランジスタ400bは、酸化物半導体膜17a、17b上に設けられる絶縁膜28に、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜が含まれることで、絶縁膜28に含まれる酸素を酸化物半導体膜17a、17bに移動させ、該酸化物半導体膜の酸素欠損を低減することが可能である。また、絶縁膜28は、エッチング雰囲気中に曝されていないため、欠陥が少ない。これらの結果、ノーマリーオフ特性を有するトランジスタとなる。また、時間経過やストレス試験において、トランジスタの電気特性、代表的には動作時間に対するしきい値電圧の変動量を低減することができる。さらには、ストレス試験を繰り返しても、しきい値電圧の変動を低減することができる。

30

【0097】

また、トランジスタ400a及びトランジスタ400bがチャネルエッチ型のトランジスタであることも、電気特性の向上に有効である。ここで、チャネルエッチ型のトランジスタとチャネル保護型のトランジスタとを比較する。例えば、酸化物半導体膜を挟んで2つのゲート電極を有するチャネル保護型のトランジスタは、第1のゲート電極上に第1のゲート絶縁膜が形成され、第1のゲート絶縁膜上に酸化物半導体膜が形成される。酸化物半導体膜上にチャネル保護膜が形成され、該チャネル保護膜上に酸化物半導体膜と接する一対の電極が形成される。さらに、チャネル保護膜及び一対の電極上に第2のゲート絶縁膜が形成され、第2のゲート絶縁膜上に第2のゲート電極が形成される。

40

【0098】

チャネル保護膜は、一対の電極を形成する際のエッチング工程において、プラズマに曝され、ダメージを受ける。このため、チャネル保護膜には欠陥が形成されやすい。この結果、酸化物半導体膜を流れるキャリアがチャネル保護膜の欠陥に捕獲されてしまい、トランジスタの電気特性が動作時間と共に変動し、信頼性が低い。しかしながら、本実施の形態に示すトランジスタ400a及びトランジスタ400bは、チャネルエッチ型であり、絶縁膜28において、酸化物半導体膜17a又は酸化物半導体膜17bと重なる領域は、

50

エッチングの雰囲気には曝されない。このため、絶縁膜 28 の欠陥が少なく、信頼性の高いトランジスタである。

【0099】

また、チャネル保護型のトランジスタにおいて、酸化物半導体膜において一対の電極と重なる領域では、一対の電極が第2のゲート電極の電界を遮蔽してしまい、第2のゲート電極の電界が酸化物半導体膜に均一に影響しない。この結果、第2のゲート電極の電界により誘起されて酸化物半導体膜を流れるキャリア量が減少してしまう。しかしながら、本実施の形態に示すトランジスタ400aは、チャネルエッチ型のトランジスタであり、ゲート電極31の電界が、酸化物半導体膜17aのバックチャネルに均一に影響する。さらには、酸化物半導体膜17aの側面においてもゲート電極31の電界の影響を受ける。これらの結果、酸化物半導体膜17aの広い範囲においてキャリアが流れるため、トランジスタの電界効果移動度が上昇すると共に、オン電流が増大する。

10

【0100】

また、チャネル保護型のトランジスタは、酸化物半導体膜と一対の電極それぞれとを接続させるため、一対の電極それぞれの一方の端部をチャネル保護膜上に位置させる。また、一対の電極それぞれの一方の端部は、酸化物半導体膜と一対の電極それぞれとの接続領域よりも内側に位置する。これらのため、フォトリソの位置ずれを考慮すると、酸化物半導体膜と一対の電極それぞれの接続領域の間隔を広く設計する必要がある。一方、チャネルエッチ型のトランジスタは、酸化物半導体膜に一対の電極それぞれの一方の端部が直接接続するため、チャネルエッチ型のトランジスタは、チャネル保護型のトランジスタと比較して、一対の電極間の距離を小さくすることが容易である。特に本発明の一態様の表示装置で画素の駆動トランジスタとして機能するトランジスタ400aはチャネル長の短いトランジスタであるため、チャネルエッチ型とすることで、表示装置を歩留りよく作製することが可能となる。

20

【0101】

さらには、トランジスタ400a及びトランジスタ400bの双方がチャネルエッチ型であり、トランジスタ400bとトランジスタ400aの構成の相違点は、チャネル長の長さ及びトランジスタ400aがバックゲート電極として機能するゲート電極31の有する点である。したがって、トランジスタ400a及びトランジスタ400bを同一の工程で作製することが可能である。よって、表示装置の作製工程の簡略化を図ることが可能となる。

30

【0102】

<トランジスタの構成要素の詳細>

以下に、トランジスタ400a、トランジスタ400bの構成の詳細について説明する。

【0103】

基板11の材質などに大きな制限はないが、少なくとも、後の熱処理に耐えうる程度の耐熱性を有している必要がある。例えば、ガラス基板、セラミック基板、石英基板、サファイア基板等を、基板11として用いてもよい。また、シリコンや炭化シリコンなどの単結晶半導体基板、多結晶半導体基板、シリコンゲルマニウム等の化合物半導体基板、SOI基板等を適用することも可能であり、これらの基板上に半導体素子が設けられたものを、基板11として用いてもよい。なお、基板11として、ガラス基板を用いる場合、第6世代(1500mm×1850mm)、第7世代(1870mm×2200mm)、第8世代(2200mm×2400mm)、第9世代(2400mm×2800mm)、第10世代(2950mm×3400mm)等の大面積基板を用いることで、大型の表示装置を作製することができる。

40

【0104】

また、基板11として、可撓性基板を用い、可撓性基板上に直接、トランジスタ400a、トランジスタ400bを形成してもよい。または、基板11とトランジスタ400a、トランジスタ400bの間に剥離層を設けてもよい。剥離層は、その上に半導体装置を

50

一部あるいは全部完成させた後、基板 1 1 より分離し、他の基板に転載するのに用いることができる。その際、トランジスタ 4 0 0 a、トランジスタ 4 0 0 b は耐熱性の劣る基板や可撓性の基板にも転載できる。

【 0 1 0 5 】

ゲート電極 1 3 a、1 3 b は、アルミニウム、クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンから選ばれた金属元素、または上述した金属元素を成分とする合金か、上述した金属元素を組み合わせた合金等を用いて形成することができる。また、マンガン、ジルコニウムのいずれか一または複数から選択された金属元素を用いてもよい。また、ゲート電極 1 3 a、1 3 b は、単層構造でも、二層以上の積層構造としてもよい。例えば、シリコンを含むアルミニウム膜の単層構造、チタン膜上にアルミニウム膜を積層する二層構造、窒化チタン膜上にチタン膜を積層する二層構造、窒化チタン膜上にタングステン膜を積層する二層構造、窒化タンタル膜または窒化タングステン膜上にタングステン膜を積層する二層構造、チタン膜上に銅膜を積層する二層構造、チタン膜と、そのチタン膜上にアルミニウム膜を積層し、さらにその上にチタン膜を形成する三層構造等がある。また、アルミニウムに、チタン、タンタル、タングステン、モリブデン、クロム、ネオジム、スカンジウムから選ばれた元素の膜、または複数組み合わせた合金膜、もしくは窒化膜を用いてもよい。

10

【 0 1 0 6 】

また、ゲート電極 1 3 a、1 3 b は、インジウム錫酸化物 (ITO)、酸化タングステンを含むインジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化シリコンを添加したインジウム錫酸化物等の透光性を有する導電性材料を適用することもできる。また、上記透光性を有する導電性材料と、上記金属元素の積層構造とすることもできる。

20

【 0 1 0 7 】

絶縁膜 1 5 は、例えば酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化ガリウムまたは Ga - Zn 系金属酸化物、窒化シリコンなどを用いればよく、積層または単層で設ける。

【 0 1 0 8 】

また、絶縁膜 1 5 として、ハフニウムシリケート (HfSiO_x)、窒素が添加されたハフニウムシリケート ($\text{HfSi}_x\text{O}_y\text{N}_z$)、窒素が添加されたハフニウムアルミネート ($\text{HfAl}_x\text{O}_y\text{N}_z$)、酸化ハフニウム、酸化イットリウムなどの high - k 材料を用いることでトランジスタのゲートリークを低減できる。

30

【 0 1 0 9 】

絶縁膜 1 5 の厚さは、5 nm 以上 4 0 0 nm 以下、より好ましくは 1 0 nm 以上 3 0 0 nm 以下、より好ましくは 5 0 nm 以上 2 5 0 nm 以下とするとよい。

【 0 1 1 0 】

一対の電極 2 0 a、2 0 b 及び一対の電極 2 0 c、2 0 d は、アルミニウム、チタン、クロム、ニッケル、銅、イットリウム、ジルコニウム、モリブデン、銀、タンタル、またはタングステンからなる単体金属、またはこれを主成分とする合金を単層構造または積層構造として用いる。例えば、シリコンを含むアルミニウム膜の単層構造、チタン膜上にアルミニウム膜を積層する二層構造、タングステン膜上にアルミニウム膜を積層する二層構造、銅 - マグネシウム - アルミニウム合金膜上に銅膜を積層する二層構造、チタン膜上に銅膜を積層する二層構造、タングステン膜上に銅膜を積層する二層構造、チタン膜または窒化チタン膜と、そのチタン膜または窒化チタン膜上に重ねてアルミニウム膜または銅膜を積層し、さらにその上にチタン膜または窒化チタン膜を形成する三層構造、モリブデン膜または窒化モリブデン膜と、そのモリブデン膜または窒化モリブデン膜上に重ねてアルミニウム膜または銅膜を積層し、さらにその上にモリブデン膜または窒化モリブデン膜を形成する三層構造等がある。なお、酸化インジウム、酸化錫または酸化亜鉛を含む透明導電材料を用いてもよい。

40

50

【0111】

絶縁膜28は、酸化物半導体膜17a、17bに接する酸化物絶縁膜23、酸化物絶縁膜23に接する酸化物絶縁膜25、酸化物絶縁膜25に接する窒化物絶縁膜27を有する。絶縁膜28は、少なくとも、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜を有することが好ましい。ここでは、酸化物絶縁膜23として、酸素を透過する酸化物絶縁膜を形成し、酸化物絶縁膜25として、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜を形成し、窒化物絶縁膜27として、水素及び酸素をブロックする窒化物絶縁膜を形成する。なお、ここでは、絶縁膜28を3層構造としたが、適宜1層、2層、または4層以上とすることができる。なお、これらの場合、少なくとも、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜を有することが好ましい。

10

【0112】

酸化物絶縁膜23は、酸素を透過する酸化物絶縁膜である。このため、酸化物絶縁膜23上に設けられる、酸化物絶縁膜25から脱離する酸素を、酸化物絶縁膜23を介して酸化物半導体膜17a、17bに移動させることができる。また、酸化物絶縁膜23は、後に形成する酸化物絶縁膜25を形成する際の、酸化物半導体膜17a、17bへのダメージ緩和膜としても機能する。

【0113】

酸化物絶縁膜23としては、厚さが5nm以上150nm以下、好ましくは5nm以上50nm以下の酸化シリコン、酸化窒化シリコン等を用いることができる。なお、本明細書中において、酸化窒化シリコン膜とは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多い膜を指し、窒化酸化シリコン膜とは、その組成として、酸素よりも窒素の含有量が多い膜を指す。

20

【0114】

また、酸化物絶縁膜23は、欠陥量が少ないことが好ましく、代表的には、ESR(Electron Spin Resonance)測定により、シリコンのダングリングボンドに由来する $g = 2.001$ に現れる信号のスピン密度が $3 \times 10^{17} \text{ spins/cm}^3$ 以下であることが好ましい。これは、酸化物絶縁膜23に含まれる欠陥密度が多いと、当該欠陥に酸素が結合してしまい、酸化物絶縁膜23における酸素の透過量が減少してしまうためである。

30

【0115】

また、酸化物絶縁膜23と酸化物半導体膜17a、17bとの界面における欠陥量が少ないことが好ましく、代表的には、ESR測定により、酸化物半導体膜17a、17bの欠陥に由来する $g = 1.93$ に現れる信号のスピン密度が $1 \times 10^{17} \text{ spins/cm}^3$ 以下、さらには検出下限以下であることが好ましい。

【0116】

なお、酸化物絶縁膜23においては、外部から酸化物絶縁膜23に入った酸素が全て酸化物絶縁膜23の外部に移動する場合がある。または、外部から酸化物絶縁膜23に入った酸素の一部が、酸化物絶縁膜23にとどまる場合もある。また、外部から酸化物絶縁膜23に酸素が入ると共に、酸化物絶縁膜23に含まれる酸素が酸化物絶縁膜23の外部へ移動することで、酸化物絶縁膜23において酸素の移動が生じる場合もある。

40

【0117】

酸化物絶縁膜23に接するように酸化物絶縁膜25が形成されている。酸化物絶縁膜25は、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜を用いて形成する。化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜は、加熱により酸素の一部が脱離する。化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜は、表面温度が100以上700以下、または100以上500以下の範囲で行われるTDS分析にて、酸素原子に換算しての酸素の脱離量が $1.0 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以上、好ましくは $3.0 \times 10^{20} \text{ atoms/cm}^3$ 以上である酸化物絶縁膜である。

50

【0118】

酸化物絶縁膜25としては、厚さが30nm以上500nm以下、好ましくは50nm以上400nm以下の、酸化シリコン、酸化窒化シリコン等を用いることができる。

【0119】

また、酸化物絶縁膜25は、欠陥量が少ないことが好ましく、代表的には、ESR測定により、シリコンのダングリングボンドに由来する $g = 2.001$ に現れる信号のスピン密度が $1.5 \times 10^{18} \text{ spins/cm}^3$ 未満、更には $1 \times 10^{18} \text{ spins/cm}^3$ 以下であることが好ましい。なお、酸化物絶縁膜25は、酸化物絶縁膜23と比較して酸化物半導体膜17a、17bから離れているため、酸化物絶縁膜23より、欠陥密度が多くともよい。

10

【0120】

窒化物絶縁膜27は、少なくとも、水素及び酸素のブロッキング効果を有する。さらに、好ましくは、酸素、水素、水、アルカリ金属、アルカリ土類金属等のブロッキング効果を有する。絶縁膜28に窒化物絶縁膜27を設けることで、酸化物半導体膜17a、17bからの酸素の外部への拡散と、外部から酸化物半導体膜17a、17bへの水素、水等の侵入を防ぐことができる。

【0121】

窒化物絶縁膜27としては、厚さが50nm以上300nm以下、好ましくは100nm以上200nm以下の、窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム等がある。

20

【0122】

なお、窒化物絶縁膜27の代わりに、酸素、水素、水等のブロッキング効果を有する酸化物絶縁膜を設けてもよい。酸素、水素、水等のブロッキング効果を有する酸化物絶縁膜としては、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、酸化ガリウム、酸化窒化ガリウム、酸化イットリウム、酸化窒化イットリウム、酸化ハフニウム、酸化窒化ハフニウム等がある。

【0123】

トランジスタ400aにおいて、ゲート電極31及び電極32は、透光性を有する導電膜を用いる。透光性を有する導電膜は、インジウム錫酸化物（以下、ITOともいう。）
、インジウム亜鉛酸化物、酸化タングステンを含むインジウム酸化物、酸化タングステン
を含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸化チタンを含むイン
ジウム錫酸化物、酸化ケイ素を含むインジウム錫酸化物等がある。

30

【0124】

<Dual Gate駆動による電流駆動力の向上について>

本実施の形態の表示装置では、高いオン電流及び高い電界効果移動度が望まれる画素の
駆動トランジスタとして機能するトランジスタ400aとして、チャネルが形成される酸
化物半導体膜17aの上層及び下層にそれぞれ重なるゲート電極13a及びゲート電極3
1を有し、各ゲート電極が互いに電氣的に接続している、すなわちデュアルゲート駆動
(Dual Gate駆動)を行うトランジスタを用い、且つそのチャネル長を $0.5 \mu\text{m}$
以上 $4.5 \mu\text{m}$ 以下と微細化している。以下では、酸化物半導体膜を挟んで対向するゲ
ート電極が接続し、両電極が同電位であるDual Gate駆動のトランジスタにおいて
、チャネル長Lを小さくすることにより、電流駆動力が向上することについて説明する。

40

【0125】

<<理想的なモデルにおける飽和移動度について>>

はじめに、界面準位や界面散乱などの効果を考慮しない、理想的なモデルについてシ
ミュレーションで検討を行った。図30に、計算で用いたトランジスタのモデルを示す。な
お、計算にはデバイスシミュレーションソフトAtlas(Silvaco社製)を用
いた。

【0126】

図30に示すトランジスタは、ゲート電極GE__1上にゲート絶縁膜GI__1が形成さ

50

れ、ゲート絶縁膜 G I _ 1 上に酸化物半導体膜 O S が形成される。ゲート絶縁膜 G I _ 1 及び酸化物半導体膜 O S 上にソース電極 S 及びドレイン電極 D が形成される。酸化物半導体膜 O S 、ソース電極 S 及びドレイン電極 D 上にゲート絶縁膜 G I _ 2 が形成される。ゲート絶縁膜 G I _ 2 上にゲート電極 G E _ 2 が形成される。また、ゲート電極 G E _ 1 及びゲート電極 G E _ 2 は、ゲート絶縁膜 G I _ 1 及びゲート絶縁膜 G I _ 2 に形成される開口部（図示しない。）において、接続する。

【 0 1 2 7 】

計算に用いた条件を表 1 に示す。

【 0 1 2 8 】

【表 1】

チャネル長(条件振り)	2, 3, 6, 10 μm
チャネル幅	50 μm
GI_1の厚さT1	450nm
GI_2の厚さT2	450nm
GI_1、GI_2の誘電率Er	3.9
OSの厚さ	35nm
OSの移動度	10cm ² /V sec
GI_1、GI_2の誘電率Er	15
SD直下におけるOSのドナー密度	1 × 10 ¹⁹ / cm ³
チャネル領域におけるOSのドナー密度	6.6 × 10 ⁻⁹ / cm ³
ドレイン電圧	1V, 10V

【 0 1 2 9 】

ゲート電極 G E _ 1 及びゲート電極 G E _ 2 は接続されているため、常に等電位である。また、当該モデルは二次元シミュレーションを用いているため、チャネル幅方向の効果については考慮されない。また、ドレイン電圧 (V d) が 1 0 V のときの V g - I d 特性の値を数式 1 に代入することによって飽和移動度 μ_{FE} を算出した。なお、ここでは、飽和領域の電界効果移動度を飽和移動度として説明する。なお、計算によって得られる飽和移動度の最大値は、飽和領域 (ゲート電圧 (V g) < ドレイン電圧 (V d) + しきい値電圧 (V t h)) における電流駆動力の指標であって、酸化物半導体膜の物性値としての移動度の近似値とは異なる。

【 0 1 3 0 】

【数 1】

$$\mu_{FE} = \left(\frac{\partial \sqrt{I_d}}{\partial V_g} \right)^2 \frac{2L}{C_{Bottom} W} \quad (1)$$

【 0 1 3 1 】

なお、数式 1 において、W はトランジスタのチャネル幅であり、C_{Bottom} は、ゲート電極 G E _ 1 及び酸化物半導体膜 O S の間の単位面積当たりの容量値である。

【 0 1 3 2 】

Dual Gate 駆動のトランジスタの計算結果を図 3 1 (A) に示し、ゲート電極 G E _ 2 を有さない Single Gate 駆動のトランジスタの計算結果を図 3 1 (B) に示す。

【 0 1 3 3 】

図 3 1 より、Dual Gate 駆動のトランジスタ、及び Single Gate 駆動のトランジスタそれぞれにおいて、鋭いピークを有する飽和移動度が得られた。また、 L 長が短いほど飽和移動度のピーク値が高くなっている。

【 0 1 3 4 】

ここで、チャンネル長 L が短くなるにつれ飽和移動度が向上しているが、これがトランジスタの電流駆動力の向上に相当するかについて、以下に説明する。

【 0 1 3 5 】

理想的なモデルのシミュレーションから得られた結果において、ゲート電圧が $V_g = V_{th} + 5V$ のときと $V_g = V_{th} + 10V$ のときにおける、オン電流を L 長に対してプロットしたグラフを図 3 2 に示す。図 3 2 の上段は、オン電流を示し、図 3 2 の下段は、オン電流 \times チャンネル長を示す。なお、図 3 2 において、左欄はドレイン電圧 (V_d) が $1V$ のときの計算結果であり、右欄はドレイン電圧 (V_d) が $10V$ のときの計算結果である。

10

【 0 1 3 6 】

図 3 2 に示すオン電流は、チャンネル長 (L) に反比例している。これは、オン電流はチャンネル長 (L) に反比例するためである。

【 0 1 3 7 】

また、オン電流が完全にチャンネル長に反比例するのであれば、オン電流 \times チャンネル長の値は、チャンネル長に依存せず一定値となる。図 3 2 において、ドレイン電圧 (V_d) が $1V$ の場合は、オン電流 \times チャンネル長の値は、チャンネル長 (L) に対して略一定値となっている。一方、ドレイン電圧 (V_d) が $10V$ の場合は、チャンネル長 (L) が短くなるにつれ、オン電流 \times チャンネル長の値が増加している。これは、ドレイン電圧 (V_d) が $10V$ の場合は、実効チャンネル長 (後述において説明する) が、図 3 0 において定められるチャンネル長 (ソース電極 S とドレイン電極 D の間の距離) よりも短くなっていることを表している。

20

【 0 1 3 8 】

< バルク電流の理論 >

以下、理想的なモデルのトランジスタの飽和移動度において、低いゲート電圧でピークが生じる原因について説明する。

【 0 1 3 9 】

図 3 0 に示すトランジスタにおいて、酸化物半導体膜 OS に含まれる電子密度は、酸化物半導体膜 OS の膜厚方向に一定の値 $n_0(y)$ で表されると仮定する。 y は酸化物半導体膜 OS 内のチャンネル長方向の任意の位置を表している。酸化物半導体膜 OS の膜厚方向におけるポテンシャルは数式 2 に示され、一定となる。ただし、ゲート電極 GE_1 のゲート電圧 V_{g_1} 及びゲート電極 GE_2 のゲート電圧 V_{g_2} が同電位であり、ゲート電極 GE_1 側及びゲート電極 GE_2 側におけるフラットバンド電圧を共に、フラットバンド電圧 V_{FB} と仮定する。

30

【 0 1 4 0 】

【 数 2 】

40

$$\phi - V(y) = V_g - V_{FB} - V(y) \quad (2)$$

【 0 1 4 1 】

このとき、蓄積型である酸化物半導体膜を有するトランジスタにおいて、ドレイン電流 I_d は、数式 3 に示すようなバルク電流 I_{bulk} のみで近似的に与えられる。

【 0 1 4 2 】

【数 3】

$$I_d \cong I_{bulk} = \frac{Wt}{L_{eff}} \mu k_B T [n_0(0) - n_0(L_{eff})] \quad (3)$$

【0143】

なお、数式 3 において、 t は酸化物半導体膜の膜厚、 μ は酸化物半導体膜の電子移動度、 k_B はボルツマン定数、 T は絶対温度、 L_{eff} は実効チャネル長である。なお、ここでは、チャネル長はソース電極及びドレイン電極の間隔のことであり、実効チャネル長とは酸化物半導体膜において、ソース電極下から広がる n 領域と、ドレイン電極下から広がる n 領域の間の距離を表す。特に、チャネル長が短い場合あるいはドレイン電圧が高い場合、実効チャネル長はチャネル長よりも短くなる。

10

【0144】

なお、 $n_0(0)$ は、上述の実効チャネル長で定められる領域のソース電極側端部における電子密度であり、数式 4 で表させる。また、 $n_0(L_{eff})$ は、上述の実効チャネル長で定められる領域のドレイン電極側端部における電子密度であり、数式 5 で表される。なお、数式 4 及び数式 5 において、 N_D は酸化物半導体膜のチャネル領域のドナー密度であり、 q は素電荷である。

【0145】

【数 4】

20

$$n_0(0) = N_D e^{q\phi/k_B T} = N_D e^{q(V_g - V_{FB})/k_B T} \quad (4)$$

【0146】

【数 5】

$$n_0(L_{eff}) = N_D e^{q(\phi - V_d)/k_B T} = N_D e^{q(V_g - V_{FB} - V_d)/k_B T} \quad (5)$$

30

【0147】

$V_d > V_g - V_{th}$ 、且つ $V_g > V_{th}$ の飽和領域の場合、ドレイン電圧 V_d は $V_g - V_{th}$ に置き換えられるので、数式 3 は数式 6 となる。

【0148】

【数 6】

$$I_d = \frac{Wt}{L_{eff}} \mu k_B T N_D e^{-qV_{FB}/k_B T} (e^{qV_g/k_B T} - e^{qV_{th}/k_B T}) \quad (6)$$

40

【0149】

数式 6 で得られるドレイン電流 I_d に対して、飽和移動度 μ_{FE}^{sat} を計算すると数式 7 となる。

【0150】

【数 7】

$$\mu_{FE}^{sat} \equiv \left(\frac{d\sqrt{I_d}}{dV_g} \right)^2 \frac{2L}{C_{GI}W} = \frac{Lt\mu q^2 N_D e^{-qV_{FB}/k_B T}}{2L_{eff} C_{GI} k_B T} \frac{e^{qV_g/k_B T}}{1 - e^{q(V_g - V_{th})/k_B T}} \quad (7)$$

50

【 0 1 5 1 】

数式 7 において、 V_g を V_{th} とすると、分母が 0 になり、飽和移動度 μ_{FE}^{sat} は無限大に発散する。この性質が、図 3 1 に示されるような飽和移動度における、低いゲート電圧 V_g でのピークの原因である。すなわち、酸化物半導体膜 OS の内部を流れるバルク電流がドレイン電流の主要因であればあるほど、図 3 1 のチャネル長が $2\ \mu m$ のときの飽和移動度のように、よりはっきりとしたピークが表れる。

【 0 1 5 2 】

また、飽和移動度が大きくなる他の要因の一つとして、実効チャネル長 L_{eff} がチャネル長 L に比べて短くなることが考えられる。例えば、酸化物半導体膜 OS において、ソース電極 S 及びドレイン電極 D と接する領域近傍において、 n 領域が広がることにより、実効チャネル長 L_{eff} がチャネル長 L より短くなる。この影響は、数式 7 に示す飽和移動度 μ_{FE}^{sat} の L / L_{eff} に対する比例関係からも明らかである。

10

【 0 1 5 3 】

< < 酸化物半導体膜中の電流密度 > >

バルク電流が飽和移動度に影響することは、蓄積型のデバイスである酸化物半導体膜を有するトランジスタに特有の現象であり、半導体膜としてシリコン膜を有するトランジスタのような、反転型のデバイスではバルク電流の影響が少ない。

【 0 1 5 4 】

次に、デバイスシミュレーションによって得られた電流密度分布をプロットしたグラフを図 3 3 (B) 及び図 3 3 (C) に示す。図 3 3 (A) は、ドレイン電圧を $10\ V$ として計算で得られた $V_g - I_d$ 特性を示し、図 3 3 (B) 及び図 3 3 (C) は、図 3 0 に示す酸化物半導体膜の A 1 - A 2 の断面方向の電流密度分布を示す。図 3 3 (B) は飽和領域 ($V_g = 0.5\ V$)、図 3 3 (C) は線形領域 ($V_g = 1.5\ V$) における電流密度分布を示す。なお、計算に用いたトランジスタのチャネル長 L / チャネル幅 W は $2\ \mu m / 50\ \mu m$ であり、ドレイン電圧 V_d を $10\ V$ とした。

20

【 0 1 5 5 】

図 3 3 (B) より、飽和領域 (低いゲート電圧 V_g) では、酸化物半導体膜 OS 中にほぼ一様に電流密度が分布している。一方で、図 3 3 (C) に示すように、線形領域 (高いゲート電圧 V_g) では、酸化物半導体膜 OS の表面付近を流れる電流が支配的になっている。図 3 3 (B) に示すように飽和領域では、酸化物半導体膜 OS 中において電流密度がほぼ一様に分布していることから、飽和移動度にピークが生じている原因の一つは、バルク電流であることが分かる。

30

【 0 1 5 6 】

一方、デバイスシミュレーションによって得られた反転型デバイスの半導体膜の電流密度分布を図 3 4 (B) 及び図 3 4 (C) に示す。図 3 4 は、図 3 0 に示すトランジスタの酸化物半導体膜 OS を、 $n - p - n$ 接合を含む半導体膜 (シリコン) に置き換えた場合の計算結果である。半導体膜のチャネル領域には、 $1 \times 10^{17} / cm^3$ の密度をもつアクセプター型不純物を仮定した。

【 0 1 5 7 】

図 3 4 (A) は、ドレイン電圧を $10\ V$ として計算で得られた $V_g - I_d$ 特性を示し、図 3 4 (B) 及び図 3 4 (C) は、図 3 0 に示す半導体膜の A 1 - A 2 の断面方向の電流密度分布を示す。図 3 4 (B) は飽和領域 ($V_g = 0.5\ V$)、図 3 4 (C) は線形領域 ($V_g = 1.5\ V$) における電流密度分布である。なお、計算に用いたトランジスタのチャネル長 L / チャネル幅 W は $2\ \mu m / 50\ \mu m$ であり、ドレイン電圧 V_d を $10\ V$ とした。

40

【 0 1 5 8 】

蓄積型デバイスである酸化物半導体膜を有するトランジスタと異なり、反転型デバイスである半導体膜を有するトランジスタは、図 3 4 (B) に示すように、しきい値電圧近傍においても、半導体膜の表面を流れる電流が多くなっており、バルク電流の寄与は蓄積型デバイスと比べると小さい。

【 0 1 5 9 】

50

以上のことから、蓄積型デバイスである酸化物半導体膜を有するトランジスタにおいて、理想的なモデルでは、バルク電流によって飽和移動度に鋭いピークが生じることが分かる。また、バルク電流によって、チャンネル長 L が短くなるほど飽和移動度が向上している。

【0160】

なお、チャンネル長 L が短くなるほど、バルク電流によって生じた飽和移動度のピーク値が高くなる原因として、酸化物半導体膜OSにおいて、ソース電極S及びドレイン電極Dと接する領域近傍において、 n 領域が広がることにより、実効チャンネル長 L_{eff} がチャンネル長 L より短くなることが考えられる。また、チャンネル長 L が小さいと、ソース電極S及びドレイン電極Dの影響で酸化物半導体膜OSの伝導帯下端のエネルギー(E_c)が低くなり、伝導帯下端のエネルギーとフェルミエネルギーが近づく現象(CBL効果(Conduction band lowering effect))により、実効チャンネル長 L_{eff} がチャンネル長 L より短くなることが考えられる。飽和移動度は、数式7に示したように、実効チャンネル長 L_{eff} が小さくなることで、 L/L_{eff} に比例して大きくなる。この効果は、チャンネル長 L が小さいほど顕著に生じるので、チャンネル長 L が小さいほど飽和移動度が向上していると考えられる。

10

【0161】

<<浅い電子トラップ準位を仮定したモデル>>

次に、実際のトランジスタの飽和移動度に近似させるために、理想的なモデルのトランジスタにおいて、ゲート絶縁膜GI_1及び酸化物半導体膜OSの界面に、電子をトラップすると負に帯電するアクセプター型の準位、即ち浅い電子トラップ準位を仮定して計算した結果を図35に示す。

20

【0162】

図35(A)に、ゲート絶縁膜GI_1及び酸化物半導体膜OSの界面に仮定した電子トラップ準位のDOS(density of state)を示す。

【0163】

次に、Dual Gate駆動のトランジスタ及びSingle Gate駆動のトランジスタそれぞれの飽和移動度を計算した。Dual Gate駆動のトランジスタの計算結果を図35(B)に示し、Single Gate駆動のトランジスタの計算結果を図35(C)に示す。

30

【0164】

図35(B)及び図35(C)より、Dual Gate駆動のトランジスタ及びSingle Gate駆動のトランジスタの飽和移動度において、理想的なモデルで得られたような鋭いピークが現れなかった。また、図35(C)より、Single Gate駆動のトランジスタでは、チャンネル長 L にあまり依存せず、飽和移動度のピーク値はおおよそ $5\text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{sec}$ 前後であった。一方、Dual Gate駆動のトランジスタでは、チャンネル長 L が小さくなるほど、飽和移動度のピーク値が高くなり、その値は15乃至 $20\text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{sec}$ となった。この結果は、後述する実施例の結果と同じ傾向である。

40

【0165】

このことから、Dual Gate駆動のトランジスタにおいて、チャンネル長 L を小さくする程、飽和移動度が上昇することが分かる。

【0166】

<Dual Gate駆動におけるチャンネルエッチ型のトランジスタ及びチャンネル保護型のトランジスタの比較>

以下に、チャンネルエッチ型のトランジスタ及びチャンネル保護型のトランジスタの電気特性について計算を行った結果を用いて、チャンネルエッチ型のトランジスタ及びチャンネル保護型のトランジスタ、それぞれの電界効果移動度及びオン電流について比較する。なお、ここでは、酸化物半導体膜を挟んで対向するゲート電極が接続し、同電位であるDual Gate駆動のトランジスタの電界効果移動度(μ_{FE})及びオン電流(I_{on})につ

50

いて比較するものとする。

【 0 1 6 7 】

図 2 9 (A) に、計算で用いたチャネル保護型のトランジスタの構造を示す。なお、計算にはデバイスシミュレーションソフト A t l a s (S i l v a c o 社製) を用いた。

【 0 1 6 8 】

チャネル保護型のトランジスタは、ゲート電極 G E _ 1 上にゲート絶縁膜 G I _ 1 が形成され、ゲート絶縁膜 G I _ 1 上に酸化物半導体膜 O S が形成される。ゲート絶縁膜 G I _ 1 及び酸化物半導体膜 O S 上にソース電極 S 及びドレイン電極 D が形成される。なお、ソース電極 S 及びドレイン電極 D の端部と酸化物半導体膜 O S の間にはチャネル保護膜 C S が形成される。酸化物半導体膜 O S 、ソース電極 S 及びドレイン電極 D 、並びにチャネル保護膜 C S 上にゲート絶縁膜 G I _ 2 が形成される。ゲート絶縁膜 G I _ 2 上にゲート電極 G E _ 2 が形成される。また、ゲート電極 G E _ 1 及びゲート電極 G E _ 2 は、ゲート絶縁膜 G I _ 1 及びゲート絶縁膜 G I _ 2 に形成される開口部 (図示しない。) において、接続する。

【 0 1 6 9 】

チャネルエッチ型のトランジスタは、チャネル保護膜 C S が設けられず、ソース電極 S 及びドレイン電極 D の端部が、酸化物半導体膜 O S に接する構造である。

【 0 1 7 0 】

計算に用いた条件を表 2 に示す。

【 0 1 7 1 】

【表 2】

チャネル長L	10 μ m
チャネル幅W	50 μ m
GI_1の厚さT1	450nm
GI_2の厚さT2	450nm
チャネル保護膜CSの厚さT3	100nm
GI_1、GI_2、CSの誘電率Er	3.9
OSの厚さ	35nm
OSの移動度	10cm ² /Vsec
OSの誘電率Er	15
SD直下におけるOSのドナー密度	1 \times 10 ¹⁹ /cm ³
チャネル領域におけるOSのドナー密度	6.6 \times 10 ⁻⁹ /cm ³

【 0 1 7 2 】

図 2 9 (A) は、D u a l G a t e 駆動のトランジスタを示すが、比較例として、ゲート電極 G E _ 2 を有さない、S i n g l e G a t e 駆動のトランジスタに関しても、D u a l G a t e 駆動のトランジスタと同様の計算を行った。S i n g l e G a t e 駆動のトランジスタは、図 2 (A 2)、図 2 (B)、及び図 2 (C 2) の選択トランジスタとして機能するトランジスタ 4 0 0 b に相当する。

【 0 1 7 3 】

チャネル保護型のトランジスタにおいて、チャネル保護膜 C S を介して、酸化物半導体膜 O S とソース電極 S またはドレイン電極 D とが重畳する領域の長さを S o v とする。また、ソース電極 S 及びドレイン電極 D において、チャネル保護膜 C S を介して酸化物半導体膜 O S と重畳する領域を S o v 領域とする。S o v と電界効果移動度との関係を計算した結果を図 2 9 (B) に示し、S o v とオン電流との関係を計算した結果を図 2 9 (C)

に示す。

【0174】

また、チャネルエッチ型のトランジスタにおいては、 Sov を $0\mu m$ として、電界効果移動度及びオン電流を計算した。また、計算結果をそれぞれ図29(B)及び図29(C)に示す。

【0175】

なお、図29(B)は、ドレイン電圧 V_d を $1V$ としたときの結果である。また、図29(C)は、ドレイン電圧 V_d を $1V$ 、ゲート電圧 V_g を $10V$ としたときの結果である。

【0176】

図29(B)に示すように、チャネルエッチ型のトランジスタ(Sov が $0\mu m$)では、Single Gate駆動のトランジスタと比較して、Dual Gate駆動のトランジスタの電界効果移動度は約2倍になっている。一方、チャネル保護型のトランジスタでは、Dual Gate駆動のトランジスタの電界効果移動度は、 Sov の長さが大きくなるに従って減少している。

【0177】

また、図29(C)に示すように、チャネルエッチ型のトランジスタ(Sov が $0\mu m$)では、Single Gate駆動のトランジスタと比較して、Dual Gate駆動のトランジスタのオン電流は約2倍になっている。一方、チャネル保護型のトランジスタでは、Dual Gate駆動のトランジスタのオン電流は、 Sov の長さが大きくなるに従って減少している。

【0178】

チャネル保護型のトランジスタでは、ソース電極S及びドレイン電極Dにおける Sov 領域がゲート電極 GE_2 の電界を遮蔽する。このため、酸化物半導体膜OSにおいて、ゲート電極 GE_2 の電圧によりキャリア密度を制御ができない領域が広がる。この結果、 Sov の長さが大きくなるにつれ、電界効果移動度が低減し、オン電流が小さくなると考えられる。以上のことから、チャネル保護型のトランジスタと比較して、チャネルエッチ型のトランジスタの方が、Dual Gate駆動における電界効果移動度の上昇効果及び電流増幅効果が高い。すなわち、本実施の形態の表示装置において発光素子の駆動トランジスタとして用いられるトランジスタ400aには、チャネルエッチ型のトランジスタを適用することが効果的である。

【0179】

また、チャネルエッチ型のトランジスタは、チャネル保護型のトランジスタと比較して、一对の電極の距離を小さくすることが容易である。このため、トランジスタ400aは、チャネル長を $0.5\mu m$ 以上 $4.5\mu m$ 以下、好ましくは $1\mu m$ より大きく $4\mu m$ 以下、より好ましくは $1\mu m$ より大きく $3.5\mu m$ 以下、より好ましくは $1\mu m$ より大きく $2.5\mu m$ 以下とすることができる。

【0180】

<表示装置の作製方法>

次に、図2に示すトランジスタ400a及びトランジスタ400bを含む表示装置の作製方法について、図3乃至図6を用いて説明する。なお、図3乃至図6において、A1-B1に示すチャネル長方向の断面図及びC1-D1に示すチャネル幅方向の断面図を用いて、トランジスタ400aの作製方法を説明し、A2-B2に示すチャネル長方向の断面図を用いてトランジスタ400bの作製方法を説明する。

【0181】

なお、トランジスタ400bのチャネル幅方向の断面図は、開口部42、43においてゲート電極13aと接するゲート電極31を有さない点以外はトランジスタ400aと同様である。

【0182】

図3(A)に示すように、基板11上に、のちにゲート電極13a、13bとなる導電

10

20

30

40

50

膜 1 2 を形成する。

【 0 1 8 3 】

ここでは、基板 1 1 としてガラス基板を用いる。

【 0 1 8 4 】

導電膜 1 2 は、スパッタリング法、C V D 法、蒸着法等により形成する。

【 0 1 8 5 】

ここでは、導電膜 1 2 として、厚さ 1 0 0 n m のタングステン膜をスパッタリング法により形成する。

【 0 1 8 6 】

次に、導電膜 1 2 上に第 1 のフォトマスクを用いたフォトリソグラフィ工程によりマスクを形成する。次に、該マスクを用いて導電膜 1 2 の一部をエッチングして、ゲート電極 1 3 a、1 3 b を形成する。この後、マスクを除去する（図 3（B）参照。）。 10

【 0 1 8 7 】

導電膜 1 2 の一部をエッチングする方法としては、ウエットエッチング法、ドライエッチング法等があり、これら的一方または両方を用いることができる。

【 0 1 8 8 】

ここでは、フォトリソグラフィ工程によりマスクを形成し、当該マスクを用いて導電膜 1 2 をドライエッチングして、ゲート電極 1 3 a、1 3 b を形成する。

【 0 1 8 9 】

なお、ゲート電極 1 3 a、1 3 b は、上記形成方法の代わりに、電解メッキ法、印刷法、インクジェット法等で形成してもよい。 20

【 0 1 9 0 】

次に、図 3（C）に示すように、基板 1 1 及びゲート電極 1 3 a、1 3 b 上に、のちに絶縁膜 1 5 となる絶縁膜 1 4 を形成し、絶縁膜 1 4 上に、のちに酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b となる酸化物半導体膜 1 6 を形成する。

【 0 1 9 1 】

絶縁膜 1 4 は、スパッタリング法、C V D 法、蒸着法等で形成する。

【 0 1 9 2 】

絶縁膜 1 4 として酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、または窒化酸化シリコン膜を形成する場合、原料ガスとしては、シリコンを含む堆積性気体及び酸化性気体を用いることが好ましい。シリコンを含む堆積性気体の代表例としては、シラン、ジシラン、トリシラン、フッ化シラン等がある。酸化性気体としては、酸素、オゾン、一酸化二窒素、二酸化窒素等がある。 30

【 0 1 9 3 】

絶縁膜 1 4 として酸化ガリウム膜を形成する場合、M O C V D（M e t a l O r g a n i c C h e m i c a l V a p o r D e p o s i t i o n）法を用いて形成することができる。

【 0 1 9 4 】

酸化物半導体膜 1 6 は、スパッタリング法、塗布法、パルスレーザー蒸着法、レーザーアブレーション法等を用いて形成することができる。 40

【 0 1 9 5 】

スパッタリング法で酸化物半導体膜 1 6 を形成する場合、プラズマを発生させるための電源装置は、R F 電源装置、A C 電源装置、D C 電源装置等を適宜用いることができる。

【 0 1 9 6 】

スパッタリングガスは、希ガス（代表的にはアルゴン）雰囲気、酸化雰囲気、希ガス及び酸素の混合ガスを適宜用いる。なお、希ガス及び酸素の混合ガスの場合、希ガスに対して酸素のガス比を高めることが好ましい。

【 0 1 9 7 】

また、ターゲットは、形成する酸化物半導体膜 1 6 の組成にあわせて、適宜選択すればよい。 50

【0198】

高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜16を得るためには、チャンバー内を高真空排気するのみならずスパッタガスの高純度化も必要である。スパッタガスとして用いる酸素ガスやアルゴンガスは、露点が-40以下、好ましくは-80以下、より好ましくは-100以下、より好ましくは-120以下にまで高純度化したガスを用いることで酸化物半導体膜16に水分等が取り込まれることを可能な限り防ぐことができる。

【0199】

ここでは、In-Ga-Zn酸化物ターゲット(In:Ga:Zn=1:1:1)を用いたスパッタリング法により、酸化物半導体膜16として厚さ35nmのIn-Ga-Zn酸化物膜を形成する。

10

【0200】

次に、酸化物半導体膜16上に、第2のフォトリソグラフィ工程によりマスクを形成した後、該マスクを用いて酸化物半導体膜16の一部をエッチングすることで、素子分離された酸化物半導体膜17a、17bをそれぞれ形成する。この後、マスクを除去する(図3(D)参照。)。

【0201】

酸化物半導体膜16の一部をエッチングする方法としては、ウェットエッチング法、ドライエッチング法等があり、これらの一方または両方を用いることができる。

【0202】

20

ここでは、フォトリソグラフィ工程によりマスクを形成し、当該マスクを用いて酸化物半導体膜16をウェットエッチングして、酸化物半導体膜17a、17bを形成する。

【0203】

なお、この後、150以上基板歪み点未満、好ましくは200以上450以下、更に好ましくは300以上450以下の加熱処理を行ってもよい。この結果、酸化物半導体膜17a、17bに含まれる水素、水等の含有量を低減することが可能であり、酸化物半導体膜17a、17bに含まれる不純物を低減することが可能である。

【0204】

次に、図4(A)に示すように、のちにトランジスタ400aの一对の電極20a、20b、及びトランジスタ400bの一对の電極20c、20dとなる導電膜18を形成する。

30

【0205】

導電膜18は、スパッタリング法、CVD法、蒸着法等で形成する。

【0206】

ここでは、厚さ50nmのタングステン膜及び厚さ300nmの銅膜を順にスパッタリング法により積層し、導電膜18を形成する。

【0207】

次に、導電膜18上に第3のフォトリソグラフィ工程によりマスクを形成する。次に、該マスクを用いて導電膜18をエッチングして、一对の電極20a、20b及び一对の電極20c、20dを形成する。この後、マスクを除去する(図4(B)参照。)。

40

【0208】

ここでは、当該マスクを用いてタングステン膜及び銅膜をドライエッチングして、一对の電極20a、20b及び一对の電極20c、20dを形成する。なお、はじめに、ウェットエッチング法を用いて銅膜をエッチングし、次に、SF₆を用いたドライエッチング法により、タングステン膜をエッチングすることで、該エッチングにおいて、銅膜の表面にフッ化物が形成される。該フッ化物により、銅膜からの銅元素の拡散が低減され、酸化物半導体膜17a、17bにおける銅濃度を低減することができる。

【0209】

次に、図5(A)に示すように、酸化物半導体膜17a及び一对の電極20a、20b

50

上、並びに、酸化物半導体膜 17b 及び一対の電極 20c、20d 上に、後に酸化物絶縁膜 23 となる酸化物絶縁膜 22、及び後に酸化物絶縁膜 25 となる酸化物絶縁膜 24 を形成する。

【0210】

なお、酸化物絶縁膜 22 を形成した後、大気に曝すことなく、連続的に酸化物絶縁膜 24 を形成することが好ましい。酸化物絶縁膜 22 を形成した後、大気開放せず、原料ガスの流量、圧力、高周波電力及び基板温度の一以上を調整して、酸化物絶縁膜 24 を連続的に形成することで、酸化物絶縁膜 22 及び酸化物絶縁膜 24 における界面の大気成分由来の不純物濃度を低減することができると共に、酸化物絶縁膜 24 に含まれる酸素を酸化物半導体膜 17a、17b に移動させることが可能であり、酸化物半導体膜 17a、17b の酸素欠損量を低減することができる。

10

【0211】

酸化物絶縁膜 22 としては、プラズマ CVD 装置の真空排気された処理室内に載置された基板を 280 以上 400 以下に保持し、処理室に原料ガスを導入して処理室内における圧力を 20 Pa 以上 250 Pa 以下、さらに好ましくは 100 Pa 以上 250 Pa 以下とし、処理室内に設けられる電極に高周波電力を供給する条件により、酸化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜を形成することができる。

【0212】

酸化物絶縁膜 22 の原料ガスとしては、シリコンを含む堆積性気体及び酸化性気体を用いることが好ましい。シリコンを含む堆積性気体の代表例としては、シラン、ジシラン、トリシラン、フッ化シラン等がある。酸化性気体としては、酸素、オゾン、一酸化二窒素、二酸化窒素等がある。

20

【0213】

上記条件を用いることで、酸化物絶縁膜 22 として酸素を透過する酸化物絶縁膜を形成することができる。また、酸化物絶縁膜 22 を設けることで、後に形成する酸化物絶縁膜 25 の形成工程において、酸化物半導体膜 17a、17b へのダメージ低減が可能である。

【0214】

当該成膜条件において、基板温度を上記温度とすることで、シリコン及び酸素の結合力が強くなる。この結果、酸化物絶縁膜 22 として、酸素が透過し、緻密であり、且つ硬い酸化物絶縁膜、代表的には、25 において 0.5 重量%のフッ酸に対するエッチング速度が 10 nm/分以下、好ましくは 8 nm/分以下である酸化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜を形成することができる。

30

【0215】

また、加熱をしながら酸化物絶縁膜 22 を形成するため、酸化物半導体膜 17a、17b に水素、水等が含まれる場合、当該工程において酸化物半導体膜 17a、17b に含まれる水素、水等を脱離させることができる。酸化物半導体膜 17a、17b に含まれる水素は、プラズマ中で発生した酸素ラジカルと結合し、水となる。酸化物絶縁膜 22 の成膜工程において基板が加熱されているため、酸素及び水素の結合により生成された水は、酸化物半導体膜 17a、17b から脱離する。即ち、プラズマ CVD 法によって酸化物絶縁膜 22 を形成することで、酸化物半導体膜 17a、17b に含まれる水及び水素の含有量を低減することができる。

40

【0216】

また、酸化物絶縁膜 22 を形成する工程において加熱するため、酸化物半導体膜 17a、17b が露出された状態での加熱時間が少なく、加熱処理による酸化物半導体膜からの酸素の脱離量を低減することができる。即ち、酸化物半導体膜 17a、17b 中に含まれる酸素欠損量を低減することができる。

【0217】

さらには、処理室の圧力を 100 Pa 以上 250 Pa 以下とすることで、酸化物絶縁膜 23 に含まれる水の含有量が少なくなるため、トランジスタ 400a 及びトランジスタ 4

50

00bの電気特性のばらつきを低減すると共に、しきい値電圧の変動を抑制することができる。

【0218】

また、処理室の圧力を100Pa以上250Pa以下とすることで、酸化物絶縁膜22を成膜する際に、酸化物半導体膜17a、17bへのダメージを低減することが可能であり、酸化物半導体膜17a、17bに含まれる酸素欠損量を低減することができる。特に、酸化物絶縁膜22または後に形成される酸化物絶縁膜24の成膜温度を高くする、代表的には220より高い温度とすることで、酸化物半導体膜17a、17bに含まれる酸素の一部が脱離し、酸素欠損が形成されやすい。また、トランジスタの信頼性を高めるため、後に形成する酸化物絶縁膜24の欠陥量を低減するための成膜条件を用いると、酸素脱離量が低減しやすい。これらの結果、酸化物半導体膜17a、17bの酸素欠損を低減することが困難な場合がある。しかしながら、処理室の圧力を100Pa以上250Pa以下とし、酸化物絶縁膜22の成膜時における酸化物半導体膜17a、17bへのダメージを低減することで、酸化物絶縁膜24からの少ない酸素脱離量でも酸化物半導体膜17a、17b中の酸素欠損を低減することが可能である。

10

【0219】

なお、シリコンを含む堆積性気体に対する酸化性気体量を100倍以上とすることで、酸化物絶縁膜22に含まれる水素含有量を低減することが可能である。この結果、酸化物半導体膜17a、17bに混入する水素量を低減できるため、トランジスタのしきい値電圧のマイナスシフトを抑制することができる。

20

【0220】

ここでは、酸化物絶縁膜22として、流量30sccmのシラン及び流量4000sccmの一酸化二窒素を原料ガスとし、処理室の圧力を200Pa、基板温度を220とし、27.12MHzの高周波電源を用いて150Wの高周波電力を平行平板電極に供給したプラズマCVD法により、厚さ50nmの酸化窒化シリコン膜を形成する。当該条件により、酸素が透過する酸化窒化シリコン膜を形成することができる。

【0221】

酸化物絶縁膜24としては、プラズマCVD装置の真空排気された処理室内に載置された基板を180以上280以下、さらに好ましくは200以上240以下に保持し、処理室に原料ガスを導入して処理室内における圧力を100Pa以上250Pa以下、さらに好ましくは100Pa以上200Pa以下とし、処理室内に設けられる電極に0.17W/cm²以上0.5W/cm²以下、さらに好ましくは0.25W/cm²以上0.35W/cm²以下の高周波電力を供給する条件により、酸化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜を形成する。

30

【0222】

酸化物絶縁膜24の原料ガスとしては、シリコンを含む堆積性気体及び酸化性気体を用いることが好ましい。シリコンを含む堆積性気体の代表例としては、シラン、ジシラン、トリシラン、フッ化シラン等がある。酸化性気体としては、酸素、オゾン、一酸化二窒素、二酸化窒素等がある。

【0223】

酸化物絶縁膜24の成膜条件として、上記圧力の反応室において上記パワー密度の高周波電力を供給することで、プラズマ中で原料ガスの分解効率が高まり、酸素ラジカルが増加し、原料ガスの酸化が進むため、酸化物絶縁膜25中における酸素含有量が化学量論的組成よりも多くなる。一方、基板温度が、上記温度で形成された膜では、シリコンと酸素の結合力が弱いため、後の工程の加熱処理により膜中の酸素の一部が脱離する。この結果、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含み、加熱により酸素の一部が脱離する酸化物絶縁膜を形成することができる。また、酸化物半導体膜17上に酸化物絶縁膜22が設けられている。このため、酸化物絶縁膜24の形成工程において、酸化物絶縁膜22が酸化物半導体膜17の保護膜となる。この結果、酸化物半導体膜17へのダメージを低減しつつ、パワー密度の高い高周波電力を用いて酸化物絶縁膜24を形成することがで

40

50

きる。

【0224】

ここでは、酸化物絶縁膜24として、流量200 sccmのシラン及び流量4000 sccmの一酸化二窒素を原料ガスとし、反応室の圧力を200 Pa、基板温度を220とし、27.12 MHzの高周波電源を用いて1500 Wの高周波電力を平行平板電極に供給したプラズマCVD法により、厚さ400 nmの酸化窒化シリコン膜を形成する。なお、プラズマCVD装置は電極面積が6000 cm²である平行平板型のプラズマCVD装置であり、供給した電力を単位面積あたりの電力（電力密度）に換算すると0.25 W/cm²である。

【0225】

次に、加熱処理を行う。該加熱処理の温度は、代表的には、150 以上400 以下、好ましくは300 以上400 以下、好ましくは320 以上370 以下とする。

【0226】

該加熱処理は、電気炉、RTA装置等を用いることができる。RTA装置を用いることで、短時間に限り、基板の歪み点以上の温度で熱処理を行うことができる。そのため加熱処理時間を短縮することができる。

【0227】

加熱処理は、窒素、酸素、超乾燥空気（水の含有量が20 ppm以下、好ましくは1 ppm以下、好ましくは10 ppb以下の空気）、または希ガス（アルゴン、ヘリウム等）の雰囲気下で行えばよい。なお、上記窒素、酸素、超乾燥空気、または希ガスに水素、水等が含まれないことが好ましい。

【0228】

当該加熱処理により、酸化物絶縁膜24に含まれる酸素の一部を酸化物半導体膜17a、17bに移動させ、酸化物半導体膜17a、17bに含まれる酸素欠損量をさらに低減することができる。

【0229】

また、酸化物絶縁膜22及び酸化物絶縁膜24に水、水素等が含まれる場合、水、水素等をブロッキングする機能を有する窒化物絶縁膜26を形成した後で加熱処理を行うと、酸化物絶縁膜22及び酸化物絶縁膜24に含まれる水、水素等が、酸化物半導体膜17a、17bに移動し、酸化物半導体膜17a、17bに欠陥が生じてしまう。しかしながら、当該加熱処理を窒化物絶縁膜26の形成前に行うことにより、酸化物絶縁膜22及び酸化物絶縁膜24に含まれる水、水素等を脱離させることが可能であり、トランジスタ400a、トランジスタ400bの電気特性のばらつきを低減すると共に、しきい値電圧の変動を抑制することができる。

【0230】

なお、加熱しながら酸化物絶縁膜24を、酸化物絶縁膜22上に形成することで、酸化物半導体膜17a、17bに酸素を移動させ、酸化物半導体膜17a、17bに含まれる酸素欠損を低減することが可能であるため、当該加熱処理を行わなくともよい。

【0231】

ここでは、窒素及び酸化雰囲気、350、1時間の加熱処理を行う。

【0232】

また、一対の電極20a、20b及び一対の電極20c、20dを形成する際、導電膜のエッチングによって、酸化物半導体膜17a、17bはダメージを受け、酸化物半導体膜17a、17bのバックチャネル（酸化物半導体膜17a、17bにおいて、ゲート電極13a、13bと対向する面と反対側の面）側に酸素欠損が生じる。しかし、酸化物絶縁膜24に化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜を適用することで、加熱処理によって当該バックチャネル側に生じた酸素欠損を低減することができる。これによりトランジスタ400a、400bの信頼性を向上させることができる。

【0233】

次に、スパッタリング法、CVD法等により、のちに窒化物絶縁膜27となる窒化物絶

10

20

30

40

50

縁膜 26 を形成する。

【0234】

なお、窒化物絶縁膜 26 をプラズマ CVD 法で形成する場合、プラズマ CVD 装置の真空排気された処理室内に載置された基板を 300 以上 400 以下、さらに好ましくは 320 以上 370 以下にすることで、緻密な窒化物絶縁膜を形成できるため好ましい。

【0235】

窒化物絶縁膜 26 としてプラズマ CVD 法により窒化シリコン膜を形成する場合、シリコンを含む堆積性気体、窒素、及びアンモニアを原料ガスとして用いることが好ましい。原料ガスとして、窒素と比較して少量のアンモニアを用いることで、プラズマ中でアンモニアが解離し、活性種が発生する。当該活性種が、シリコンを含む堆積性気体に含まれるシリコン及び水素の結合、及び窒素の三重結合を切断する。この結果、シリコン及び窒素の結合が促進され、シリコン及び水素の結合が少なく、欠陥が少なく、緻密な窒化シリコン膜を形成することができる。一方、原料ガスにおいて、窒素に対するアンモニアの量が多いと、シリコンを含む堆積性気体及び窒素それぞれの分解が進まず、シリコン及び水素結合が残存してしまい、欠陥が増大した、且つ粗な窒化シリコン膜が形成されてしまう。これらのため、原料ガスにおいて、アンモニアに対する窒素の流量比を 5 以上 50 以下、好ましくは 10 以上 50 以下とすることが好ましい。

【0236】

ここでは、プラズマ CVD 装置の反応室に、流量 50 sccm のシラン、流量 5000 sccm の窒素、及び流量 100 sccm のアンモニアを原料ガスとし、処理室の圧力を 100 Pa、基板温度を 350 とし、27.12 MHz の高周波電源を用いて 1000 W の高周波電力を平行平板電極に供給したプラズマ CVD 法により、窒化物絶縁膜 26 として、厚さ 50 nm の窒化シリコン膜を形成する。なお、プラズマ CVD 装置は電極面積が 6000 cm² である平行平板型のプラズマ CVD 装置であり、供給した電力を単位面積あたりの電力（電力密度）に換算すると $1.7 \times 10^{-1} \text{ W/cm}^2$ である。

【0237】

以上の工程により、酸化物絶縁膜 22、酸化物絶縁膜 24、及び窒化物絶縁膜 26 を形成することができる。

【0238】

次に、加熱処理を行ってもよい。該加熱処理の温度は、代表的には、150 以上 400 以下、好ましくは 300 以上 400 以下、好ましくは 320 以上 370 以下とする。

【0239】

次に、窒化物絶縁膜 26 上に第 4 のフォトリソグラフィ工程によりマスクを形成した後、該マスクを用いて、絶縁膜 14、酸化物絶縁膜 22、酸化物絶縁膜 24、及び窒化物絶縁膜 26 のそれぞれ一部をエッチングして、絶縁膜 15 と、酸化物絶縁膜 23、酸化物絶縁膜 25、及び窒化物絶縁膜 27 で構成される絶縁膜 28 とを形成する。なお、絶縁膜 28 は、トランジスタ 400a のチャネル長方向の断面図である図 5 (B) の A1 - B1 に示すように、開口部 41 を有する。また、絶縁膜 15 及び絶縁膜 28 には、トランジスタ 400a のチャネル幅方向の断面図である図 5 (B) の C1 - D1 に示すように、開口部 42、43 を有する。

【0240】

次に、図 6 (A) に示すように、後にゲート電極 31 及び電極 32 となる導電膜 30 を形成する。

【0241】

導電膜 30 は、スパッタリング法、CVD 法、蒸着法等により形成する。

【0242】

ここでは、スパッタリング法により導電膜 30 として厚さ 100 nm の ITO 膜を形成する。

図 2 と異なる構造の表示装置について、図 7 を用いて説明する。図 7 に示す表示装置は、駆動トランジスタとして機能するトランジスタ 4 1 0 a と、選択トランジスタとして機能するトランジスタ 4 0 0 b と、を含む画素を有する。図 7 (A 1) は、駆動トランジスタとして機能するトランジスタ 4 1 0 a の上面図であり、図 7 (A 2) は、選択トランジスタとして機能するトランジスタ 4 0 0 b の上面図であり、図 7 (B) は、図 7 (A 1) の一点鎖線 A 3 - B 3 及び図 7 (A 2) の一点鎖線 A 2 - B 2 の断面図であり、図 7 (C 1) は、図 7 (A 1) の一点鎖線 C 3 - D 3 間の断面図であり、図 7 (C 2) は、図 7 (

A 2) の一点鎖線 C 2 - D 2 間の断面図である。なお、図 7 (A 1) 及び図 7 (A 2) では、明瞭化のため、基板 1 1 及び絶縁膜などを省略している。

【 0 2 5 3 】

図 7 (A 2) 、図 7 (B) 及び図 7 (C 2) において選択トランジスタとして機能するトランジスタ 4 0 0 b は、図 2 (A 2) 、図 2 (B) 及び図 2 (C 2) の構成と同様である。

【 0 2 5 4 】

トランジスタ 4 1 0 a は、チャネル幅方向において、酸化物半導体膜 1 7 a の一方の側面の外側において、ゲート電極 1 3 a 及びゲート電極 5 1 が接続するが、酸化物半導体膜 1 7 a の他方の側面の外側において、絶縁膜 1 5 及び絶縁膜 2 8 を介して、ゲート電極 1 3 a 及びゲート電極 5 1 が対向する点が、先に示すトランジスタ 4 0 0 a と異なる。

【 0 2 5 5 】

図 7 (A 1) 、図 7 (B) 及び図 7 (C 1) に示すトランジスタ 4 1 0 a は、チャネルエッチ型のトランジスタであり、基板 1 1 上に設けられるゲート電極 1 3 a と、基板 1 1 及びゲート電極 1 3 a 上に形成される絶縁膜 1 5 と、絶縁膜 1 5 を介して、ゲート電極 1 3 a と重なる酸化物半導体膜 1 7 a と、酸化物半導体膜 1 7 a に接する一対の電極 2 0 a 、2 0 b とを有する。また、絶縁膜 1 5 、酸化物半導体膜 1 7 a 、及び一対の電極 2 0 a 、2 0 b 上に、酸化物絶縁膜 2 3 、酸化物絶縁膜 2 5 、及び窒化物絶縁膜 2 7 で構成される絶縁膜 2 8 と、絶縁膜 2 8 上に形成されるゲート電極 5 1 とを有する。ゲート電極 5 1 は、絶縁膜 1 5 及び絶縁膜 2 8 に設けられた開口部 4 2 においてゲート電極 1 3 a に接続する。また、一対の電極 2 0 a 、2 0 b の一方、ここでは電極 2 0 b に接続する電極 3 2 が絶縁膜 2 8 上に形成される。なお、電極 3 2 は画素電極として機能する。

【 0 2 5 6 】

トランジスタ 4 1 0 a は、チャネル長が $0.5 \mu\text{m}$ 以上 $4.5 \mu\text{m}$ 以下、好ましくは $1 \mu\text{m}$ より大きく $4 \mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $1 \mu\text{m}$ より大きく $3.5 \mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $1 \mu\text{m}$ より大きく $2.5 \mu\text{m}$ 以下である。トランジスタ 4 1 0 a は、ゲート電極 1 3 a 及びゲート電極 5 1 の間に酸化物半導体膜 1 7 a が設けられている。また、ゲート電極 5 1 は図 7 (A 1) に示すように、上面から見て、絶縁膜 2 8 を介して酸化物半導体膜 1 7 a の端部と重なる。

【 0 2 5 7 】

また、絶縁膜 1 5 及び絶縁膜 2 8 には複数の開口部を有する。代表的には、図 7 (B) に示すように、一対の電極 2 0 a 、2 0 b の一方を露出する開口部 4 1 を有する。また、図 7 (C 1) に示すように、酸化物半導体膜 1 7 a のチャネル幅方向の側面の一方の外側において、絶縁膜 1 5 及び絶縁膜 2 8 に開口部 4 2 が設けられ、該開口部 4 2 においてゲート電極 5 1 とゲート電極 1 3 a とが接続する。また、ゲート電極 5 1 は開口部 4 2 の側面において、酸化物半導体膜 1 7 a のチャネル幅方向の側面と対向する。また、酸化物半導体膜 1 7 a のチャネル幅方向の側面の他方の外側においては、ゲート電極 5 1 はゲート電極 1 3 a と接続しない。また、ゲート電極 5 1 端部は、酸化物半導体膜 1 7 a の側面の外側に位置する。

【 0 2 5 8 】

なお、図 7 (C 1) に示すように、チャネル幅方向において、絶縁膜 1 5 及び絶縁膜 2 8 の界面にゲート電極 5 1 を投影した際の端部と、酸化物半導体膜 1 7 a の側面との距離 d は、絶縁膜 1 5 の膜厚 t_1 と絶縁膜 2 8 の膜厚 t_2 を足し合わせた膜厚の 1 倍以上 7.5 倍以下とすることが好ましい。距離 d が、絶縁膜 1 5 の膜厚 t_1 と絶縁膜 2 8 の膜厚 t_2 を足し合わせた膜厚の 1 倍以上の場合、ゲート電極 5 1 の電界が酸化物半導体膜 1 7 a の側面、または側面及びその近傍を含む端部に影響するため、酸化物半導体膜 1 7 a の側面または端部における寄生チャネルの発生を抑制することができる。一方、距離 d が絶縁膜 1 5 の膜厚 t_1 と絶縁膜 2 8 の膜厚 t_2 を足し合わせた膜厚の 7.5 倍以下の場合、トランジスタの面積を小さくすることができる。

【 0 2 5 9 】

次に、トランジスタ 4 1 0 a の作製工程について説明する。

【 0 2 6 0 】

図 3 乃至図 5 (A) の工程を経て、基板 1 1 上にゲート電極 1 3 a、絶縁膜 1 4、酸化物半導体膜 1 7 a、一対の電極 2 0 a、2 0 b、酸化物絶縁膜 2 2、酸化物絶縁膜 2 4、及び窒化物絶縁膜 2 6 を形成する。なお、当該工程においては、第 1 のフォトマスク乃至第 3 のフォトマスクを用いたフォトリソグラフィ工程を行う。

【 0 2 6 1 】

次に、第 4 のフォトマスクを用いたフォトリソグラフィ工程により窒化物絶縁膜 2 6 上にマスクを形成した後、絶縁膜 1 4、酸化物絶縁膜 2 2、酸化物絶縁膜 2 4、及び窒化物絶縁膜 2 6 の一部をエッチングして、図 7 (A 1)、図 7 (B) 及び図 7 (C 1) に示す開口部 4 1、4 2 を形成する。

10

【 0 2 6 2 】

次に、図 6 (A) に示す工程と同様に、導電膜 3 0 を形成する。次に、第 5 のフォトマスクを用いたフォトリソグラフィ工程により導電膜 3 0 上にマスクを形成した後、導電膜 3 0 の一部をエッチングして図 7 (A 1)、図 7 (B) 及び図 7 (C 1) に示すゲート電極 5 1 及び電極 3 2 を形成する。

【 0 2 6 3 】

以上の工程により、トランジスタ 4 1 0 a を作製することができる。

【 0 2 6 4 】

< 表示装置の変形例 2 >

20

図 2 及び図 7 と異なる構造の表示装置について、図 8 を用いて説明する。図 8 に示す表示装置は、駆動トランジスタとして機能するトランジスタ 4 2 0 a と、選択トランジスタとして機能するトランジスタ 4 0 0 b と、を含む画素を有する。図 8 (A 1) は、駆動トランジスタとして機能するトランジスタ 4 2 0 a の上面図であり、図 8 (A 2) は、選択トランジスタとして機能するトランジスタ 4 0 0 b の上面図であり、図 8 (B) は、図 8 (A 1) の一点鎖線 A 4 - B 4 及び図 8 (A 2) の一点鎖線 A 2 - B 2 の断面図であり、図 8 (C 1) は、図 8 (A 1) の一点鎖線 C 4 - D 4 間の断面図であり、図 8 (C 2) は、図 8 (A 2) の一点鎖線 C 2 - D 2 間の断面図である。なお、図 8 (A 1) 及び図 8 (A 2) では、明瞭化のため、基板 1 1 及び絶縁膜などを省略している。

【 0 2 6 5 】

30

図 8 (A 2)、図 8 (B) 及び図 8 (C 2) において選択トランジスタとして機能するトランジスタ 4 0 0 b は、図 2 (A 2)、図 2 (B) 及び図 2 (C 2) の構成と同様である。また、図 8 (A 1)、図 8 (B) 及び図 8 (C 1) において駆動トランジスタとして機能するトランジスタ 4 2 0 a は、ゲート電極 1 3 a 及びゲート電極 6 4 が、導電膜 6 2 を介して接続している点が、先に示すトランジスタ 4 1 0 a と異なる。

【 0 2 6 6 】

図 8 (A 1)、(B) 及び図 8 (C 1) に示すトランジスタ 4 2 0 a は、チャネルエッチ型のトランジスタであり、基板 1 1 上に設けられるゲート電極 1 3 a と、基板 1 1 及びゲート電極 1 3 a 上に形成される絶縁膜 1 5 と、絶縁膜 1 5 を介して、ゲート電極 1 3 a と重なる酸化物半導体膜 1 7 a と、酸化物半導体膜 1 7 a に接する一対の電極 2 0 a、2 0 b とを有する。また、絶縁膜 1 5、酸化物半導体膜 1 7 a、及び一対の電極 2 0 a、2 0 b 上に、酸化物絶縁膜 2 3、酸化物絶縁膜 2 5、及び窒化物絶縁膜 2 7 で構成される絶縁膜 2 8 と、絶縁膜 2 8 上に形成されるゲート電極 6 4 とを有する。ゲート電極 6 4 は、導電膜 6 2 を介して、ゲート電極 1 3 a に接続する。また、一対の電極 2 0 a、2 0 b の一方、ここでは電極 2 0 b に接続する電極 3 2 が絶縁膜 2 8 上に形成される。なお、電極 3 2 は画素電極として機能する。

40

【 0 2 6 7 】

トランジスタ 4 2 0 a は、チャネル長が 0 . 5 μm 以上 4 . 5 μm 以下、好ましくは 1 μm より大きく 4 μm 以下、より好ましくは 1 μm より大きく 3 . 5 μm 以下、より好ましくは 1 μm より大きく 2 . 5 μm 以下である。また、トランジスタ 4 2 0 a は、ゲート

50

電極 13a 及びゲート電極 64 の間に酸化物半導体膜 17a が設けられている。また、ゲート電極 64 は図 8 (A1) に示すように、上面から見て、絶縁膜 28 を介して酸化物半導体膜 17a の端部と重なる。

【0268】

また、絶縁膜 15 及び絶縁膜 28 は複数の開口部を有する。代表的には、図 8 (B) に示すように、トランジスタ 420a の一对の電極 20a、20b の一方を露出する開口部 41 を有する。また、図 8 (C1) に示すように、絶縁膜 15 に設けられた開口部 61 において、導電膜 62 がゲート電極 13a と接続する。なお、導電膜 62 は、一对の電極 20a、20b と同時に形成される。また、絶縁膜 28 に設けられた開口部 63 において、ゲート電極 64 は導電膜 62 と接続する。即ち、導電膜 62 を介してゲート電極 13a 及びゲート電極 64 は電氣的に接続する。また、ゲート電極 13a 及びゲート電極 64 と同電位である導電膜 62 は酸化物半導体膜 17a の側面と対向する。

10

【0269】

なお、図 8 (C1) に示すように、トランジスタ 420a は、酸化物半導体膜 17a のチャネル幅方向の側面の一方の外側のみにおいて、ゲート電極 13a 及びゲート電極 64 が導電膜 62 を介して接続するが、酸化物半導体膜 17a のチャネル幅方向の側面の双方の外側において、ゲート電極 13a 及びゲート電極 64 が導電膜 62 を介して接続してもよい。

【0270】

次に、トランジスタ 420a の作製工程について説明する。

20

【0271】

図 3 の工程を経て、基板 11 上に、ゲート電極 13a、絶縁膜 14、及び酸化物半導体膜 17a を形成する。当該工程においては、第 1 のフォトリソグラフィ工程を行う。

【0272】

次に、第 3 のフォトリソグラフィ工程を用いたフォトリソグラフィ工程により絶縁膜 14 上にマスクを形成した後、絶縁膜 14 の一部をエッチングして、図 8 (A1) 及び図 8 (C1) に示す開口部 61 を形成する。

【0273】

次に、図 4 (A) 及び図 4 (B) に示す工程と同様に、第 4 のフォトリソグラフィ工程を用いたフォトリソグラフィ工程により導電膜 18 上にマスクを形成した後、導電膜 18 の一部をエッチングして、一对の電極 20a、20b、及び導電膜 62 を形成する。

30

【0274】

次に、図 5 (A) に示す工程と同様に、酸化物絶縁膜 22、酸化物絶縁膜 24、及び窒化物絶縁膜 26 を形成する。次に、第 5 のフォトリソグラフィ工程を用いたフォトリソグラフィ工程により窒化物絶縁膜 26 上にマスクを形成した後、窒化物絶縁膜 26 の一部をエッチングして、図 8 (A1) 及び図 8 (C1) に示す開口部 63 を形成する。

【0275】

次に、図 6 (A) に示す工程と同様に、導電膜 30 を形成する。次に、第 6 のフォトリソグラフィ工程を用いたフォトリソグラフィ工程により導電膜 30 上にマスクを形成した後、導電膜 30 の一部をエッチングして、図 8 (A1)、図 8 (B) 及び図 8 (C1) に示すゲート電極 64 及び電極 32 を形成する。

40

【0276】

以上の工程により、トランジスタ 420a を作製することができる。

【0277】

< 表示装置の変形例 3 >

図 2、図 7 及び図 8 と異なる構造の表示装置について、図 11 を用いて説明する。図 11 に示す表示装置は、駆動トランジスタとして機能するトランジスタ 430a と、選択トランジスタとして機能するトランジスタ 430b と、を含む画素を有する。図 11 (A1) は、駆動トランジスタとして機能するトランジスタ 430a の上面図であり、図 11 (

50

A 2) は、選択トランジスタとして機能するトランジスタ 430b の上面図であり、図 11(B) は、図 11(A1) の一点鎖線 A5 - B5 及び図 11(A2) の一点鎖線 A6 - B6 の断面図であり、図 11(C1) は、図 11(A1) の一点鎖線 C5 - D5 間の断面図であり、図 11(C2) は、図 11(A2) の一点鎖線 C6 - D6 間の断面図である。なお、図 11(A1) 及び図 11(A2) では、明瞭化のため、基板や絶縁膜などを省略している。

【0278】

図 11(A1)、図 11(B) 及び図 11(C1) に示すトランジスタ 430a は、一対の電極 20a、20b の一方に接続する電極 77 が絶縁膜 15 上に形成される。また、酸化物半導体膜 17a 及び一対の電極 20a、20b 上にトランジスタごとに分離された絶縁膜 74a を有する点が、先に示す他の駆動用トランジスタと異なる。

10

【0279】

また、図 11(A2)、図 11(B) 及び図 11(C2) に示すトランジスタ 430b は、酸化物半導体膜 17b 及び一対の電極 20c、20d 上にトランジスタごとに分離された絶縁膜 74b を有する点が、先に示したトランジスタ 400b と異なる。

【0280】

図 11(A1)、図 11(B) 及び図 11(C1) に示すトランジスタ 430a は、チャネルエッチ型のトランジスタであり、基板 11 上に設けられるゲート電極 13a と、基板 11 及びゲート電極 13a 上に形成される絶縁膜 15 と、絶縁膜 15 を介して、ゲート電極 13a と重なる酸化物半導体膜 17a と、酸化物半導体膜 17a に接する一対の電極 20a、20b とを有する。また、絶縁膜 15、酸化物半導体膜 17a、及び一対の電極 20a、20b 上に、酸化物絶縁膜 71a、酸化物絶縁膜 72a、及び窒化物絶縁膜 73a で構成されるゲート絶縁膜として機能する絶縁膜 74a と、絶縁膜 74a 及び窒化物絶縁膜 15a 上に形成されるゲート電極 76 とを有する。ゲート電極 76 は、窒化物絶縁膜 15a に設けられた開口部 75 においてゲート電極 13a と接続する。また、一対の電極 20a、20b の一方、ここでは電極 20b に接続する電極 77 が絶縁膜 15 上に形成される。なお、電極 77 は画素電極として機能する。

20

【0281】

また図 11(A2)、図 11(B) 及び図 11(C2) に示すトランジスタ 430b は、チャネルエッチ型のトランジスタであり、基板 11 上に設けられるゲート電極 13b と、基板 11 及びゲート電極 13b 上に形成される絶縁膜 15 と、絶縁膜 15 を介して、ゲート電極 13b と重なる酸化物半導体膜 17b と、酸化物半導体膜 17b に接する一対の電極 20c、20d とを有する。また、絶縁膜 15、酸化物半導体膜 17b、及び一対の電極 20c、20d 上に、酸化物絶縁膜 71b、酸化物絶縁膜 72b、及び窒化物絶縁膜 73b で構成される絶縁膜 74b と、を有する。

30

【0282】

トランジスタ 430a、430b に含まれる絶縁膜 15 は、窒化物絶縁膜 15a 及び酸化物絶縁膜 15b で形成される。酸化物絶縁膜 15b は、酸化物半導体膜 17a、一対の電極 20a、20b 及び酸化物絶縁膜 71a と重複する領域と、酸化物半導体膜 17b、一対の電極 20c、20d 及び酸化物絶縁膜 71b と重複する領域と、に形成される。

40

【0283】

また、絶縁膜 74a、74b は、トランジスタごとに分離されており、且つ酸化物半導体膜 17a、17b とそれぞれ重畳する。具体的には、図 11(B) に示すトランジスタ 430a のチャネル長方向において、一対の電極 20a、20b 上に絶縁膜 74a の端部が位置し、図 11(C1) に示すトランジスタ 430a のチャネル幅方向において、酸化物半導体膜 17a の外側に絶縁膜 74a の端部が位置する。また、図 11(B) に示すトランジスタ 430b のチャネル長方向において、一対の電極 20c、20d 上に絶縁膜 74b の端部が位置し、図 11(C2) に示すトランジスタ 430b のチャネル幅方向において、酸化物半導体膜 17b の外側に絶縁膜 74b の端部が位置する。

【0284】

50

また、図 11 (C1) に示すチャネル幅方向において、ゲート電極 76 は、ゲート絶縁膜として機能する絶縁膜 74a の側面において、酸化物半導体膜 17a の側面と対向する。なお、絶縁膜 74a の端部は、チャネル長方向において、一对の電極 20a、20b 上に設けられず、絶縁膜 15 上に設けられてもよい。この場合、電極 77 は、絶縁膜 74a 上に形成され、且つ絶縁膜 74a の開口部において、一对の電極 20a、20b の一方と接続する。

【0285】

トランジスタ 430a は、チャネル長が 0.5 μm 以上 4.5 μm 以下、好ましくは 1 μm より大きく 4 μm 以下、より好ましくは 1 μm より大きく 3.5 μm 以下、より好ましくは 1 μm より大きく 2.5 μm 以下である。また、トランジスタ 430a は、チャネル幅方向において、ゲート電極 13a 及びゲート電極 76 の間に、絶縁膜 15 及び絶縁膜 74a を介して酸化物半導体膜 17a が設けられている。また、ゲート電極 76 は、図 11 (A1) に示すように、上面から見て、絶縁膜 74a を介して酸化物半導体膜 17a の端部と重なる。

10

【0286】

また、トランジスタ 430b のチャネル長は、トランジスタ 430a よりも大きい。これによって、画素の選択トランジスタとして機能するトランジスタ 430b のカットオフ電流の値を低減することが可能となる。

【0287】

なお、図 11 (C1) ではチャネル幅方向において、酸化物半導体膜 17a のチャネル幅方向の側面の一方の外側のみににおいて、ゲート電極 13a 及びゲート電極 76 が接続する場合を例に示すが、酸化物半導体膜 17a のチャネル幅方向の側面の双方の外側において、ゲート電極 13a 及びゲート電極 76 が接続してもよい。

20

【0288】

次に、トランジスタ 430a、430b の作製方法について説明する。

【0289】

トランジスタ 430a、430b は、図 3 乃至図 5 (A) に示す工程を経て、基板 11 上に、ゲート電極 13a、13b、絶縁膜 14、酸化物半導体膜 17a、17b、一对の電極 20a、20b、一对の電極 20c、20d、酸化物絶縁膜 22、酸化物絶縁膜 24、及び窒化物絶縁膜 26 を形成する。当該工程においては、第 1 のフォトマスク乃至第 3

30

【0290】

次に、図 5 (B) に示す工程において、第 4 のフォトマスクを用いたフォトリソグラフィ工程により、窒化物絶縁膜 26 上にマスクを形成した後、酸化物絶縁膜 22、酸化物絶縁膜 24、及び窒化物絶縁膜 26 の一部をエッチングして、トランジスタごとに分離された絶縁膜 74a、74b を形成することができる。なお、絶縁膜 14 が窒化物絶縁膜及び酸化物絶縁膜で積層される場合、酸化物絶縁膜 23 のエッチングと共に、絶縁膜 14 の一部もエッチングされる。この結果、図 11 (B) に示すように、窒化物絶縁膜 15a 及び酸化物絶縁膜 15b で形成される段差を有する絶縁膜 15 が形成される。

【0291】

この後、図 6 に示す工程を経て、ゲート電極 76 及び電極 77 を形成する。

40

【0292】

以上の工程により、トランジスタ 430a、430b を作製することができる。

【0293】

<表示装置の変形例 4>

図 2、図 7、図 8 及び図 11 と異なる構造の表示装置について、図 9 を用いて説明する。図 9 (A) に、表示装置に含まれる画素 602 の等価回路図を示す。

【0294】

図 9 (A) に示すように、本変形例の画素 602 は、発光素子 350 と、発光素子 350 の駆動トランジスタとして機能するトランジスタ 400a と、選択トランジスタとして

50

機能するトランジスタ450bと、容量素子370と、を有し、トランジスタ400a及びトランジスタ450bは、ともに酸化物半導体膜の上下に配置されたゲート電極を含むいわゆるデュアルゲート型のトランジスタである。

【0295】

画素602に含まれるトランジスタ400aは、図2(A1)、図2(B)、図2(C1)及び図2(D)に示した構成と同様の構成とすることができる。

【0296】

また、図9(B)は、選択トランジスタとして機能するトランジスタ450bの上面図であり、図9(C)は、図9(B)の一点鎖線C9-D9の断面図であり、図9(D)は、図2(A1)で図示したトランジスタ400aの一点鎖線A1-B1及び図9(B)の一点鎖線A9-B9の断面図である。なお、図9(B)では、明瞭化のため、基板11及び絶縁膜などを省略している。

10

【0297】

図9に示すトランジスタ450bは、絶縁膜28上に、酸化物半導体膜17b及びゲート電極13bと重なるゲート電極109を有する点が、先に示す他の選択用トランジスタと異なる。

【0298】

図9に示すトランジスタ450bは、チャネルエッチ型のトランジスタであり、基板11上に設けられるゲート電極13bと、基板11及びゲート電極13b上に形成される絶縁膜15と、絶縁膜15を介して、ゲート電極13bと重なる酸化物半導体膜17bと、酸化物半導体膜17bに接する一対の電極20c、20dとを有する。また、絶縁膜15、酸化物半導体膜17b、及び一対の電極20c、20d上に、酸化物絶縁膜23、酸化物絶縁膜25、及び窒化物絶縁膜27で構成されるゲート絶縁膜として機能する絶縁膜28と、絶縁膜28及び絶縁膜15上に形成されるゲート電極109とを有する。ゲート電極109は、絶縁膜15及び絶縁膜28に設けられた開口部102、103においてゲート電極13bと接続する。

20

【0299】

トランジスタ450bに含まれるゲート電極109は、トランジスタ400aに含まれるゲート電極31と同じ層で形成される。

【0300】

また、トランジスタ450bは、少なくともトランジスタ400aよりも大きいチャネル長を有する。また、チャネル幅方向において、ゲート電極13b及びゲート電極109の間に、絶縁膜15及び絶縁膜28を介して酸化物半導体膜17bが設けられている。また、ゲート電極109は図9(B)に示すように、上面から見て、絶縁膜28を介して酸化物半導体膜17bの端部と重なる。

30

【0301】

トランジスタ400a、450bにおいて、エッチング等で島状に加工された酸化物半導体膜の端部においては、加工におけるダメージにより欠陥が形成されると共に、不純物付着などにより汚染される場合がある。このため、トランジスタにおいて酸化物半導体膜の上側又は下側に形成されるゲート電極のうち、一方のみが形成される場合、酸化物半導体膜が真性または実質的に真性であっても、電界などのストレスが与えられることによって酸化物半導体膜の端部は活性化され、n型(低抵抗領域)となりやすい。例えば、当該n型の端部が、図9(B)の破線33、34のように、一対の電極20c、20dの間に設けられると、n型の領域がキャリアのパスとなってしまう、寄生チャネルが形成される。この結果、しきい値電圧におけるドレイン電流の上昇が段階的であり、且つしきい値電圧がマイナスシフトしたトランジスタとなってしまう。

40

【0302】

しかしながら、図9に示すトランジスタ450bは、同電位であるゲート電極13b及びゲート電極109を有し、チャネル幅方向において、ゲート電極109が、絶縁膜28の側面において、酸化物半導体膜17bの側面と対向することで、ゲート電極109の電

50

界が酸化物半導体膜 17b 側面からも影響する。この結果、酸化物半導体膜 17b の側面、または側面及びその近傍を含む端部における寄生チャネルの発生が抑制される。この結果、トランジスタ 450b は、しきい値電圧におけるドレイン電流の上昇が急峻である、電気特性の優れたトランジスタとすることができる。なお、上記の記載は、トランジスタ 400a が有するゲート電極 13a、ゲート電極 31 及び酸化物半導体膜 17a についても適用することができる。

【0303】

なお、上記に示した本実施の形態の表示装置の構成及び変形例の表示装置の構成は、一部が異なる構成であるが、それぞれの構成を自由に組み合わせることが可能である。

【0304】

以上、本実施の形態で示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適宜組み合わせて用いることができる。

【0305】

(実施の形態 2)

本実施の形態では、実施の形態 1 と異なる表示装置及びその作製方法について図面を参照して説明する。本実施の形態では、酸化物半導体膜に含まれる酸素欠損がより低減されたトランジスタを図 12 乃至図 15 を用いて説明する。

【0306】

図 12 に本実施の形態の表示装置の画素に含まれるトランジスタの上面図及び断面図を示す。

【0307】

本実施の形態の表示装置は、駆動トランジスタとして機能するトランジスタ 440a と、選択トランジスタとして機能するトランジスタ 440b と、を含む画素を有する。図 12 (A1) は、駆動トランジスタとして機能するトランジスタ 440a の上面図であり、図 12 (A2) は、選択トランジスタとして機能するトランジスタ 440b の上面図であり、図 12 (B) は、図 12 (A1) の一点鎖線 A7 - B7 間の断面図及び図 12 (A2) の一点鎖線 A8 - B8 間の断面図であり、図 12 (C1) は、図 12 (A1) の一点鎖線 C7 - D7 間の断面図であり、図 12 (C2) は、図 12 (A2) の一点鎖線 C8 - D8 間の断面図である。なお、図 12 (A1) 及び図 12 (A2) では、明瞭化のため、基板 11 及び絶縁膜などを省略している。

【0308】

図 12 (A1)、図 12 (B) 及び図 12 (C1) に示すトランジスタ 440a は、チャネルエッチ型のトランジスタであり、基板 11 上に設けられるゲート電極 13a と、基板 11 及びゲート電極 13a 上に形成される絶縁膜 15 と、絶縁膜 15 を介して、ゲート電極 13a と重なる酸化物半導体膜 17a と、酸化物半導体膜 17a に接する一対の電極 20a、20b とを有する。また、絶縁膜 15、酸化物半導体膜 17a、及び一対の電極 20a、20b 上に、酸化物絶縁膜 83a、酸化物絶縁膜 85a、及び窒化物絶縁膜 87 で構成される絶縁膜 88a と、絶縁膜 88a 上に形成されるゲート電極 91 とを有する。ゲート電極 91 は、絶縁膜 15 及び窒化物絶縁膜 87 に設けられた開口部 96 においてゲート電極 13a と接続する。また、一対の電極 20a、20b の一方、ここでは電極 20b に接続する電極 92 が、窒化物絶縁膜 87 上に形成される。電極 92 は窒化物絶縁膜 87 に設けられた開口部 95 において、電極 20b と接続する。なお、電極 92 は画素電極として機能する。

【0309】

また、図 12 (A2)、図 12 (B) 及び図 12 (C2) に示すトランジスタ 440b は、チャネルエッチ型のトランジスタであり、基板 11 上に設けられるゲート電極 13b と、基板 11 及びゲート電極 13b 上に形成される絶縁膜 15 と、絶縁膜 15 を介して、ゲート電極 13b と重なる酸化物半導体膜 17b と、酸化物半導体膜 17b に接する一対の電極 20c、20d とを有する。また、絶縁膜 15、酸化物半導体膜 17b、及び一対の電極 20c、20d 上に、酸化物絶縁膜 83b、酸化物絶縁膜 85b、及び窒化物絶縁

膜 8 7 で構成される絶縁膜 8 8 b を有する。

【 0 3 1 0 】

トランジスタ 4 4 0 a において、絶縁膜 1 5 及び絶縁膜 8 8 a はそれぞれゲート絶縁膜として機能する。また、トランジスタ 4 4 0 b において、絶縁膜 1 5 はゲート絶縁膜として機能する。絶縁膜 1 5 は、窒化物絶縁膜 1 5 a 及び酸化物絶縁膜 1 5 b で形成される。酸化物絶縁膜 1 5 b は、酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b、一对の電極 2 0 a、2 0 b、一对の電極 2 0 c、2 0 d、又は酸化物絶縁膜 8 3 a のいずれかと重なる領域に形成される。

【 0 3 1 1 】

なお、トランジスタ 4 4 0 b において、絶縁膜 8 8 b 上であって、ゲート電極 1 3 b 及び酸化物半導体膜 1 7 b と重なる領域に第 2 のゲート電極を設けてもよい。その場合、該第 2 のゲート電極は、絶縁膜 1 5 及び窒化物絶縁膜 8 7 に設けられた開口部においてゲート電極 1 3 b と接続することが好ましい。

【 0 3 1 2 】

本実施の形態では、窒化物絶縁膜 1 5 a として、窒化シリコン膜を用いて形成する。また、酸化物絶縁膜 1 5 b は、実施の形態 1 に示す絶縁膜 1 5 において列挙した酸化物を適宜用いることができる。また、窒化物絶縁膜 1 5 a 及び酸化物絶縁膜 1 5 b はそれぞれ、絶縁膜 1 4 に列挙した作製方法を適宜用いることができる。また、酸化物絶縁膜 8 3 a、8 3 b は、実施の形態 1 に示す酸化物絶縁膜 2 3 と同様の材料及び作製方法を適宜用いて形成することができる。また、酸化物絶縁膜 8 5 a、8 5 b は、実施の形態 1 に示す酸化物絶縁膜 2 5 と同様の材料及び作製方法を適宜用いて形成することができる。窒化物絶縁膜 8 7 は、実施の形態 1 に示す窒化物絶縁膜 2 7 と同様の材料及び作製方法を適宜用いて形成することができる。また、ゲート電極 9 1 及び電極 9 2 は、実施の形態 1 に示すゲート電極 3 1 及び電極 3 2 と同様の材料及び作製方法を適宜用いて形成することができる。

【 0 3 1 3 】

また、酸化物絶縁膜 8 3 a、8 3 b 及び酸化物絶縁膜 8 5 a、8 5 b は、トランジスタごとに分離されており、且つ酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b とそれぞれ重畳する。具体的には、図 1 2 (B) に示すトランジスタ 4 4 0 a のチャネル長方向の断面図において、一对の電極 2 0 a、2 0 b 上に酸化物絶縁膜 8 3 a 及び酸化物絶縁膜 8 5 a の端部が位置し、図 1 2 (C 1) に示すトランジスタ 4 4 0 a のチャネル幅方向の断面図において、酸化物半導体膜 1 7 a の外側に酸化物絶縁膜 8 3 a 及び酸化物絶縁膜 8 5 a の端部が位置する。同様に、図 1 2 (B) に示すトランジスタ 4 4 0 b のチャネル長方向の断面図において、一对の電極 2 0 c、2 0 d 上に酸化物絶縁膜 8 3 b 及び酸化物絶縁膜 8 5 b の端部が位置し、図 1 2 (C 2) に示すトランジスタ 4 4 0 b のチャネル幅方向の断面図において、酸化物半導体膜 1 7 b の外側に酸化物絶縁膜 8 3 b 及び酸化物絶縁膜 8 5 b の端部が位置する。

【 0 3 1 4 】

また、窒化物絶縁膜 8 7 は、酸化物絶縁膜 8 3 a、8 3 b 及び酸化物絶縁膜 8 5 a、8 5 b の上面及び側面を覆うように形成され、窒化物絶縁膜 1 5 a と接する。

【 0 3 1 5 】

なお、トランジスタ 4 4 0 a において、酸化物絶縁膜 8 3 a 及び酸化物絶縁膜 8 5 a の端部は、チャネル長方向において、一对の電極 2 0 a、2 0 b 上に設けられず、窒化物絶縁膜 1 5 a 上に設けられてもよい。また、トランジスタ 4 4 0 b において、酸化物絶縁膜 8 3 b 及び酸化物絶縁膜 8 5 b の端部は、チャネル長方向において、一对の電極 2 0 c、2 0 d 上に設けられず、窒化物絶縁膜 1 5 a 上に設けられてもよい。

【 0 3 1 6 】

また、図 1 2 (C 1) に示すトランジスタ 4 4 0 a のチャネル幅方向の断面図において、ゲート電極 9 1 は、酸化物絶縁膜 8 3 a 及び酸化物絶縁膜 8 5 a の側面を介して、酸化物半導体膜 1 7 a の側面と対向する。

【 0 3 1 7 】

本実施の形態に示すトランジスタ440aは、チャネル長が $0.5\mu\text{m}$ 以上 $4.5\mu\text{m}$ 以下、好ましくは $1\mu\text{m}$ より大きく $4\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $1\mu\text{m}$ より大きく $3.5\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $1\mu\text{m}$ より大きく $2.5\mu\text{m}$ 以下である。また、トランジスタ440aは、チャネル幅方向において、ゲート電極13a及びゲート電極91の間に、絶縁膜15及び絶縁膜88aを介して酸化物半導体膜17aが設けられている。また、ゲート電極91は図12(A1)に示すように、上面から見て、絶縁膜88aを介して酸化物半導体膜17aの端部と重なる。

【0318】

また、トランジスタ440bのチャネル長は、トランジスタ440aよりも大きい。これによって、画素の選択トランジスタとして機能するトランジスタ440bのカットオフ電流の値を低減することが可能となる。

【0319】

トランジスタ440aは、図12(C1)に示すように、酸化物半導体膜17aのチャネル幅方向の側面の一方の外側において、絶縁膜15及び窒化物絶縁膜87の開口部96が設けられている。そして該開口部96において、ゲート電極91はゲート電極13aと接続する。また、ゲート電極91は酸化物絶縁膜83a、85aの側面において、酸化物半導体膜17aのチャネル幅方向の側面と対向する。また、酸化物半導体膜17aのチャネル幅方向の側面の他方の外側においては、ゲート電極91はゲート電極13aと接続しない。また、ゲート電極91端部は、酸化物半導体膜17aの側面の外側に位置する。

【0320】

なお、トランジスタ440aでは、図12(C1)に示すように、酸化物半導体膜17aのチャネル幅方向の側面の一方の外側のみににおいて、ゲート電極13a及びゲート電極91が接続するが、酸化物半導体膜17aのチャネル幅方向の側面の双方の外側において、ゲート電極13a及びゲート電極91が接続してもよい。

【0321】

本実施の形態に示すトランジスタ440a又はトランジスタ440bにおいて、酸化物半導体膜17a及び酸化物絶縁膜85a、又は酸化物半導体膜17b及び酸化物絶縁膜85bが、窒化物絶縁膜15a及び窒化物絶縁膜87で、周囲を囲まれている。窒化物絶縁膜15a及び窒化物絶縁膜87は、酸素の拡散係数が低く、酸素に対するバリア性を有するため、酸化物絶縁膜85a、85bに含まれる酸素の一部を効率よく酸化物半導体膜17a、17bに移動させることが可能であり、酸化物半導体膜17a、17bの酸素欠損量を減らすことが可能である。また、窒化物絶縁膜15a及び窒化物絶縁膜87は、水、水素等の拡散係数が低く、水、水素等に対するバリア性を有するため、外部から酸化物半導体膜17a、17bへの水、水素等の拡散を防ぐことが可能である。これらの結果、トランジスタ440a及びトランジスタ440bは、信頼性の高いトランジスタとなる。

【0322】

次に、トランジスタ440a及びトランジスタ440bを含む本実施の形態の表示装置の作製工程について図13乃至図15を用いて説明する。

【0323】

なお、図13乃至図15において、A7-B7に示すチャネル長方向の断面図及びC7-D7に示すチャネル幅方向の断面図を用いて、トランジスタ440aの作製方法を説明し、A8-B8に示すチャネル長方向の断面図を用いてトランジスタ440bの作製方法を説明する。

【0324】

なお、トランジスタ440bのチャネル幅方向の断面図は、開口部96においてゲート電極13aと接するゲート電極91を有さない点以外はトランジスタ440aと同様である。

【0325】

トランジスタ440a及びトランジスタ440bは、図3乃至図4(B)に示す工程と同様の工程を経て、基板11上に、ゲート電極13a、13b、窒化物絶縁膜15a、酸

10

20

30

40

50

化物絶縁膜 14b、酸化物半導体膜 17a、17b、一对の電極 20a、20b 及び一对の電極 20c、20d を形成する。当該工程においては、第 1 のフォトマスク乃至第 3 のフォトマスクを用いたフォトリソグラフィ工程を行う。

【0326】

次に、図 13 (A) に示すように、酸化物絶縁膜 22 及び酸化物絶縁膜 24 を形成する。次に、加熱処理を行って、酸化物絶縁膜 24 に含まれる酸素の一部を酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b に移動させる。ここでの加熱処理によって、酸化物半導体膜 17a、17b に含まれる酸素欠損量を低減することができる。

【0327】

次に、第 4 のフォトマスクを用いたフォトリソグラフィ工程により、酸化物絶縁膜 24 上にマスクを形成した後、酸化物絶縁膜 22 及び酸化物絶縁膜 24 の一部をエッチングして、トランジスタごとに分離された酸化物絶縁膜 83a、83b 及び酸化物絶縁膜 85a、85b を形成する。なお、酸化物絶縁膜 24 のエッチングと共に、酸化物絶縁膜 14b の一部もエッチングされ、酸化物絶縁膜 15b が形成される。この結果、図 13 (B) に示すように、窒化物絶縁膜 15a が露出される。即ち、段差を有する絶縁膜 15 が形成される。

【0328】

次に、図 14 (A) に示す窒化物絶縁膜 86 を形成する。当該工程において、C7 - D7 に示すトランジスタ 440a のチャネル幅方向断面図において、窒化物絶縁膜 15a 及び窒化物絶縁膜 86 が接する。即ち、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物絶縁膜 85a が、窒化物絶縁膜 15a 及び窒化物絶縁膜 86 で周囲を囲まれている。

【0329】

なお、図示しないが、窒化物絶縁膜 86 を形成することで、トランジスタ 440b のチャネル幅方向断面図においても、酸化物半導体膜 17b 及び酸化物絶縁膜 85b が、窒化物絶縁膜 15a 及び窒化物絶縁膜 86 で周囲を囲まれている。

【0330】

次に、第 5 のフォトマスクを用いたフォトリソグラフィ工程により、窒化物絶縁膜 86 上にマスクを形成した後、窒化物絶縁膜 86 の一部をエッチングして、開口部 95 を形成する。また、窒化物絶縁膜 15a 及び窒化物絶縁膜 86 の一部をエッチングして、開口部 96 を形成する (図 14 (B) 参照)。

【0331】

この後、図 15 (A) に示すように、後にトランジスタ 440a のゲート電極 91 及び電極 92 となる導電膜 90 を形成する。導電膜 90 は、実施の形態 1 に示す導電膜 30 と同様に形成することができる。

【0332】

次に、導電膜 90 上に第 6 のフォトマスクを用いたフォトリソグラフィ工程によりマスクを形成する。次に、該マスクを用いて導電膜 90 の一部をエッチングして、ゲート電極 91 及び電極 92 を形成する。この後、マスクを除去する (図 15 (B) 参照)。

【0333】

なお、図 15 (B) に示すように、トランジスタ 440a のチャネル幅方向断面図において、酸化物絶縁膜 83a 及び酸化物絶縁膜 85a の側面において酸化物半導体膜 17a との側面と対向するように、ゲート電極 91 を形成する。

【0334】

この後、加熱処理を行ってもよい。酸化物絶縁膜 85a、85b は、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜で形成される。また、窒化物絶縁膜 15a 及び窒化物絶縁膜 87 は酸素に対するバリア性が高い。これらのため、当該加熱処理において、酸化物絶縁膜 85a、85b に含まれる酸素の外部への拡散を低減することができる。また、酸化物半導体膜 17a、17b に含まれる酸素の外部への拡散を低減することができる。この結果、酸化物半導体膜 17a、17b の酸素欠損を低減することができる。さらに、窒化物絶縁膜 15a 及び窒化物絶縁膜 87 は、水素、水等に対するバリア性

10

20

30

40

50

が高く、外部からの酸化物半導体膜 17 a、17 b への水素、水等の拡散を低減することができる。このため、酸化物半導体膜 17 a、17 b の水素、水等を低減することができる。この結果、信頼性の高いトランジスタ 440 a 及びトランジスタ 440 b を作製することができる。

【0335】

以上の工程により、トランジスタ 440 a 及びトランジスタ 440 b を含む表示装置を作製することができる。

【0336】

以上、本実施の形態で示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適宜組み合わせて用いることができる。

【0337】

(実施の形態 3)

実施の形態 1 及び実施の形態 2 に示す選択トランジスタ及び駆動トランジスタにおいて、必要に応じて、基板 11 及びゲート電極 13 a、13 b の間に下地絶縁膜を設けることができる。下地絶縁膜としては、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化ガリウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム等がある。なお、下地絶縁膜として、窒化シリコン、酸化ガリウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム、酸化アルミニウム等を用いることで、基板 11 から不純物、代表的にはアルカリ金属、水、水素等の酸化物半導体膜 17 a、17 b への拡散を抑制することができる。

【0338】

下地絶縁膜は、スパッタリング法、CVD 法等により形成することができる。

【0339】

なお、本実施の形態に示す構成及び方法などは、他の実施の形態に示す構成及び方法などと適宜組み合わせて用いることができる。

【0340】

(実施の形態 4)

本実施の形態では、図 2 で示したトランジスタ 400 a 及びトランジスタ 400 b を用いて、酸化物半導体膜 17 a 及び一对の電極 20 a、20 b、酸化物半導体膜 17 b 及び一对の電極 20 c、20 d が異なる形態を有する表示装置について、図 19 を用いて説明する。なお、他のトランジスタに適宜本実施の形態を適用することができる。

【0341】

トランジスタに設けられる一对の電極として、タングステン、チタン、アルミニウム、銅、モリブデン、クロム、またはタンタル単体若しくは合金等の酸素と結合しやすい導電材料を用いることができる。この結果、酸化物半導体膜 17 a、17 b に含まれる酸素と電極 20 a 乃至 20 d に含まれる導電材料とが結合し、酸化物半導体膜 17 a、17 b において、酸素欠損領域が形成される。また、酸化物半導体膜 17 a、17 b に電極 20 a 乃至 20 d を形成する導電材料の構成元素の一部が混入する場合もある。これらの結果、図 19 に示すように、酸化物半導体膜 17 a、17 b において、電極 20 a 乃至 20 d と接する領域近傍に、低抵抗領域 21 a 乃至 21 d が形成される。具体的には、低抵抗領域 21 a、21 b は、一对の電極 20 a、20 b にそれぞれ接し、且つ絶縁膜 15 と、一对の電極 20 a、20 b との間に形成される。また、低抵抗領域 21 c、21 d は、一对の電極 20 c、20 d にそれぞれ接し、且つ絶縁膜 15 と、一对の電極 20 c、20 d との間に形成される。

【0342】

低抵抗領域 21 a 乃至 21 d は、導電性が高いため、酸化物半導体膜 17 a、17 b と、電極 20 a 乃至 20 d との接触抵抗を低減することが可能であり、トランジスタのオン電流を増大させることが可能である。

【0343】

なお、低抵抗領域 21 a、21 b の端部は、一对の電極 20 a、20 b の端部と略一致

10

20

30

40

50

してもよい。または、図 19 に示すように、一対の電極 20 a、20 b の端部より内側に低抵抗領域 21 a、21 b の端部が位置してもよい。同様に、低抵抗領域 21 c、21 d の端部は、一対の電極 20 c、20 d の端部と略一致してもよい。または、図 19 に示すように、一対の電極 20 c、20 d の端部より内側に低抵抗領域 21 c、21 d の端部が位置してもよい。酸化物半導体膜 17 a、17 b において、低抵抗領域 21 a 乃至 21 d が形成される場合、チャネル長は酸化物半導体膜と絶縁膜 28 の界面における低抵抗領域間の距離となる。

【0344】

また、電極 20 a 乃至 20 d を、上記酸素と結合しやすい導電材料と、窒化チタン、窒化タンタル、ルテニウム等の酸素と結合しにくい導電材料との積層構造としてもよい。このような積層構造とすることで、電極 20 a 乃至 20 d と酸化物絶縁膜 23 との界面において、電極 20 a 乃至 20 d の酸化を防ぐことが可能であり、電極 20 a 乃至 20 d の高抵抗化を抑制することが可能である。

【0345】

なお、本実施の形態に示す構成及び方法などは、他の実施の形態に示す構成及び方法などと適宜組み合わせ用いることができる。

【0346】

(実施の形態 5)

本実施の形態では、実施の形態 1 乃至実施の形態 4 と比較して、酸化物半導体膜の欠陥量をさらに低減することが可能なトランジスタを有する表示装置について図面を参照して説明する。本実施の形態で説明するトランジスタは、実施の形態 1 乃至実施の形態 4 と比較して、酸化物半導体膜を複数備えた多層膜を有する点異なる。

【0347】

図 20 (A1) 乃至図 20 (C2) に、表示装置が有するトランジスタ 105 a 及びトランジスタ 105 b の上面図及び断面図を示す。トランジスタ 105 a は、画素に含まれる発光素子の駆動トランジスタとして機能するトランジスタである。また、トランジスタ 105 b は、画素の選択トランジスタとして機能するトランジスタである。

【0348】

図 20 (A1) はトランジスタ 105 a の上面図であり、図 20 (A2) はトランジスタ 105 b の上面図である。図 20 (B) は、図 20 (A1) の一点鎖線 A10 - B10 間の断面図及び図 20 (A2) の一点鎖線 A11 - B11 間の断面図であり、図 20 (C1) は、図 20 (A1) の一点鎖線 C10 - D10 間の断面図であり、図 20 (C2) は、図 20 (A2) の一点鎖線 C11 - D11 間の断面図である。なお、図 20 (A1)、図 20 (A2) では、明瞭化のため、基板 11 及び絶縁膜などを省略している。

【0349】

図 20 に示す表示装置に含まれるトランジスタ 105 a 及びトランジスタ 105 b は、絶縁膜 15 と、絶縁膜 28 との間に多層膜 98 a 及び多層膜 98 b をそれぞれ有する点において、図 2 に示した表示装置に含まれるトランジスタ 400 a 及びトランジスタ 400 b と異なる。その他の構成は、図 2 と同様であり、先の説明を参酌することができる。

【0350】

本実施の形態に示すトランジスタ 105 a において、多層膜 98 a は、酸化物半導体膜 17 a 及び酸化物半導体膜 97 a を有する。また、トランジスタ 105 b において、多層膜 98 b は、酸化物半導体膜 17 b 及び酸化物半導体膜 97 b を有する。即ち、多層膜 98 a 及び多層膜 98 b はそれぞれ 2 層構造である。

【0351】

トランジスタ 105 a では、酸化物半導体膜 17 a の一部がチャネル領域として機能し、トランジスタ 105 b では、酸化物半導体膜 17 b の一部がチャネル領域として機能する。また、多層膜 98 a 及び多層膜 98 b に接するように、酸化物絶縁膜 23 が形成されており、酸化物絶縁膜 23 に接するように酸化物絶縁膜 25 が形成されている。即ち、酸化物半導体膜 17 a と酸化物絶縁膜 23 との間に、酸化物半導体膜 97 a が設けられ、且

10

20

30

40

50

つ、酸化物半導体膜 17b と酸化物絶縁膜 23 との間に、酸化物半導体膜 97b が設けられている。

【0352】

酸化物半導体膜 97a、97b は、酸化物半導体膜 17a、17b を構成する元素の一種以上から構成される酸化物半導体膜である。このため、酸化物半導体膜 17a と酸化物半導体膜 97a との界面、及び酸化物半導体膜 17b と酸化物半導体膜 97b との界面において、界面散乱が起こりにくい。従って、該界面においてはキャリアの動きが阻害されないため、トランジスタの電界効果移動度が高くなる。

【0353】

酸化物半導体膜 97a、97b に適用する酸化物半導体膜（以下、酸化物半導体膜 97）は、少なくとも In 若しくは Zn を含む金属酸化物で形成され、代表的には、In-Ga 酸化物、In-Zn 酸化物、In-M-Zn 酸化物（M は Al、Ga、Y、Zr、La、Ce、または Nd）であり、且つ酸化物半導体膜 17a、17b に適用する酸化物半導体膜（以下、酸化物半導体膜 17）よりも伝導帯の下端のエネルギーが真空準位に近く、代表的には、酸化物半導体膜 97 の伝導帯の下端のエネルギーと、酸化物半導体膜 17 の伝導帯の下端のエネルギーとの差が、0.05 eV 以上、0.07 eV 以上、0.1 eV 以上、または 0.15 eV 以上、且つ 2 eV 以下、1 eV 以下、0.5 eV 以下、または 0.4 eV 以下である。即ち、酸化物半導体膜 97 の電子親和力と、酸化物半導体膜 17 の電子親和力との差が、0.05 eV 以上、0.07 eV 以上、0.1 eV 以上、または 0.15 eV 以上、且つ 2 eV 以下、1 eV 以下、0.5 eV 以下、または 0.4 eV 以下である。

【0354】

酸化物半導体膜 97 は、In を含むことで、キャリア移動度（電子移動度）が高くなるため好ましい。

【0355】

酸化物半導体膜 97 として、Al、Ga、Y、Zr、La、Ce、または Nd を In より高い原子数比で有することで、以下の効果を有する場合がある。（1）酸化物半導体膜 97 のエネルギーギャップを大きくする。（2）酸化物半導体膜 97 の電子親和力を小さくする。（3）外部からの不純物の拡散を低減する。（4）酸化物半導体膜 17 と比較して、絶縁性が高くなる。

【0356】

また、Ga、Y、Zr、La、Ce、または Nd は、酸素との結合力が強い金属元素であるため、Ga、Y、Zr、La、Ce、または Nd を In より高い原子数比で有することで、酸素欠損が生じにくくなる。

【0357】

酸化物半導体膜 97 が In-M-Zn 酸化物であるとき、Zn および O を除いての In および M の原子数比率は、In が 50 atomic % 未満、M が 50 atomic % 以上、さらに好ましくは、In が 25 atomic % 未満、M が 75 atomic % 以上とする。

【0358】

また、酸化物半導体膜 17 及び酸化物半導体膜 97 が、In-M-Zn 酸化物（M は Ga、Y、Zr、La、Ce、または Nd）の場合、酸化物半導体膜 17 と比較して、酸化物半導体膜 97 に含まれる M（Ga、Y、Zr、La、Ce、または Nd）の原子数比が大きく、代表的には、酸化物半導体膜 17 に含まれる上記原子と比較して、1.5 倍以上、好ましくは 2 倍以上、さらに好ましくは 3 倍以上高い原子数比である。

【0359】

また、酸化物半導体膜 17 及び酸化物半導体膜 97 が、In-M-Zn 酸化物（M は Al、Ga、Y、Zr、La、Ce、または Nd）の場合、酸化物半導体膜 97 を In : M : Zn = x_1 : y_1 : z_1 [原子数比]、酸化物半導体膜 17 を In : M : Zn = x_2 : y_2 : z_2 [原子数比] とすると、 y_1 / x_1 が y_2 / x_2 よりも大きく、好ましくは、

10

20

30

40

50

y_1 / x_1 が y_2 / x_2 よりも 1.5 倍以上である。さらに好ましくは、 y_1 / x_1 が y_2 / x_2 よりも 2 倍以上大きく、より好ましくは、 y_1 / x_1 が y_2 / x_2 よりも 3 倍以上大きい。このとき、酸化物半導体膜において、 y_2 が x_2 以上であると、当該酸化物半導体膜を用いたトランジスタに安定した電気特性を付与できるため好ましい。ただし、 y_2 が x_2 の 3 倍以上になると、当該酸化物半導体膜を用いたトランジスタの電界効果移動度が低下してしまうため、 y_2 は x_2 の 3 倍未満であると好ましい。

【0360】

酸化物半導体膜 17 が In - M - Zn 酸化物 (M は、Ga、Y、Zr、La、Ce、または Nd) の場合、酸化物半導体膜 17 を成膜するために用いるターゲットにおいて、金属元素の原子数比を $\text{In} : \text{M} : \text{Zn} = x_1 : y_1 : z_1$ とすると、 x_1 / y_1 は、1/3 以上 6 以下、さらには 1 以上 6 以下であって、 z_1 / y_1 は、1/3 以上 6 以下、さらには 1 以上 6 以下であることが好ましい。なお、 z_1 / y_1 を 1 以上 6 以下とすることで、酸化物半導体膜 17 として CAAC - OS 膜が形成されやすくなる。ターゲットの金属元素の原子数比の代表例としては、 $\text{In} : \text{M} : \text{Zn} = 1 : 1 : 1$ 、 $\text{In} : \text{M} : \text{Zn} = 1 : 1 : 2$ 、 $\text{In} : \text{M} : \text{Zn} = 3 : 1 : 2$ 等がある。

10

【0361】

酸化物半導体膜 97 が In - M - Zn 酸化物 (M は、Ga、Y、Zr、La、Ce、または Nd) の場合、酸化物半導体膜 97 を成膜するために用いるターゲットにおいて、金属元素の原子数比を $\text{In} : \text{M} : \text{Zn} = x_2 : y_2 : z_2$ とすると、 $x_2 / y_2 < x_1 / y_1$ であって、 z_2 / y_2 は、1/3 以上 6 以下、さらには 1 以上 6 以下であることが好ましい。なお、 z_2 / y_2 を 1 以上 6 以下とすることで、酸化物半導体膜 97 として CAAC - OS 膜が形成されやすくなる。ターゲットの金属元素の原子数比の代表例としては、 $\text{In} : \text{M} : \text{Zn} = 1 : 3 : 2$ 、 $\text{In} : \text{M} : \text{Zn} = 1 : 3 : 4$ 、 $\text{In} : \text{M} : \text{Zn} = 1 : 3 : 6$ 、 $\text{In} : \text{M} : \text{Zn} = 1 : 3 : 8$ 等がある。

20

【0362】

なお、酸化物半導体膜 17 及び酸化物半導体膜 97 の原子数比はそれぞれ、誤差として上記の原子数比のプラスマイナス 40 % の変動を含む。

【0363】

酸化物半導体膜 97a、97b は、後に形成する酸化物絶縁膜 25 を形成する際の、酸化物半導体膜 17a、17b へのダメージ緩和膜としても機能する。このため、酸化物絶縁膜 23 を設けず、酸化物半導体膜 97a、97b 上に酸化物絶縁膜 25 を形成してもよい。

30

【0364】

酸化物半導体膜 97a、97b の厚さは、3 nm 以上 100 nm 以下、好ましくは 3 nm 以上 50 nm 以下とする。

【0365】

また、酸化物半導体膜 97a、97b は、酸化物半導体膜 17a、17b と同様に、例えば非単結晶構造でもよい。非単結晶構造は、例えば、後述する CAAC - OS (C Axis Aligned Crystalline Oxide Semiconductor)、多結晶構造、後述する微結晶構造、または非晶質構造を含む。

40

【0366】

酸化物半導体膜 97a、97b は、例えば非晶質構造でもよい。非晶質構造の酸化物半導体膜は、例えば、原子配列が無秩序であり、結晶成分を有さない。または、非晶質構造の酸化物膜は、例えば、完全な非晶質構造であり、結晶部を有さない。

【0367】

なお、酸化物半導体膜 17 及び酸化物半導体膜 97 によって、非晶質構造の領域、微結晶構造の領域、多結晶構造の領域、CAAC - OS の領域、単結晶構造の領域の二種以上を有する混合膜を構成してもよい。混合膜は、例えば、非晶質構造の領域、微結晶構造の領域、多結晶構造の領域、CAAC - OS の領域、単結晶構造の領域のいずれか二種以上の領域を有する場合がある。また、混合膜は、例えば、非晶質構造の領域、微結晶構造の

50

領域、多結晶構造の領域、C A A C - O Sの領域、単結晶構造の領域のいずれか二種以上の領域の積層構造を有する場合がある。

【 0 3 6 8 】

ここでは、酸化物半導体膜 1 7 a と酸化物絶縁膜 2 3 の間、及び酸化物半導体膜 1 7 b と酸化物絶縁膜 2 3 の間に、それぞれ酸化物半導体膜 9 7 a 及び酸化物半導体膜 9 7 b が設けられている。このため、酸化物半導体膜 9 7 a 及び酸化物半導体膜 9 7 b と酸化物絶縁膜 2 3 との間において、不純物及び欠陥によりトラップ準位が形成されても、当該トラップ準位が形成される領域と酸化物半導体膜 1 7 a 及び酸化物半導体膜 1 7 b との間には隔たりがある。この結果、酸化物半導体膜 1 7 a 及び酸化物半導体膜 1 7 b を流れる電子がトラップ準位に捕獲されにくく、トランジスタのオン電流を増大させることが可能であると共に、電界効果移動度を高めることができる。また、トラップ準位に電子が捕獲されると、該電子がマイナスの固定電荷となってしまう。この結果、トランジスタのしきい値電圧が変動してしまう。しかしながら、酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b とトラップ準位が形成される領域との間に隔たりがあるため、トラップ準位における電子の捕獲を低減することが可能であり、トランジスタ 1 0 5 a 及びトランジスタ 1 0 5 b におけるしきい値電圧の変動を低減することができる。

10

【 0 3 6 9 】

また、酸化物半導体膜 9 7 a、9 7 b は、外部からの不純物を遮蔽することが可能であるため、外部から酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b へ移動する不純物量を低減することが可能である。また、酸化物半導体膜 9 7 a、9 7 b は、酸素欠損を形成しにくい。これらのため、酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b における不純物濃度及び酸素欠損量を低減することが可能である。

20

【 0 3 7 0 】

なお、酸化物半導体膜 1 7 及び酸化物半導体膜 9 7 は、各膜を単に積層するのではなく連続接合（ここでは特に伝導帯の下端のエネルギーが各膜の間で連続的に変化する構造）が形成されるように作製する。すなわち、各膜の界面において、トラップ中心や再結合中心のような欠陥準位を形成するような不純物が存在しないような積層構造とする。仮に、積層された酸化物半導体膜 1 7 及び酸化物半導体膜 9 7 の間に不純物が混在していると、エネルギーバンドの連続性が失われ、界面でキャリアがトラップされ、あるいは再結合して、消滅してしまう。

30

【 0 3 7 1 】

連続接合を形成するためには、ロードロック室を備えたマルチチャンバー方式の成膜装置（スパッタリング装置）を用いて各膜を大気に触れさせることなく連続して積層することが必要となる。スパッタリング装置における各チャンバーは、酸化物半導体膜にとって不純物となる水等を可能な限り除去すべくクライオポンプのような吸着式の真空排気ポンプを用いて高真空排気（ 5×10^{-7} Pa 乃至 1×10^{-4} Pa 程度まで）することが好ましい。または、ターボ分子ポンプとコールドトラップを組み合わせる排気系からチャンバー内に気体、特に炭素または水素を含む気体が逆流しないようにしておくことが好ましい。

【 0 3 7 2 】

なお、多層膜 9 8 a、9 8 b の代わりに、図 2 1 に示すトランジスタ 1 0 6 a、トランジスタ 1 0 6 b のように、多層膜 9 4 a、9 4 b を有してもよい。トランジスタ 1 0 6 a は、画素の駆動トランジスタとして機能するトランジスタであり、トランジスタ 1 0 6 b は、画素の選択トランジスタとして機能するトランジスタである。

40

【 0 3 7 3 】

多層膜 9 4 a は、酸化物半導体膜 9 9 a、酸化物半導体膜 1 7 a、及び酸化物半導体膜 9 7 a が順に積層されている。また、多層膜 9 4 b は、酸化物半導体膜 9 9 b、酸化物半導体膜 1 7 b、及び酸化物半導体膜 9 7 b が順に積層されている。即ち、多層膜 9 4 a 及び多層膜 9 4 b は 3 層構造である。なお、多層膜 9 4 a と多層膜 9 4 b とは、同一の工程によって形成される。また、トランジスタ 1 0 6 a では、酸化物半導体膜 1 7 a がチャネ

50

ル領域として機能し、トランジスタ 106b では、酸化物半導体膜 17b がチャネル領域として機能する。

【0374】

また、トランジスタ 106a 及びトランジスタ 106b において、絶縁膜 15 と、酸化物半導体膜 99a 及び酸化物半導体膜 99b とがそれぞれが接する。即ち、絶縁膜 15 と酸化物半導体膜 17a 又は酸化物半導体膜 17b との間に、酸化物半導体膜 99a 又は酸化物半導体膜 99b が設けられている。

【0375】

また、酸化物半導体膜 97a 及び酸化物半導体膜 97b と、酸化物絶縁膜 23 とがそれぞれ接する。即ち、酸化物半導体膜 17a 又は酸化物半導体膜 17b と酸化物絶縁膜 23 との間に、酸化物半導体膜 97a 又は酸化物半導体膜 97b が設けられている。

10

【0376】

酸化物半導体膜 99a、99b に適用される酸化物半導体膜（以下、酸化物半導体膜 99）には、酸化物半導体膜 97 と同様の材料及び形成方法を適宜用いることができる。

【0377】

酸化物半導体膜 99a 及び酸化物半導体膜 99b はそれぞれ、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b より膜厚が小さいと好ましい。酸化物半導体膜 99a 及び酸化物半導体膜 99b の厚さを 1nm 以上 5nm 以下、好ましくは 1nm 以上 3nm 以下とすることで、トランジスタのしきい値電圧の変動量を低減することが可能である。

【0378】

20

なお、トランジスタ 105a 及びトランジスタ 105b と同様に、トランジスタ 106a 及びトランジスタ 106b に含まれる酸化物半導体膜 97a、97b は、後に形成する酸化物絶縁膜 25 を形成する際の、酸化物半導体膜 17a、17b へのダメージ緩和膜としても機能する。このため、酸化物絶縁膜 23 を設けず、酸化物半導体膜 97a、97b 上に酸化物絶縁膜 25 を形成してもよい。

【0379】

本実施の形態に示すトランジスタは、チャネルが形成される酸化物半導体膜である酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b と酸化物絶縁膜 23 との間に、酸化物半導体膜 97a 及び酸化物半導体膜 97b がそれぞれ設けられている。このため、酸化物半導体膜 97a 及び酸化物半導体膜 97b と酸化物絶縁膜 23 の間において、不純物及び欠陥によりトラップ準位が形成されても、当該トラップ準位が形成される領域と酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b との間には隔たりがある。この結果、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b を流れる電子がトラップ準位に捕獲されにくく、トランジスタのオン電流を増大させることが可能であると共に、電界効果移動度を高めることができる。また、トラップ準位に電子が捕獲されると、該電子がマイナスの固定電荷となってしまう。この結果、トランジスタのしきい値電圧が変動してしまう。しかしながら、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b とトラップ準位が形成される領域との間に隔たりがあるため、トラップ準位に捕獲される電子の数を低減することが可能であり、しきい値電圧の変動を低減することができる。

30

【0380】

40

また、酸化物半導体膜 97a 及び酸化物半導体膜 97b は、不純物の侵入をブロックする機能を有し、外部から酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b へ侵入する不純物量を低減することが可能である。また、酸化物半導体膜 97a 及び酸化物半導体膜 97b は、酸素欠損を形成しにくい。上記の理由から、本実施の形態に示すトランジスタは、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b における不純物濃度及び酸素欠損量を低減することが可能である。

【0381】

また、絶縁膜 15 と酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b との間に、それぞれ酸化物半導体膜 99a 及び酸化物半導体膜 99b が設けられており、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 17b と酸化物絶縁膜 23 との間に、それぞれ酸化物半導体膜 9

50

7 a 及び酸化物半導体膜 9 7 b が設けられている。そのため、酸化物半導体膜 9 9 a、9 9 b と酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b との界面近傍におけるシリコンや炭素の濃度、酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b におけるシリコンや炭素の濃度、または酸化物半導体膜 9 7 a、9 7 b と酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b との界面近傍におけるシリコンや炭素の濃度を低減することができる。

【0382】

このような構造を有する本実施の形態に係るトランジスタは、チャンネルが形成される酸化物半導体膜を含む多層膜において欠陥が極めて少ないため、トランジスタの電気特性を向上させることが可能であり、代表的には、オン電流の増大及び電界効果移動度の向上が可能である。また、ストレス試験の一例である B T ストレス試験及び光 B T ストレス試験におけるしきい値電圧の変動量が少なく、信頼性が高い。

10

【0383】

<トランジスタのバンド構造>

次に、図 2 0 (A 1)、図 2 0 (B)、及び図 2 0 (C 1) に示すトランジスタ 1 0 5 a に設けられる多層膜 9 8 a、及び図 2 1 に示すトランジスタ 1 0 6 a に設けられる多層膜 9 4 a のバンド構造について、図 2 2 を用いて説明する。なお、トランジスタ 1 0 5 b に設けられる多層膜 9 8 b は、多層膜 9 8 a と同様の構成を有する。また、トランジスタ 1 0 6 b に設けられる多層膜 9 4 b は多層膜 9 4 a と同様の構成を有する。したがって、以下の説明において、多層膜 9 8 a は多層膜 9 8 b と読み替えることが可能であり、多層膜 9 4 a は多層膜 9 4 b と読み替えることが可能である。

20

【0384】

ここでは、例として、酸化物半導体膜 1 7 a としてエネルギーギャップが 3 . 1 5 e V である In - Ga - Zn 酸化物を用い、酸化物半導体膜 9 7 a としてエネルギーギャップが 3 . 5 e V である In - Ga - Zn 酸化物とする。エネルギーギャップは、分光エリブソメータ (H O R I B A J O B I N Y V O N 社 U T - 3 0 0) を用いて測定した。

【0385】

酸化物半導体膜 1 7 a 及び酸化物半導体膜 9 7 a の真空準位と価電子帯上端のエネルギー差 (イオン化ポテンシャルともいう。) は、それぞれ 8 e V 及び 8 . 2 e V であった。なお、真空準位と価電子帯上端のエネルギー差は、紫外線光電子分光分析 (U P S : U l t r a v i o l e t P h o t o e l e c t r o n S p e c t r o s c o p y) 装置 (P H I 社 V e r s a P r o b e) を用いて測定した。

30

【0386】

したがって、酸化物半導体膜 1 7 a 及び酸化物半導体膜 9 7 a の真空準位と伝導帯下端のエネルギー差 (電子親和力ともいう。) は、それぞれ 4 . 8 5 e V 及び 4 . 7 e V であった。

【0387】

図 2 2 (A) は、多層膜 9 8 a のバンド構造の一部を模式的に示している。ここでは、絶縁膜 1 5 及び酸化物絶縁膜 2 3 を酸化シリコン膜とし、多層膜 9 8 a と酸化シリコン膜を接して設けた場合について説明する。なお、図 2 2 (A) に表す E c I 1 は酸化シリコン膜の伝導帯下端のエネルギーを示し、E c S 1 は酸化物半導体膜 1 7 a の伝導帯下端のエネルギーを示し、E c S 2 は酸化物半導体膜 9 7 a の伝導帯下端のエネルギーを示し、E c I 2 は酸化シリコン膜の伝導帯下端のエネルギーを示す。また、E c I 1 は、図 2 0 (B) に示す絶縁膜 1 5 に相当し、E c I 2 は、図 2 0 (B) に示す酸化物絶縁膜 2 3 に相当する。

40

【0388】

図 2 2 (A) に示すように、酸化物半導体膜 1 7 a 及び酸化物半導体膜 9 7 a において、伝導帯下端のエネルギーは障壁が無くなだらかに変化する。換言すると、連続的に変化するともいうことができる。これは、多層膜 9 8 a は、酸化物半導体膜 1 7 a と共通の元素を含み、酸化物半導体膜 1 7 a 及び酸化物半導体膜 9 7 a の間で、酸素が相互に移動することで混合層が形成されるためであるといえることができる。

50

【0389】

図22(A)より、多層膜98aの酸化物半導体膜17aがウェル(井戸)となり、多層膜98aを用いたトランジスタにおいて、チャネル領域が酸化物半導体膜17aに形成されることがわかる。なお、多層膜98aは、伝導帯下端のエネルギーが連続的に変化しているため、酸化物半導体膜17aと酸化物半導体膜97aとが連続接合している、ともいえる。

【0390】

なお、図22(A)に示すように、酸化物半導体膜97aと、酸化物絶縁膜23との界面近傍には、不純物や欠陥に起因したトラップ準位が形成され得るものの、酸化物半導体膜97aが設けられることにより、酸化物半導体膜17aと該トラップ準位が形成される領域とを遠ざけることができる。ただし、EcS1とEcS2とのエネルギー差が小さい場合、酸化物半導体膜17aの電子が該エネルギー差を越えてトラップ準位に達することがある。トラップ準位に電子が捕獲されることで、絶縁膜表面にマイナスの固定電荷が生じ、トランジスタのしきい値電圧はプラス方向にシフトしてしまう。したがって、EcS1とEcS2とのエネルギー差を、0.1eV以上、好ましくは0.15eV以上とすると、トランジスタのしきい値電圧の変動が低減され、安定した電気特性となるため好適である。

【0391】

また、図22(B)は、多層膜98aのバンド構造の一部を模式的に示し、図22(A)に示すバンド構造の変形例である。ここでは、絶縁膜15及び酸化物絶縁膜23を酸化シリコン膜とし、多層膜98aと酸化シリコン膜を接して設けた場合について説明する。なお、図22(B)に表すEcI1は酸化シリコン膜の伝導帯下端のエネルギーを示し、EcS1は酸化物半導体膜17aの伝導帯下端のエネルギーを示し、EcI2は酸化シリコン膜の伝導帯下端のエネルギーを示す。また、EcI1は、図20(B)に示す絶縁膜15に相当し、EcI2は、図20(B)に示す酸化物絶縁膜23に相当する。

【0392】

図20(B)に示すトランジスタにおいて、一対の電極20a、20bの形成時に多層膜98aの上方、すなわち酸化物半導体膜97aがエッチングされる場合がある。一方、酸化物半導体膜17aの上面は、酸化物半導体膜97aの成膜時に酸化物半導体膜17aと酸化物半導体膜97aの混合層が形成される場合がある。

【0393】

例えば、酸化物半導体膜17aが、In:Ga:Zn=1:1:1[原子数比]のIn-Ga-Zn酸化物、またはIn:Ga:Zn=3:1:2[原子数比]のIn-Ga-Zn酸化物をスパッタリングターゲットに用いて成膜した酸化物半導体膜であり、酸化物半導体膜97aが、In:Ga:Zn=1:3:2[原子数比]のIn-Ga-Zn酸化物、In:Ga:Zn=1:3:4[原子数比]のIn-Ga-Zn酸化物、またはIn:Ga:Zn=1:3:6[原子数比]のIn-Ga-Zn酸化物をスパッタリングターゲットに用いて成膜した酸化物半導体膜である場合、酸化物半導体膜17aよりも酸化物半導体膜97aのGaの含有量が多いため、酸化物半導体膜17aの上面には、GaO_x層または酸化物半導体膜17aよりもGaを多く含む混合層が形成されうる。

【0394】

したがって、酸化物半導体膜97aがエッチングされた場合においても、EcS1のEcI2側の伝導帯下端のエネルギーが高くなり、図22(B)に示すバンド構造のようになる場合がある。

【0395】

図22(B)に示すバンド構造のようになる場合、チャネル領域の断面観察時において、多層膜98aは、酸化物半導体膜17aのみと見かけ上観察される場合がある。しかしながら、実質的には、酸化物半導体膜17a上には、酸化物半導体膜17aよりもGaを多く含む混合層が形成されているため、該混合層を1.5番目の層として、捉えることができる。なお、該混合層は、例えば、EDX分析等によって、多層膜98aに含有する元

10

20

30

40

50

素を測定した場合、酸化物半導体膜 17a の上方の組成を分析することで確認することができる。例えば、酸化物半導体膜 17a の上方の組成が、酸化物半導体膜 17a 中の組成よりも Ga の含有量が多い構成となることで確認することができる。

【0396】

図 22 (C) は、図 21 に示す多層膜 94a のバンド構造の一部を模式的に示している。ここでは、絶縁膜 15 及び酸化物絶縁膜 23 を酸化シリコン膜とし、多層膜 94a と酸化シリコン膜を接して設けた場合について説明する。なお、図 22 (C) に表す EcI1 は酸化シリコン膜の伝導帯下端のエネルギーを示し、EcS1 は酸化物半導体膜 17a の伝導帯下端のエネルギーを示し、EcS2 は酸化物半導体膜 97a の伝導帯下端のエネルギーを示し、EcS3 は酸化物半導体膜 99a の伝導帯下端のエネルギーを示し、EcI2 は酸化シリコン膜の伝導帯下端のエネルギーを示す。また、EcI1 は、図 21 に示す絶縁膜 15 に相当し、EcI2 は、図 21 に示す酸化物絶縁膜 23 に相当する。

10

【0397】

図 22 (C) に示すように、酸化物半導体膜 99a、酸化物半導体膜 17a、及び酸化物半導体膜 97a において、伝導帯下端のエネルギーは障壁が無くなだらかに変化する。換言すると、連続的に変化するともいうことができる。これは、多層膜 94a は、酸化物半導体膜 17a と共通の元素を含み、酸化物半導体膜 17a 及び酸化物半導体膜 97 の間で、酸素が相互に移動することで混合層が形成されるためであるといえることができる。

【0398】

図 22 (C) より、多層膜 94a の酸化物半導体膜 17a がウェル (井戸) となり、多層膜 94a を用いたトランジスタにおいて、チャンネル領域が酸化物半導体膜 17a に形成されることがわかる。なお、多層膜 94a は、伝導帯下端のエネルギーが連続的に変化しているため、酸化物半導体膜 99a と、酸化物半導体膜 17a と、酸化物半導体膜 97a とが連続接合している、ともいえる。

20

【0399】

なお、多層膜 94a と、酸化物絶縁膜 23 との界面近傍、多層膜 94a と、絶縁膜 15 との界面近傍には、不純物や欠陥に起因したトラップ準位が形成され得るものの、図 22 (C) に示すように、酸化物半導体膜 97a、99a が設けられることにより、酸化物半導体膜 17a と該トラップ準位が形成される領域とを遠ざけることができる。ただし、EcS1 と EcS2 とのエネルギー差、及び EcS1 と EcS3 とのエネルギー差が小さい場合、酸化物半導体膜 17a の電子が該エネルギー差を越えてトラップ準位に達することがある。トラップ準位に電子が捕獲されることで、絶縁膜表面にマイナスの固定電荷が生じ、トランジスタのしきい値電圧はプラス方向にシフトしてしまう。したがって、EcS1 と EcS2 とのエネルギー差、及び EcS1 と EcS3 とのエネルギー差を、0.1 eV 以上、好ましくは 0.15 eV 以上とすると、トランジスタのしきい値電圧の変動が低減され、安定した電気特性となるため好適である。

30

【0400】

なお、本実施の形態に示す構成及び方法などは、他の実施の形態に示す構成及び方法などと適宜組み合わせる用いることができる。

【0401】

40

(実施の形態 6)

本実施の形態では、上記実施の形態で説明した半導体装置に含まれているトランジスタにおいて、酸化物半導体膜に適用可能な一態様について説明する。

【0402】

酸化物半導体膜は、CAAC-OS 膜で構成されていることが好ましい。CAAC-OS 膜は、c 軸配向性を有する結晶を備えるが、該結晶の、明確な結晶粒界 (グレインバウンダリーともいう。)を確認することができない。c 軸配向性を有する結晶はエッチングされにくく、チャンネルエッチ型のトランジスタにおいて、一対の電極を形成する際の酸化物半導体膜のオーバーエッチング量が少ない。この結果、酸化物半導体膜を CAAC-OS 膜で構成することで、チャンネルエッチ型のトランジスタを作製することができる。特に、

50

駆動トランジスタに用いるチャネルエッチ型のトランジスタは、一対の電極の間隔、即ちチャネル長を、 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $4.5\text{ }\mu\text{m}$ 以下と小さくすることが可能である。

【0403】

また、酸化物半導体膜は、単結晶構造の酸化物半導体（以下、単結晶酸化物半導体という。）、多結晶構造の酸化物半導体（以下、多結晶酸化物半導体という。）、微結晶構造の酸化物半導体（以下、微結晶酸化物半導体という。）、及び非晶質構造の酸化物半導体（以下、非晶質酸化物半導体という。）の一以上で構成されてもよい。以下に、CAAC-OS、単結晶酸化物半導体、多結晶酸化物半導体、微結晶酸化物半導体、非晶質酸化物半導体について説明する。

【0404】

<CAAC-OS>

CAAC-OS膜は、複数の結晶部を有する酸化物半導体膜の一つである。また、CAAC-OS膜に含まれる結晶部は、c軸配向性を有する。平面TEM像において、CAAC-OS膜に含まれる結晶部の面積が 2500 nm^2 以上、さらに好ましくは $5\text{ }\mu\text{m}^2$ 以上、さらに好ましくは $1000\text{ }\mu\text{m}^2$ 以上である。また、断面TEM像において、該結晶部を50%以上、好ましくは80%以上、さらに好ましくは95%以上有することで、単結晶に近い物性の薄膜となる。

【0405】

CAAC-OS膜を透過型電子顕微鏡（TEM：Transmission Electron Microscope）によって観察すると、明確な結晶部同士の境界、即ち結晶粒界（グレインバウンダリーともいう。）を確認することができない。そのため、CAAC-OS膜は、結晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。

【0406】

CAAC-OS膜を、試料面と概略平行な方向からTEMによって観察（断面TEM観察）すると、結晶部において、金属原子が層状に配列していることを確認できる。金属原子の各層は、CAAC-OS膜の膜を形成する面（被形成面ともいう。）または上面の凹凸を反映した形状であり、CAAC-OS膜の被形成面または上面と平行に配列する。なお、本明細書において、「平行」とは、二つの直線が -10° 以上 10° 以下の角度で配置されている状態をいう。従って、 -5° 以上 5° 以下の場合も含まれる。また、「垂直」とは、二つの直線が 80° 以上 100° 以下の角度で配置されている状態をいう。従って、 85° 以上 95° 以下の場合も含まれる。

【0407】

一方、CAAC-OS膜を、試料面と概略垂直な方向からTEMによって観察（平面TEM観察）すると、結晶部において、金属原子が三角形または六角形状に配列していることを確認できる。しかしながら、異なる結晶部間で、金属原子の配列に規則性は見られない。

【0408】

なお、CAAC-OS膜に対し、電子線回折を行うと、配向性を示すスポット（輝点）が観測される。

【0409】

断面TEM観察および平面TEM観察より、CAAC-OS膜の結晶部は配向性を有していることがわかる。

【0410】

CAAC-OS膜に対し、X線回折（XRD：X-Ray Diffraction）装置を用いて構造解析を行うと、CAAC-OS膜のout-of-plane法による解析では、回折角（ 2θ ）が 31° 近傍にピークが現れる場合がある。このピークは、InGaZn酸化物の結晶の（00x）面（xは整数）に帰属されることから、CAAC-OS膜の結晶がc軸配向性を有し、c軸が被形成面または上面に概略垂直な方向を向いていることが確認できる。

【0411】

一方、C A A C - O S 膜に対し、c 軸に概略垂直な方向から X 線を入射させる *i n - p l a n e* 法による解析では、 2θ が 56° 近傍にピークが現れる場合がある。このピークは、I n G a Z n 酸化物の結晶の (1 1 0) 面に帰属される。I n G a Z n 酸化物の単結晶酸化物半導体膜であれば、 2θ を 56° 近傍に固定し、試料面の法線ベクトルを軸 (軸) として試料を回転させながら分析 (スキャン) を行くと、(1 1 0) 面と等価な結晶面に帰属されるピークが 6 本観察される。これに対し、C A A C - O S 膜の場合は、 2θ を 56° 近傍に固定して スキャンした場合でも、明瞭なピークが現れない。

【 0 4 1 2 】

以上のことから、C A A C - O S 膜では、異なる結晶部間では a 軸および b 軸の配向は不規則であるが、c 軸配向性を有し、かつ c 軸が被形成面または上面の法線ベクトルに平行な方向を向いていることがわかる。従って、前述の断面 T E M 観察で確認された層状に配列した金属原子の各層は、結晶の a - b 面に平行な面である。

10

【 0 4 1 3 】

なお、結晶部は、C A A C - O S 膜を成膜した際、または加熱処理などの結晶化処理を行った際に形成される。上述したように、結晶部の c 軸は、C A A C - O S 膜の被形成面または上面の法線ベクトルに平行な方向に配向する。従って、例えば、C A A C - O S 膜の形状をエッチングなどによって変化させた場合、結晶部の c 軸が C A A C - O S 膜の被形成面または上面の法線ベクトルと平行にならないこともある。

【 0 4 1 4 】

また、C A A C - O S 膜中の結晶化度が均一でなくてもよい。例えば、C A A C - O S 膜の結晶部が、C A A C - O S 膜の上面近傍からの結晶成長によって形成される場合、上面近傍の領域は、被形成面近傍の領域よりも結晶化度が高くなることがある。また、C A A C - O S 膜に不純物を添加する場合、不純物が添加された領域の結晶化度が変化し、部分的に結晶化度の異なる領域が形成されることもある。

20

【 0 4 1 5 】

なお、C A A C - O S 膜の *o u t - o f - p l a n e* 法による解析では、 2θ が 31° 近傍のピークの他に、 2θ が 36° 近傍にもピークが現れる場合がある。 2θ が 36° 近傍のピークは、C A A C - O S 膜中の一部に、c 軸配向性を有さない結晶部が含まれることを示している。C A A C - O S 膜は、 2θ が 31° 近傍にピークを示し、 2θ が 36° 近傍にピークを示さないことが好ましい。

30

【 0 4 1 6 】

C A A C - O S 膜は、不純物濃度の低い酸化物半導体膜である。不純物は、水素、炭素、シリコン、遷移金属元素などの酸化物半導体膜の主成分以外の元素である。特に、シリコンなどの、酸化物半導体膜を構成する金属元素よりも酸素との結合力の強い元素は、酸化物半導体膜から酸素を奪うことで酸化物半導体膜の原子配列を乱し、結晶性を低下させる要因となる。また、鉄やニッケルなどの重金属、アルゴン、二酸化炭素などは、原子半径 (または分子半径) が大きいため、酸化物半導体膜内部に含まれると、酸化物半導体膜の原子配列を乱し、結晶性を低下させる要因となる。なお、酸化物半導体膜に含まれる不純物は、キャリアトラップやキャリア発生源となる場合がある。

【 0 4 1 7 】

また、C A A C - O S 膜は、欠陥準位密度の低い酸化物半導体膜である。例えば、酸化物半導体膜中の酸素欠損は、キャリアトラップとなることや、水素を捕獲することによってキャリア発生源となることがある。

40

【 0 4 1 8 】

不純物濃度が低く、欠陥準位密度が低い (酸素欠損の少ない) ことを、高純度真性または実質的に高純度真性と呼ぶ。高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜は、キャリア発生源が少ないため、キャリア密度を低くすることができる。従って、当該酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、しきい値電圧がマイナスとなる電気特性 (ノーマリーオンともいう。) になることが少ない。また、高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜は、キャリアトラップが少ない。そのため、当該酸化物半導体

50

膜を用いたトランジスタは、電気特性の変動が小さく、信頼性の高いトランジスタとなる。なお、酸化物半導体膜のキャリアトラップに捕獲された電荷は、放出するまでに要する時間が長く、あたかも固定電荷のように振る舞うことがある。そのため、不純物濃度が高く、欠陥準位密度が高い酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、電気特性が不安定となる場合がある。

【0419】

また、CAAC-OS膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性の変動が小さい。

【0420】

<単結晶酸化物半導体>

単結晶酸化物半導体膜は、不純物濃度が低く、欠陥準位密度が低い（酸素欠損が少ない）酸化物半導体膜である。そのため、キャリア密度を低くすることができる。従って、単結晶酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、ノーマリーオンの電気特性になることが少ない。また、単結晶酸化物半導体膜は、不純物濃度が低く、欠陥準位密度が低いため、キャリアトラップが少なくなる場合がある。従って、単結晶酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、電気特性の変動が小さく、信頼性の高いトランジスタとなる。

【0421】

なお、酸化物半導体膜は、欠陥が少ないと密度が高くなる。また、酸化物半導体膜は、結晶性が高いと密度が高くなる。また、酸化物半導体膜は、水素などの不純物濃度が低いと密度が高くなる。単結晶酸化物半導体膜は、CAAC-OS膜よりも密度が高い。また、CAAC-OS膜は、微結晶酸化物半導体膜よりも密度が高い。また、多結晶酸化物半導体膜は、微結晶酸化物半導体膜よりも密度が高い。また、微結晶酸化物半導体膜は、非晶質酸化物半導体膜よりも密度が高い。

【0422】

<多結晶酸化物半導体>

多結晶酸化物半導体膜は、TEMによる観察像で、結晶粒を確認することができる。多結晶酸化物半導体膜に含まれる結晶粒は、例えば、TEMによる観察像で、2 nm以上300 nm以下、3 nm以上100 nm以下または5 nm以上50 nm以下の粒径であることが多い。また、多結晶酸化物半導体膜は、TEMによる観察像で、結晶粒界を確認できる場合がある。

【0423】

多結晶酸化物半導体膜は、複数の結晶粒を有し、当該複数の結晶粒間において結晶の方位が異なっている場合がある。また、多結晶酸化物半導体膜に対し、XRD装置を用いて構造解析を行うと、例えばInGaZn酸化物の結晶を有する多結晶酸化物半導体膜のout-of-plane法による解析では、2θが31°近傍のピーク、2θが36°近傍のピーク、またはそのほかのピークが現れる場合がある。

【0424】

多結晶酸化物半導体膜は、高い結晶性を有するため、高い電子移動度を有する場合がある。従って、多結晶酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、高い電界効果移動度を有する。ただし、多結晶酸化物半導体膜は、結晶粒界に不純物が偏析する場合がある。また、多結晶酸化物半導体膜の結晶粒界は欠陥準位となる。多結晶酸化物半導体膜は、結晶粒界がキャリアトラップやキャリア発生源となる場合があるため、多結晶酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、CAAC-OS膜を用いたトランジスタと比べて、電気特性の変動が大きく、信頼性の低いトランジスタとなる場合がある。

【0425】

<微結晶酸化物半導体>

微結晶酸化物半導体膜は、TEMによる観察像では、明確に結晶部を確認することができない場合がある。微結晶酸化物半導体膜に含まれる結晶部は、1 nm以上100 nm以下、または1 nm以上10 nm以下の大きさであることが多い。特に、1 nm以上10 nm以下、または1 nm以上3 nm以下の微結晶であるナノ結晶(nc: nanocrystalline)である場合がある。

t a l) を有する酸化物半導体膜を、n c - O S (n a n o c r y s t a l l i n e O x i d e S e m i c o n d u c t o r) 膜と呼ぶ。また、n c - O S 膜は、例えば、T E M による観察像では、結晶粒界を明確に確認できない場合がある。

【 0 4 2 6 】

n c - O S 膜は、微小な領域（例えば、1 n m 以上 1 0 n m 以下の領域、特に 1 n m 以上 3 n m 以下の領域）において原子配列に周期性を有する。また、n c - O S 膜は、異なる結晶部間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、膜全体で配向性が見られない。従って、n c - O S 膜は、分析方法によっては、非晶質酸化物半導体膜と区別が付かない場合がある。例えば、n c - O S 膜に対し、結晶部よりも大きい径の X 線を用いる X R D 装置を用いて構造解析を行うと、o u t - o f - p l a n e 法による解析では、結晶面を示すピークが検出されない。また、n c - O S 膜は、結晶部よりも大きい径（例えば 5 0 n m 以上）の電子線を用いる電子線回折（制限視野電子線回折ともいう。）を行うと、ハローパターンのような回折パターンが観測される。一方、n c - O S 膜は、結晶部の大きさと近い結晶部より小さい径（例えば 1 n m 以上 3 0 n m 以下）の電子線を用いる電子線回折（ナノビーム電子線回折ともいう。）を行うと、スポットが観測される。また、n c - O S 膜のナノビーム電子線回折を行うと、円を描くように（リング状に）輝度の高い領域が観測される場合がある。また、n c - O S 膜のナノビーム電子線回折を行うと、リング状の領域内に複数のスポットが観測される場合がある。

10

【 0 4 2 7 】

n c - O S 膜は、非晶質酸化物半導体膜よりも規則性の高い酸化物半導体膜である。そのため、n c - O S 膜は、非晶質酸化物半導体膜よりも欠陥準位密度が低くなる。ただし、n c - O S 膜は、異なる結晶部間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、n c - O S 膜は、C A A C - O S 膜と比べて欠陥準位密度が高くなる。

20

【 0 4 2 8 】

なお、本実施の形態に示す構成及び方法などは、他の実施の形態に示す構成及び方法などと適宜組み合わせ用いることができる。

【 0 4 2 9 】

（実施の形態 7）

実施の形態 1 乃至実施の形態 6 に示す表示装置の作製方法において、酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b 上に電極 2 0 a 乃至 2 0 d を形成した後、酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b を酸化雰囲気で発生させたプラズマに曝し、酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b に酸素を供給することができる。酸化雰囲気としては、酸素、オゾン、一酸化二窒素、二酸化窒素等の雰囲気がある。さらに、当該プラズマ処理において、基板 1 1 側にバイアスを印加しない状態で発生したプラズマに酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b を曝すことが好ましい。この結果、酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b にダメージを与えず、且つ酸素を供給することが可能であり、酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b に含まれる酸素欠損量を低減することができる。また、エッチング処理により酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b の表面に残存する不純物、例えば、フッ素、塩素等のハロゲン等を除去することができる。また、当該プラズマ処理を 3 0 0 以上で加熱しながら行うことが好ましい。プラズマ中の酸素と酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b に含まれる水素が結合し、水となる。基板が加熱されているため、当該水は酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b から脱離する。この結果、酸化物半導体膜 1 7 a、1 7 b に含まれる水素及び水の含有量を低減することができる。

30

40

【 0 4 3 0 】

なお、本実施の形態に示す構成及び方法などは、他の実施の形態に示す構成及び方法などと適宜組み合わせ用いることができる。

【 0 4 3 1 】

（実施の形態 8）

本実施の形態では、本発明の一態様の表示装置に含まれる画素の構成について、図面を用いて説明する。なお、先の実施の形態に示す符号と同様の箇所、または同様の機能を有する部分については、同様の符号を付し、その詳細の説明は省略する。

50

【0432】

図23は、表示装置の画素に用いることができる回路構成の一例を示している。

【0433】

図23に示す画素603は、データ信号のデータ書き込みを制御する選択トランジスタとして機能するトランジスタ300bと、駆動トランジスタとして機能するトランジスタ300aと、トランジスタ300cと、容量素子370と、発光素子350と、を有する。

【0434】

トランジスタ300aのソース電極及びドレイン電極の一方は、アノード線として機能する配線ANO1と電氣的に接続され、トランジスタ300aのソース電極及びドレイン電極の他方は、発光素子350の一方の電極に電氣的に接続される。さらにトランジスタ300aのゲート電極は、トランジスタ300bのソース電極及びドレイン電極の一方、及び容量素子370の一方の電極に電氣的に接続される。

10

【0435】

トランジスタ300aは、オン状態又はオフ状態になることにより、発光素子350に流れる電流を制御する機能を有する。本実施の形態において、トランジスタ300aは、チャンネル長を $0.5\mu\text{m}$ 以上 $4.5\mu\text{m}$ 以下とし、且つ、酸化物半導体膜の上層及び下層にそれぞれ配置され、互いに電氣的に接続された第1のゲート電極及び第2のゲート電極を有する。すなわち、トランジスタ300aは、オン電流及び電界効果移動度が向上し、且つしきい値電圧のマイナス方向への変動が抑制されたトランジスタである。

20

【0436】

トランジスタ300bのソース電極及びドレイン電極の他方は、データ信号が与えられる信号線SLに電氣的に接続される。さらにトランジスタ300bのゲート電極は、ゲート信号が与えられる走査線GLに電氣的に接続される。

【0437】

トランジスタ300bは、オン状態又はオフ状態となることにより、データ信号の書き込みを制御する機能を有する。すなわち、トランジスタ300bは、選択トランジスタとしての機能を有する。

【0438】

本実施の形態において、トランジスタ300bのチャンネル長は、トランジスタ300aのチャンネル長よりも大きい。トランジスタ300bはしきい値電圧のマイナス方向への変動(シフト)を抑制されたトランジスタであり、カットオフ電流の値が小さい。

30

【0439】

トランジスタ300cのソース電極及びドレイン電極の一方は、データの基準電位が与えられる配線MLと接続され、トランジスタ300cのソース電極及びドレイン電極の他方は、発光素子350の一方の電極、及び容量素子370の他方の電極に電氣的に接続される。さらに、トランジスタ300cのゲート電極は、ゲート信号が与えられる走査線GLに電氣的に接続される。

【0440】

トランジスタ300cは、発光素子350に流れる電流を調整する機能を有する。例えば、トランジスタ300aのしきい値電圧や電界効果移動度のばらつき、又はトランジスタ300aが劣化した場合に配線MLに流れる電流をモニタリングすることで、発光素子350に流れる電流を補正することができる。配線MLに与えられる電位としては、例えば、発光素子350のしきい値電圧以下の電圧とすることができる。

40

【0441】

本実施の形態において、トランジスタ300cのチャンネル長は、例えば、トランジスタ300aのチャンネル長よりも大きくすることが好ましい。なお、トランジスタ300cはシングルゲート構造としてもよいし、トランジスタ300aと同様にデュアルゲート構造としてもよい。ただし、トランジスタ300cをシングルゲート構造とすると、第1のゲート電極と第2のゲート電極を接続するための領域を削除することができるため、トラン

50

ジスタの面積を縮小することができる。これによって、画素の開口率を増加させることができるため、好ましい。

【0442】

容量素子370の一对の電極の一方は、トランジスタ300bのソース電極及びドレイン電極の一方、及びトランジスタ300aのゲート電極と電氣的に接続され、容量素子370の一对の電極の他方は、トランジスタ300cのソース電極及びドレイン電極の他方、及び発光素子350の一方の電極に電氣的に接続される。

【0443】

図23に示す画素603の構成において、容量素子370は、書き込まれたデータを保持する保持容量としての機能を有する。

10

【0444】

発光素子350の一对の電極の一方は、トランジスタ300aのソース電極及びドレイン電極の他方、容量素子370の他方、及びトランジスタ300cのソース電極及びドレイン電極の他方と電氣的に接続される。また、発光素子350の一对の電極の他方は、カソードとして機能する配線CATに電氣的に接続される。

【0445】

発光素子350としては、例えば、有機エレクトロルミネセンス素子（有機EL素子）、又は無機EL素子を用いることができる。

【0446】

また、配線MLと平行な方向に延伸した配線ANO2が設けられる。配線ANO2は、アノード線として機能する配線ANO1と接続しており、配線ANO1の配線抵抗を低減することが可能である。この結果、大面積基板を用いた表示装置において、配線の電圧降下を低減することが可能であり、表示装置の輝度ムラを低減することができる。

20

【0447】

配線ANO1、ANO2と、配線CATとの一方には、高電源電位VDDが与えられ、他方には低電源電位VSSが与えられる。図23に示す構成においては、配線ANO1、ANO2に高電源電位VDDを、配線CATに低電源電位VSSを、それぞれ与える構成としている。

【0448】

図23の画素603を有する表示装置では、走査線駆動回路により各行の画素603を順次選択し、トランジスタ300bをオン状態にしてデータ信号のデータを書き込む。

30

【0449】

データが書き込まれた画素603は、トランジスタ300bがオフ状態になることで保持状態となる。さらにトランジスタ300bは、容量素子370と接続しているため、書き込まれたデータを長時間保持することが可能となる。また、トランジスタ300aにより、ソース電極とドレイン電極の間に流れる電流量が制御され、発光素子350は、流れる電流量に応じた輝度で発光する。

【0450】

次に、図23に示す画素603に用いることのできる構成について、図16乃至図18を用いて以下説明を行う。

40

【0451】

図16は、画素603に用いることのできる画素回路の上面図の一部を表している。また、図17は、図16に示す一点鎖線X1-X2間の断面を、図18は、図16に示す一点鎖線X3-X4及びX5-X6間の断面を、それぞれ表している。

【0452】

図16において、走査線として機能する配線GLは、信号線に略直交する方向（図中左右方向）に延伸して設けられている。信号線として機能する配線SLは、走査線に略直交する方向（図中上下方向）に延伸して設けられている。データの基準電位が与えられる配線MLは、配線SLと平行方向に延伸して設けられている。アノード線として機能する配線ANO2は、配線SL及び配線MLと平行方向に延伸して設けられている。

50

【0453】

トランジスタ300a、300b、300cは、画素603内に設けられている。なお、トランジスタ300a、300b、300cは、それぞれゲート電極として機能する導電膜と、ゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜上に形成されたチャネル領域が形成される酸化半導体膜と、一対の電極として機能する導電膜により構成される。例えば、トランジスタ300aにおいては、ゲート電極13aと、ゲート絶縁膜（図示しない）と、酸化半導体膜17aと、電極20a、20bにより構成される。

【0454】

また、トランジスタ300bにおいては、ゲート電極13bと、ゲート絶縁膜（図示しない）と、酸化半導体膜17bと、電極20c、20dにより構成される。

10

【0455】

なお、トランジスタ300cの構成については、特に言及しないが、トランジスタ300bに示す構成と同様の構成とすることができる。

【0456】

また、電極13cは、開口部352aにおいて、電極20aと電氣的に接続されている。また、電極20bは、開口部354、356bにおいて、画素電極322と電氣的に接続されている。また、電極13dは、開口部352b及び開口部352cにおいて、電極20eと電氣的に接続されている。

【0457】

また、電極20bの下方には、ゲート電極13aが形成されている。電極20bと、ゲート電極13a上に形成される誘電膜と、ゲート電極13aによって、容量素子が形成される。該容量素子は、図23に示す容量素子370に相当する。

20

【0458】

次に、図16に示す一点鎖線X1-X2間、一点鎖線X3-X4間及び一点鎖線X5-X6間の断面について、図17及び図18を用いて説明する。

【0459】

図17及び図18に示す画素は、基板11と、基板11上のゲート電極13a、13b及び電極13c、13dと、基板11、ゲート電極13a、13b及び電極13c、13d上に形成された絶縁膜306a、306bと、絶縁膜306b上の酸化半導体膜17a、17bと、酸化半導体膜17a、17b上にそれぞれ設けられた一対の電極20a、20b及び一対の電極20c、20dと、電極20a乃至20dと同一の工程で形成された電極20eと、酸化半導体膜17a、17b、及び電極20a乃至20e上に形成された酸化絶縁膜314と、酸化絶縁膜314上に形成された窒化物絶縁膜316と、窒化物絶縁膜316上に設けられ、且つ酸化半導体膜17aと重畳する位置に形成されたゲート電極320と、窒化物絶縁膜316上に設けられ、且つ酸化半導体膜17aと重畳する位置に開口部356aが設けられた絶縁膜318と、ゲート電極320と同一工程で形成され、絶縁膜318上に形成された画素電極322と、トランジスタ、及び画素電極322の端部を覆うように形成された絶縁膜324と、を有する。

30

【0460】

また、絶縁膜306a、306bは、トランジスタ300a、トランジスタ300bのゲート絶縁膜（トランジスタ300aにおいては第1のゲート絶縁膜）として機能し、酸化絶縁膜314及び窒化物絶縁膜316は、トランジスタ300aの第2のゲート絶縁膜として機能する。

40

【0461】

また、電極20b及びゲート電極13aに挟持された領域においては、絶縁膜306a、306bは誘電体としての機能を有する。すなわち、電極20b、絶縁膜306a、306b、及びゲート電極13aは容量素子を形成する。

【0462】

また、画素電極322及び絶縁膜324上には、EL層326が形成され、EL層326上には電極328が形成される。また、画素電極322と、EL層326と、電極32

50

8によって、発光素子350が形成されている。EL層326は、少なくとも発光性の物質が含まれる発光層が形成されていればよく、該発光層以外に、ホール注入層、ホール輸送層、電子輸送層、電子注入層、及び電荷発生層などの機能層が形成されていてもよい。EL層326は、一对の電極(ここでは、画素電極322と電極328)から電子と正孔が注入され電流が流れる。そして、該電子と正孔が再結合することによって発光性の物質が励起状態を形成し、その励起状態が基底状態に戻る際に発光することができる。

【0463】

また、絶縁膜318は、画素電極322の下方に形成される凹凸を平坦化させる機能を有していればよく、例えば、有機絶縁膜等を用いて形成することができる。

【0464】

また、絶縁膜324は、EL層326を隣接する画素間で分離する機能、すなわち隔壁としての機能を有する。絶縁膜324としては、絶縁性を有していればよく、例えば、有機絶縁膜または無機絶縁膜を用いることができる。有機絶縁膜としては、例えば、ポリイミド系樹脂、ポリアミド系樹脂、アクリル系樹脂、シロキサン系樹脂、エポキシ系樹脂、またはフェノール系樹脂等を用いることができる。無機絶縁膜としては、酸化シリコン、酸化窒化シリコン等を用いることができる。特に、感光性の有機樹脂材料を用いることで、絶縁膜324の作製が容易となるため好ましい。

【0465】

また、電極13c上の絶縁膜306a、306bには、開口部352aが形成されている。電極13cは、開口部352aを介して電極20aと接続される。また、電極13d上の絶縁膜306a、306bには、開口部352b、352cが形成されている。電極13dは、開口部352b、352cを介して電極20eと接続される。電極13d上に形成された開口部352b、352cのように、複数の開口部を設けることによって、電極20eと電極13dの接触抵抗を低くすることができる。なお、図18においては、開口部352b、352cの開口部を2つ形成する場合について例示したが、これに限定されず、1つの開口部または3つ以上の複数の開口部を形成してもよい。

【0466】

また、トランジスタ300a上の絶縁膜318には、開口部356aが形成されている。開口部356aを形成することによって、ゲート電極320と、酸化物半導体膜17aの距離を短くすることができる。したがって、ゲート電極320からの電界を酸化物半導体膜17aに好適に印加することができる。

【0467】

また、電極20b上の酸化物絶縁膜314及び窒化物絶縁膜316には、開口部354が形成されている。また、開口部354上の絶縁膜318には開口部356bが形成されている。電極20bは、開口部354、356bを介して、画素電極322と電氣的に接続されている。

【0468】

なお、図17及び図18に示す画素に用いることのできる材料としては、実施の形態1又は実施の形態2に示す記載を援用することができる。

【0469】

なお、本実施の形態に示す構成及び方法などは、他の実施の形態に示す構成及び方法などと適宜組み合わせる用いることができる。

【0470】

(実施の形態9)

本実施の形態では、本発明の一態様であるアクティブマトリクス型表示装置の一例について、図24を用いて説明する。

【0471】

図24(A)は本発明の一態様の表示装置の上面図である。また、図24(B)は、一点鎖線M1-M2およびN1-N2における断面図に相当する。

【0472】

図24(A)、(B)に示すアクティブマトリクス型の表示装置は、支持基板801上に、発光部802、駆動回路部803(ゲート線駆動回路等)、駆動回路部804(信号線駆動回路等)および封止材805を有する。発光部802および駆動回路部803、804は、支持基板801、封止基板806および封止材805で形成された空間810に封止されている。

【0473】

駆動回路部803及び駆動回路部804は、上記実施の形態で説明したトランジスタの構成を用いて形成してもよい。なお、それぞれの駆動回路等を分割し、画素を挟んだ対向側に配置してもよい。

【0474】

図24(B)に示す発光部802は、データ信号のデータの書込を制御する機能を有する選択トランジスタとして機能する第1のトランジスタ(図示しない。)と、発光素子に流れる電流を調整する機能を有する駆動トランジスタとして機能する第2のトランジスタ811と、第2のトランジスタ811の配線(ソース電極またはドレイン電極)に電氣的に接続された第1の電極831とを含む複数の画素により形成されている。

【0475】

発光素子840はトップエミッション(上面射出)構造であり、第1の電極831、EL層833、および第2の電極835によって構成されている。また、第1の電極831の端部を覆って隔壁として機能する絶縁膜839が形成されている。

【0476】

トランジスタ811は、デュアルゲート構造であり、絶縁膜844上に、第1の電極831と同時に形成されるゲート電極832を有する。絶縁膜839の下にトランジスタ811を設けることで、ゲート電極832における外光の反射を低減することができる。

【0477】

支持基板801上には、駆動回路部803、804に外部からの信号(ビデオ信号、クロック信号、スタート信号、またはリセット信号等)や電位を伝達する外部入力端子を接続するための引き出し配線809が設けられる。ここでは、外部入力用の配線としてFPC808(Flexible Printed Circuit)を設ける例を示している。

【0478】

駆動回路部803、804は複数のトランジスタを有する。図24(B)では、駆動回路部803が、nチャネル型のトランジスタ852、853を有するNMOS回路を有する例を示している。駆動回路部の回路は、種々のCMOS回路、PMOS回路またはNMOS回路で形成することができる。また、本実施の形態では、発光部が形成された基板上に駆動回路が形成された駆動回路一体型を示すが、この構成に限定されるものではなく、発光部が形成された基板とは別の基板に駆動回路を形成することもできる。

【0479】

工程数の増加を防ぐため、引き出し配線809は、発光部や駆動回路部に用いる電極や配線と同一の材料、同一の工程で作製することが好ましい。例えば、引き出し配線809を発光部802および駆動回路部803に含まれるトランジスタのゲート電極と同一の材料、同一の工程で作製することができる。

【0480】

支持基板801は表示装置の作製工程に耐えられる程度の耐熱性を備えた基板を用いることができる。当該基板の厚さおよび大きさは製造装置に適用可能であれば特に限定されない。

【0481】

支持基板801はガスバリア性を有すると好ましい。また、ガスバリア性を有する膜を積層して用いても良い。具体的には、ガスバリア性が水蒸気透過率として $10^{-5} \text{ g/m}^2 \cdot \text{day}$ 以下、好ましくは $10^{-6} \text{ g/m}^2 \cdot \text{day}$ 以下であると、表示装置の信頼性を高めることができる。

10

20

30

40

50

【0482】

また、支持基板801は可撓性を有していてもよい。可撓性を有する基板としては、代表的にはプラスチック基板をその例に挙げる事ができる他、厚さが50 μ m以上500 μ m以下の薄いガラスや、金属箔などを用いることもできる。

【0483】

例えば、支持基板801に適用可能な基板としては、無アルカリガラス基板、バリウムホウケイ酸ガラス基板、アルミノホウケイ酸ガラス基板、セラミック基板、石英基板、サファイア基板、金属基板、ステンレス基板、プラスチック基板、ポリエチレンテレフタレート基板、ポリイミド基板等が挙げられる。

【0484】

駆動回路部803が有するトランジスタの構造は特に限定されない。図24(B)に図示したトランジスタは、チャネルエッチ型のボトムゲート構造を一例として示したが、チャネル保護型のボトムゲート構造、セルフアライン型のトップゲート構造またはノンセルフアライン型のトップゲート構造であってもよい。

【0485】

チャネルが形成される領域に酸化物半導体を用いたトランジスタには、極めてオフ電流が低い特性を有するものがある。当該トランジスタを用いると、画素(容量素子)に入力された信号の保持能力が高くなり、例えば静止画表示などにおいてフレーム周波数を小さくすることができる。フレーム周波数を小さくすることによって、表示装置の消費電力を低減させることができる。

【0486】

絶縁膜839は、第1の電極831の端部を覆って設けられている。絶縁膜839は、当該隔壁の上層に形成されるEL層833や第2の電極835の被覆性を向上させるため、端部が曲面となるような形状とすることが好ましい。

【0487】

また、絶縁膜839は、EL層833よりも屈折率の小さい材料を用いることが好ましい。当該材料で絶縁膜839を形成することで、EL層833と絶縁膜839の界面で全反射を起こさせることができ、絶縁膜839中に進入する光を減少させ、光の取り出し効率を向上させることができる。

【0488】

表示装置が備える発光素子は、一对の電極(第1の電極831および第2の電極835)と、当該一对の電極間に設けられたEL層833とを有する。当該一对の電極の一方は陽極として機能し、他方は陰極として機能する。

【0489】

トップエミッション構造の発光素子では、上部電極に可視光に対して透光性を有する導電膜を用いる。また、下部電極には、可視光を反射する導電膜を用いることが好ましい。ボトムエミッション(下面射出)構造の発光素子では、下部電極に可視光に対して透光性を有する導電膜を用いる。また、上部電極には、可視光を反射する導電膜を用いることが好ましい。デュアルエミッション(両面射出)構造の発光素子では、上部電極および下部電極の双方に可視光に対して透光性を有する導電膜を用いる。

【0490】

第1の電極831と第2の電極835の間に、発光素子のしきい値電圧より高い電圧を印加すると、EL層833に第1の電極831側から正孔が注入され、第2の電極835側から電子が注入される。注入された電子と正孔はEL層833において再結合し、EL層833に含まれる発光物質が発光する。

【0491】

EL層833は発光層を有する。EL層833は、発光層以外の層として、正孔注入性の高い物質、正孔輸送性の高い物質、正孔ブロック材料、電子輸送性の高い物質、電子注入性の高い物質、またはバイポーラ性の物質(電子輸送性および正孔輸送性が高い物質)等を含む層をさらに有していても良い。

10

20

30

40

50

【0492】

E L 層 8 3 3 には低分子系化合物および高分子系化合物のいずれを用いることもでき、無機化合物を含んでいても良い。E L 層 8 3 3 を構成する層は、それぞれ、蒸着法（真空蒸着法を含む）、転写法、印刷法、インクジェット法、塗布法等の方法で形成することができる。

【0493】

また、発光素子 8 4 0 の第 1 の電極 8 3 1 と第 2 の電極 8 3 5 を用いて、微小共振器（マイクロキャビティともいう）を構成できる。例えば、第 1 の電極 8 3 1 に E L 層 8 3 3 が発する光を反射する導電膜を用い、第 2 の電極 8 3 5 に、当該光の一部を反射し、一部を透過する半透過・半反射膜性の導電膜を用いて構成できる。

10

【0494】

また、光学調整層を第 1 の電極 8 3 1 と第 2 の電極 8 3 5 の間に設けることができる。光学調整層は反射性の第 1 の電極 8 3 1 と半透過・半反射性の第 2 の電極 8 3 5 の間の光学距離を調整する層であり、光学調整層の厚さを調整することにより、第 2 の電極 8 3 5 から優先的に取り出す光の波長を調整できる。

【0495】

光学調整層に用いることができる材料としては、E L 層を適用できる。例えば、電荷発生領域を用いて、その厚さを調整してもよい。特に正孔輸送性の高い物質とアクセプター性物質を含む領域を光学調整層に用いると、光学調整層が厚い構成であっても駆動電圧の上昇を抑制できるため好ましい。

20

【0496】

また、光学調整層に用いることができる他の材料としては、E L 層 8 3 3 が発する光を透過する透光性の導電膜を適用できる。例えば、反射性の導電膜の表面に該透光性を有する導電膜を積層して、第 1 の電極 8 3 1 を構成できる。この構成によれば、隣接する第 1 の電極 8 3 1 の光学調整層の厚さを変えることが容易であるため好ましい。

【0497】

絶縁膜 8 4 4 は、実施の形態 1 に示す酸化物絶縁膜及び窒化物絶縁膜を用いることができる。

【0498】

絶縁膜 8 4 6 としては、トランジスタ起因の表面凹凸を低減するために平坦化膜として機能する絶縁膜を選択するのが好適である。

30

【0499】

封止材 8 0 5 および封止基板 8 0 6 は、大気中の不純物（代表的には水および／または酸素）をできるだけ透過しない材料で形成することが望ましい。封止材 8 0 5 にはエポキシ系樹脂や、ガラスフリット等を用いることができる。

【0500】

封止基板 8 0 6 に用いることができる材料としては、支持基板 8 0 1 に適用可能な基板の他、P V F（ポリビニルフロライド）、ポリエステルまたはアクリル等からなるプラスチック基板や、FRP（Fiber Reinforced Plastics）等をその例に挙げるができる。

40

【0501】

また、支持基板 8 0 1 側に形成する構造物と封止基板 8 0 6 側に形成する構造物とが接しない空間 8 1 0 には、透光性を有する材料が含まれていてもよい。

【0502】

当該透光性を有する材料としては、例えば、発光素子の信頼性を損なう不純物（代表的には水および／または酸素）と反応、或いは不純物を吸着する材料を用いることができる。これにより、当該不純物は、発光素子の信頼性を損なう前に、充填物に含まれる材料と優先的に反応、または吸着され、その活性を失わせることができる。したがって、表示装置の信頼性を向上させることができる。

【0503】

50

当該透光性を有する材料には、例えば、正孔輸送性の高い物質、発光物質、ホスト材料、電子輸送性の高い物質、電子注入性の高い物質またはノおよびアクセプター性物質等を用いることができる。

【0504】

具体的には、導電性高分子、ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)/ポリ(スチレンスルホン酸)(PEDOT/PSS)、乾燥剤、EL層833に適用可能な材料、4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(略称:NPBまたは-NPD)、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(III)(略称:Alq)などが挙げられる。

【0505】

また、当該透光性を有する材料は、第2の電極835と封止基板806(封止基板806上に形成される構造物を含む)とを光学的に接続することができる。これにより、発光素子840から射出される光が第2の電極835から封止基板806に至る光路において、屈折率の急激な変化(屈折率の段差ともいう)が抑制され、第2の電極835側から封止基板806に、発光素子840の発光を効率よく取り出すことができる。したがって、表示装置の発光効率を向上させることができる。

【0506】

当該透光性を有する材料は、第2の電極835よりも屈折率が大きい材料であることが好ましい。当該材料を用いることで、第2の電極835と当該材料との界面における全反射を抑制し、光を効率よく取り出すことができる。

【0507】

なお、第2の電極835と封止基板806とを光学的に接続することができる材料としては、上述した材料の他に、液晶材料、フッ素系不活性液体(パーフルオロカーボン等)透光性を有する樹脂などを用いることができる。なお、これらの材料から、必要に応じて発光素子の信頼性を損なう不純物を除去してもよい。また、これらの材料に当該不純物と反応、または吸着する材料を分散してもよい。

【0508】

なお、液晶材料としては、ネマチック液晶、コレステリック液晶、スメクチック液晶、ディスコチック液晶、サーモトロピック液晶、リオトロピック液晶、低分子液晶、高分子液晶、高分子分散型液晶(PDLC)、強誘電液晶、反強誘電液晶、主鎖型液晶、側鎖型高分子液晶、バナナ型液晶等の液晶、またはこれらの液晶とカイラル剤等の混合材料を用いることができる。

【0509】

カラーフィルタ866は、光源からの光を調色し、色純度を高める目的で設けられている。例えば、白色の発光素子を用いてフルカラーの表示装置とする場合には、異なる色のカラーフィルタを設けた複数の画素を用いる。その場合、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の3色のカラーフィルタを用いてもよいし、これに黄色(Y)を加えた4色とすることもできる。また、R、G、B(およびY)に加えて白色(W)の画素を用い、4色(または5色)としてもよい。

【0510】

また、隣接するカラーフィルタ866の間に、ブラックマトリクス864が設けられている。ブラックマトリクス864は隣接する画素から回り込む光を遮光し、隣接画素間における混色を抑制する。ブラックマトリクス864は異なる発光色の隣接画素間のみ配置し、同色画素間には設けない構成としてもよい。ここで、カラーフィルタ866の端部を、ブラックマトリクス864と重なるように設けることにより、光漏れを抑制することができる。

【0511】

ブラックマトリクス864は、光を遮光する材料を用いることができ、金属材料や顔料を含む樹脂材料などを用いて形成することができる。なお、ブラックマトリクス864を駆動回路部などの発光部802以外の領域に重ねて設けると、導波光などによる意図しな

10

20

30

40

50

い光漏れを抑制することができる。

【0512】

また、図24(B)に示すように、カラーフィルタ866とブラックマトリクス864を覆うオーバーコート868を設けると、カラーフィルタ866やブラックマトリクス864に含まれる顔料などの不純物が発光素子等に拡散することを抑制できる。オーバーコート868は透光性を有し、無機絶縁材料や有機絶縁材料で形成することができる。

【0513】

なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる。

【0514】

(実施の形態10)

本実施の形態では、本発明の一態様の表示装置を搭載することのできる電子機器について説明する。

【0515】

表示装置を適用した電子機器として、例えば、テレビジョン装置(テレビ、またはテレビジョン受信機ともいう)、コンピュータ用などのモニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、デジタルフォトフレーム、携帯電話機(携帯電話、携帯電話装置ともいう)、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、パチンコ機などの大型ゲーム機などが挙げられる。これらの電子機器の具体例を図25に示す。

【0516】

図25(A)は、テレビジョン装置の一例を示している。テレビジョン装置7100は、筐体7101に表示部7103が組み込まれている。表示部7103により、映像を表示することが可能であり、表示装置を表示部7103に用いることができる。また、ここでは、スタンド7105により筐体7101を支持した構成を示している。

【0517】

テレビジョン装置7100の操作は、筐体7101が備える操作スイッチや、別体のリモートコントローラ7110により行うことができる。リモートコントローラ7110が備える操作キー7109により、チャンネルや音量の操作を行うことができ、表示部7103に表示される映像を操作することができる。また、リモートコントローラ7110に、当該リモートコントローラから出力する情報を表示する表示部7107を設ける構成としてもよい。

【0518】

なお、テレビジョン装置7100は、受信機やモデムなどを備えた構成とする。受信機により一般のテレビ放送の受信を行うことができ、さらにモデムを介して有線または無線による通信ネットワークに接続することにより、一方向(送信者から受信者)または双方向(送信者と受信者間、あるいは受信者間同士など)の情報通信を行うことも可能である。

【0519】

図25(B)はコンピュータであり、本体7201、筐体7202、表示部7203、キーボード7204、外部接続ポート7205、ポインティングデバイス7206等を含む。なお、コンピュータは、表示装置をその表示部7203に用いることにより作製される。

【0520】

図25(C)は携帯型遊技機であり、筐体7301と筐体7302の2つの筐体で構成されており、連結部7303により、開閉可能に連結されている。筐体7301には表示部7304が組み込まれ、筐体7302には表示部7305が組み込まれている。また、図25(C)に示す携帯型遊技機は、その他、スピーカ部7306、記録媒体挿入部7307、LEDランプ7308、入力手段(操作キー7309、接続端子7310、センサ7311(力、変位、位置、速度、加速度、角速度、回転数、距離、光、液、磁気、温度、化学物質、音声、時間、硬度、電場、電流、電圧、電力、放射線、流量、湿度、傾度、

10

20

30

40

50

振動、にoinまたは赤外線を測定する機能を含むもの)、マイクロフォン7312)等を備えている。もちろん、携帯型遊技機の構成は上述のものに限定されず、少なくとも表示部7304および表示部7305の両方、または一方に表示装置を用いていればよく、その他付属設備が適宜設けられた構成とすることができる。図25(C)に示す携帯型遊技機は、記録媒体に記録されているプログラムまたはデータを読み出して表示部に表示する機能や、他の携帯型遊技機と無線通信を行って情報を共有する機能を有する。なお、図25(C)に示す携帯型遊技機が有する機能はこれに限定されず、様々な機能を有することができる。

【0521】

図25(D)は、携帯電話機の一例を示している。携帯電話機7400は、筐体7401に組み込まれた表示部7402の他、操作ボタン7403、外部接続ポート7404、スピーカ7405、マイク7406などを備えている。なお、携帯電話機7400は、表示装置を表示部7402に用いることにより作製される。

【0522】

図25(D)に示す携帯電話機7400は、表示部7402を指などで触れることで、情報を入力することができる。また、電話を掛ける、或いはメールを作成するなどの操作は、表示部7402を指などで触れることにより行うことができる。

【0523】

表示部7402の画面は主として3つのモードがある。第1は、画像の表示を主とする表示モードであり、第2は、文字等の情報の入力を主とする入力モードである。第3は表示モードと入力モードの2つのモードが混合した表示+入力モードである。

【0524】

例えば、電話を掛ける、或いはメールを作成する場合は、表示部7402を文字の入力を主とする文字入力モードとし、画面に表示させた文字の入力操作を行えばよい。この場合、表示部7402の画面のほとんどにキーボードまたは番号ボタンを表示させることが好ましい。

【0525】

また、携帯電話機7400内部に、ジャイロ、加速度センサ等の傾きを検出するセンサを有する検出装置を設けることで、携帯電話機7400の向き(縦か横か)を判断して、表示部7402の画面表示を自動的に切り替えるようにすることができる。

【0526】

また、画面モードの切り替えは、表示部7402を触れること、または筐体7401の操作ボタン7403の操作により行われる。また、表示部7402に表示される画像の種類によって切り替えるようにすることもできる。例えば、表示部に表示する画像信号が動画のデータであれば表示モード、テキストデータであれば入力モードに切り替える。

【0527】

また、入力モードにおいて、表示部7402の光センサで検出される信号を検知し、表示部7402のタッチ操作による入力が一定期間ない場合には、画面のモードを入力モードから表示モードに切り替えるように制御してもよい。

【0528】

表示部7402は、イメージセンサとして機能させることもできる。例えば、表示部7402に掌や指で触れ、掌紋、指紋等を撮像することで、本人認証を行うことができる。また、表示部に近赤外光を発光するバックライトまたは近赤外光を発光するセンシング用光源を用いれば、指静脈、掌静脈などを撮像することもできる。

【0529】

図25(E)は、折りたたみ式のコンピュータの一例を示している。折りたたみ式のコンピュータ7450は、ヒンジ7454で接続された筐体7451Lと筐体7451Rを備えている。また、操作ボタン7453、左側スピーカ7455Lおよび右側スピーカ7455Rの他、コンピュータ7450の側面には図示されていない外部接続ポート7456を備える。なお、筐体7451Lに設けられた表示部7452Lと、筐体7451Rに

10

20

30

40

50

設けられた表示部 7 4 5 2 R が互いに対峙するようにヒンジ 7 4 5 4 を折り畳むと、表示部を筐体で保護することができる。

【 0 5 3 0 】

表示部 7 4 5 2 L と表示部 7 4 5 2 R は、画像を表示する他、指などで触れると情報を入力できる。例えば、インストール済みのプログラムを示すアイコンを指でふれて選択し、プログラムを起動できる。または、表示された画像の二箇所に触れた指の間隔を変えて、画像を拡大または縮小できる。または、表示された画像の一箇所に触れた指を移動して画像を移動できる。また、キーボードの画像を表示して、表示された文字や記号を指で触れて選択し、情報を入力することもできる。

【 0 5 3 1 】

また、コンピュータ 7 4 5 0 に、ジャイロ、加速度センサ、GPS (Global Positioning System) 受信機、指紋センサ、ビデオカメラを搭載することもできる。例えば、ジャイロ、加速度センサ等の傾きを検出するセンサを有する検出装置を設けることで、コンピュータ 7 4 5 0 の向き (縦か横か) を判断して、表示する画面の向きを自動的に切り替えるようにすることができる。

【 0 5 3 2 】

また、コンピュータ 7 4 5 0 はネットワークに接続できる。コンピュータ 7 4 5 0 はインターネット上の情報を表示できる他、ネットワークに接続された他の電子機器を遠隔から操作する端末として用いることができる。

【 0 5 3 3 】

図 2 5 (F) は、本実施の形態の表示装置の照明装置への適用例を示している。照明装置 7 5 0 0 は、筐体 7 5 0 1 と、光源として本発明の一態様の表示装置が組み込まれた発光部 7 5 0 3 a、発光部 7 5 0 3 b、発光部 7 5 0 3 c、発光部 7 5 0 3 d を有する。照明装置 7 5 0 0 は、天井や壁等に取り付けることが可能である。

【 0 5 3 4 】

なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる。

【実施例】

【 0 5 3 5 】

本実施例では、トランジスタを作製し、その $V_g - I_d$ 特性および信頼性の評価を行った結果について説明する。

【 0 5 3 6 】

< 試料の作製 >

本実施例では、本発明の一態様の表示装置の画素の駆動トランジスタとして適用可能な試料 1、2 と、選択トランジスタとして適用可能な試料 3 をそれぞれ作製した。より具体的には、本発明の一態様である試料 1 として、図 7 (A 1)、図 7 (B) 及び図 7 (C 1) に示すトランジスタ 4 1 0 a に相当する構成を作製した。また本発明の一態様である試料 2 として、図 1 2 (A 1)、図 1 2 (B) 及び図 1 2 (C 1) に示すトランジスタ 4 4 0 a に相当する構成を作製した。また本発明の一態様である試料 3 としては、図 2 (A 2)、図 2 B) 及び図 2 (C 2) に示すトランジスタ 4 0 0 b に相当する構成を作製した。

【 0 5 3 7 】

< 試料 1 >

まず、基板としてガラス基板を用い、基板上にゲート電極を形成した。

【 0 5 3 8 】

ゲート電極として、スパッタリング法で厚さ 2 0 0 n m のタングステン膜を形成し、フォトリソグラフィ工程により該タングステン膜上にマスクを形成し、該マスクを用いて該タングステン膜の一部をエッチングして形成した。

【 0 5 3 9 】

次に、ゲート電極上にゲート絶縁膜として機能する絶縁膜を形成した。

【 0 5 4 0 】

ゲート絶縁膜として、厚さ400nmの窒化シリコン膜と、厚さ50nmの酸化窒化シリコン膜を積層して形成した。

【0541】

なお、窒化シリコン膜は、第1の窒化シリコン膜、第2の窒化シリコン膜、および第3の窒化シリコン膜の3層積層構造とした。

【0542】

第1の窒化シリコン膜は、流量200sccmのシラン、流量2000sccmの窒素、及び流量100sccmのアンモニアガスを原料ガスとしてプラズマCVD装置の反応室に供給し、反応室内の圧力を100Paに制御し、27.12MHzの高周波電源を用いて2000Wの電力を供給して、厚さが50nmとなるように形成された。第2の窒化シリコン膜は、流量200sccmのシラン、流量2000sccmの窒素、及び流量2000sccmのアンモニアガスを原料ガスとしてプラズマCVD装置の反応室に供給し、反応室内の圧力を100Paに制御し、27.12MHzの高周波電源を用いて2000Wの電力を供給して、厚さが300nmとなるように形成された。第3の窒化シリコン膜は、流量200sccmのシラン、及び流量5000sccmの窒素を原料ガスとしてプラズマCVD装置の反応室に供給し、反応室内の圧力を100Paに制御し、27.12MHzの高周波電源を用いて2000Wの電力を供給して、厚さが50nmとなるように形成された。なお、第1の窒化シリコン膜、第2の窒化シリコン膜、及び第3の窒化シリコン膜形成時の基板温度は350とした。

【0543】

酸化窒化シリコン膜は、流量20sccmのシラン、流量3000sccmの一酸化二窒素を原料ガスとしてプラズマCVD装置の反応室に供給し、反応室内の圧力を40Paに制御し、27.12MHzの高周波電源を用いて100Wの電力を供給して形成された。なお、酸化窒化シリコン膜形成時の基板温度は350とした。

【0544】

次に、ゲート絶縁膜を介してゲート電極に重なる酸化物半導体膜を形成した。

【0545】

ここでは、ゲート絶縁膜上に厚さ35nmの酸化物半導体膜をスパッタリング法で形成した。

【0546】

酸化物半導体膜は、スパッタリングターゲットをIn:Ga:Zn=1:1:1(原子数比)のターゲットとし、流量100sccmの酸素をスパッタリングガスとしてスパッタリング装置の反応室内に供給し、反応室内の圧力を0.6Paに制御し、5kWの直流電力を供給して形成された。なお、酸化物半導体膜を形成する際の基板温度を170とした。

【0547】

次に、酸化物半導体膜に接する一対の電極を形成した。

【0548】

まず、ゲート絶縁膜および酸化物半導体膜上に導電膜を形成した。該導電膜として、厚さ50nmのタングステン膜上に厚さ400nmのアルミニウム膜を形成し、該アルミニウム膜上に厚さ200nmのチタン膜を形成した。次に、フォトリソグラフィ工程により該導電膜上にマスクを形成し、該マスクを用いて該導電膜の一部をエッチングし、一対の電極を形成した。

【0549】

次に、減圧された処理室に基板を移動し、350で加熱した後、反応室に設けられる上部電極に27.12MHzの高周波電源を用いて150Wの高周波電力を供給して、一酸化二窒素雰囲気中で発生させた酸素プラズマに酸化物半導体膜を曝した。

【0550】

次に、酸化物半導体膜及び一対の電極上に第2のゲート絶縁膜を形成した。ここでは、第2のゲート絶縁膜として第1の酸化物絶縁膜、第2の酸化物絶縁膜、および窒化物絶縁

10

20

30

40

50

膜の3層構造とした。

【0551】

第1の酸化物絶縁膜は、流量20 sccmのシラン及び流量3000 sccmの一酸化二窒素を原料ガスとし、反応室の圧力を200 Pa、基板温度を350 とし、100 Wの高周波電力を平行平板電極に供給したプラズマCVD法により形成した。

【0552】

第2の酸化物絶縁膜は、流量160 sccmのシラン及び流量4000 sccmの一酸化二窒素を原料ガスとし、反応室の圧力を200 Pa、基板温度を220 とし、1500 Wの高周波電力を平行平板電極に供給したプラズマCVD法により形成した。当該条件により、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含み、加熱により酸素の一部が脱離する酸化窒化シリコン膜を形成することができる。

10

【0553】

次に、加熱処理を行い、第1の酸化物絶縁膜および第2の酸化物絶縁膜から水、窒素、水素等を脱離させると共に、第2の酸化物絶縁膜に含まれる酸素の一部を酸化物半導体膜へ供給した。ここでは、窒素及び酸素雰囲気中、350 、1時間の加熱処理を行った。

【0554】

次に、第2の酸化物絶縁膜上に、厚さ100 nmの窒化物絶縁膜を形成した。窒化物絶縁膜は、流量50 sccmのシラン、流量5000 sccmの窒素、及び流量100 sccmのアモニアガスを原料ガスとし、反応室の圧力を100 Pa、基板温度を350 とし、1000 Wの高周波電力を平行平板電極に供給したプラズマCVD法により形成された。

20

【0555】

次に、酸化物半導体膜及び一対の電極が設けられていない領域において、ゲート絶縁膜及び第2のゲート絶縁膜の一部に、ゲート電極に達する開口部を形成した。当該開口部は、フォトリソグラフィ工程により第2のゲート絶縁膜上にマスクを形成し、該マスクを用いてゲート絶縁膜及び第2のゲート絶縁膜の一部をエッチングすることにより形成した。

【0556】

次に、第2のゲート絶縁膜上にバックゲート電極として機能する第2のゲート電極を形成した。バックゲート電極は、ゲート絶縁膜及び第2のゲート絶縁膜の一部に設けられた開口部を介して、ゲート電極と電気的に接続する構成とした。

30

【0557】

ここでは、バックゲート電極として、スパッタリング法により厚さ100 nmの酸化シリコンを含む酸化インジウム-酸化スズ化合物(ITO-SiO_2)の導電膜を形成した。なお該導電膜に用いたターゲットの組成は、 $\text{In}_2\text{O}_3 : \text{SnO}_2 : \text{SiO}_2 = 85 : 10 : 5$ [重量%]とした。この後、窒素雰囲気中、250 、1時間の加熱処理を行った。

【0558】

以上の工程により、本実施例の試料1を得た。

【0559】

<試料2>

40

試料2は試料1と比較し、第2のゲート絶縁膜及びバックゲート電極の構造が異なる。より具体的には、図12(C1)に示すように、トランジスタのチャネル幅方向において、第1の酸化物絶縁膜及び第2の酸化物絶縁膜の側面をバックゲート電極が覆うような構成とした。

【0560】

試料2の作製は、上述した試料1の作製工程において、第1の酸化物絶縁膜、第2の酸化物絶縁膜を成膜し、加熱処理を行ったのちに、フォトリソグラフィ工程により第2の酸化物絶縁膜上にマスクを形成した。続いて該マスクを用いて第1の酸化物絶縁膜、第2の酸化物絶縁膜の一部をエッチングした。それ以外の工程は、上述した試料1と同様であるため、試料1の記載を援用できる。

50

【 0 5 6 1 】

< 試料 3 >

試料 3 は、試料 1 と比較し、バックゲート電極を有さない点で相違する。

【 0 5 6 2 】

試料 3 の作製は、上述した試料 1 の作製工程において、バックゲート電極の形成工程を省略することにより作製した。それ以外の工程は、上述した試料 1 と同様であるため、試料 1 の記載を援用できる。

【 0 5 6 3 】

なお、上述した試料 1 乃至試料 3 として、チャンネル幅 (W) を 5 0 μm であり、チャンネル長 (L) が 2 μm 、3 μm 、および 6 μm である、3 種類のトランジスタをそれぞれ作製した。

【 0 5 6 4 】

< V g - I d 特性 >

次に、試料 1 乃至試料 3 のトランジスタの初期特性として、V g - I d 特性を測定した。ここでは、基板温度を 2 5 とし、ソース - ドレイン間の電位差 (以下、ドレイン電圧、V d ともいう) を 1 V、1 0 V とし、ソース - ゲート電極間の電位差 (以下、ゲート電圧、V g ともいう) を - 1 5 V 乃至 1 5 V まで変化させたときのソース - ドレイン間に流れる電流 (以下、ドレイン電流、I d ともいう) の変化特性、すなわち V g - I d 特性を測定した。

【 0 5 6 5 】

ここで、試料 1 及び試料 2 においては、ゲート電極とバックゲート電極とが電氣的に短絡した状態でゲート電圧を加えるような駆動方法を用いた。このような駆動方法を D u a l G a t e (デュアルゲート) 駆動という。すなわち、D u a l G a t e 駆動では、常にゲート電極とバックゲート電極とのゲート電圧が等しくなる。

【 0 5 6 6 】

図 2 6 に、試料 3 の V g - I d 特性を示す。図 2 6 (A)、(B)、(C) はそれぞれ、チャンネル長 (L) が 2 μm 、3 μm 、6 μm であるトランジスタについての結果である。また同様に、図 2 7 には試料 1 の V g - I d 特性を、図 2 8 には試料 2 の V g - I d 特性をそれぞれ示している。

【 0 5 6 7 】

また、図 2 6、図 2 7、図 2 8 のそれぞれにおいて、横軸はゲート電圧 V g を、第 1 の縦軸はドレイン電流 I d を、第 2 の縦軸は、電界効果移動度 M o b i l i t y をそれぞれ示す。ここで、電界効果移動度は、飽和領域での値を示すために、V d = 1 0 V で算出した電界効果移動度を示している。

【 0 5 6 8 】

図 2 6 に示す試料 3 (本発明の一態様の表示装置において画素の選択トランジスタに用いることが好適なトランジスタ) は、チャンネル長 (L) を大きくするほど、しきい値電圧がマイナス方向のシフトが抑制される結果が示された。特に、ドレイン電圧 V d が大きい場合でのしきい値電圧のマイナス方向へのシフトの抑制効果が顕著に確認された。なお、チャンネル長 (L) によらず、電界効果移動度の値はほとんど変化しないことが分かった。

【 0 5 6 9 】

また、図 2 7 に示す試料 1 (本発明の一態様の表示装置において画素の駆動トランジスタに用いることが好適なトランジスタ) は、すべてのチャンネル長 (L) の条件で、上記試料 3 に比べて電界効果移動度が向上していることが確認できた。さらに、チャンネル長 (L) が小さいほど、電界効果移動度が向上することが分かった。また、デュアルゲート駆動とすることで、チャンネル長 (L) の小さい条件 (L = 2 μm) であっても、ドレイン電圧 V d に対するしきい値電圧の変化は極めて小さいものであることが分かった。

【 0 5 7 0 】

また、図 2 8 に示す試料 2 (本発明の一態様の表示装置において画素の駆動トランジスタに用いることが好適なトランジスタ) は、すべてのチャンネル長 (L) の条件で、上記試

10

20

30

40

50

料 3 に比べて電界効果移動度が向上していることが確認できた。さらに、チャンネル長 (L) が小さいほど、電界効果移動度が向上することが分かった。また、デュアルゲート駆動とすることで、チャンネル長 (L) の小さい条件 ($L = 2 \mu m$) であっても、ドレイン電圧 V_d に対するしきい値電圧の変化は極めて小さいものであることが分かった。

【 0 5 7 1 】

以上の結果から、チャンネル長 (L) を大きくするほど、しきい値電圧のマイナス方向のシフトが抑制されることが確認された。また、チャンネル長 (L) が小さいほど電界効果移動度が向上することが確認された。さらには、デュアルゲート駆動とすることでチャンネルが形成される酸化物半導体に対してより効果的に電界を加えることが可能となり、その結果チャンネル長 (L) が小さい場合であっても、ドレイン電圧 V_d に対するしきい値電圧の変化を小さくすることができていることがわかる。したがって、高い電界効果移動度が求められる画素の駆動トランジスタにおいては、チャンネル長 (L) を小さく (代表的には、 $L = 2 \mu m$) 且つデュアルゲート駆動とし、ノーマリーオフ特性が求められる画素の選択トランジスタにおいては、チャンネル長 (L) を該駆動トランジスタより大きくすることで、高速駆動及び低消費電力化を実現可能な表示装置を提供することができる。

【 符号の説明 】

【 0 5 7 2 】

1 1	基板	
1 2	導電膜	
1 3 a	ゲート電極	20
1 3 b	ゲート電極	
1 3 c	電極	
1 3 d	電極	
1 4	絶縁膜	
1 4 b	酸化物絶縁膜	
1 5	絶縁膜	
1 5 a	窒化物絶縁膜	
1 5 b	酸化物絶縁膜	
1 6	酸化物半導体膜	
1 7	酸化物半導体膜	30
1 7 a	酸化物半導体膜	
1 7 b	酸化物半導体膜	
1 8	導電膜	
2 0 a	電極	
2 0 b	電極	
2 0 c	電極	
2 0 d	電極	
2 0 e	電極	
2 1 a	低抵抗領域	
2 1 b	低抵抗領域	40
2 1 c	低抵抗領域	
2 1 d	低抵抗領域	
2 2	酸化物絶縁膜	
2 3	酸化物絶縁膜	
2 4	酸化物絶縁膜	
2 5	酸化物絶縁膜	
2 6	窒化物絶縁膜	
2 7	窒化物絶縁膜	
2 8	絶縁膜	
3 0	導電膜	50

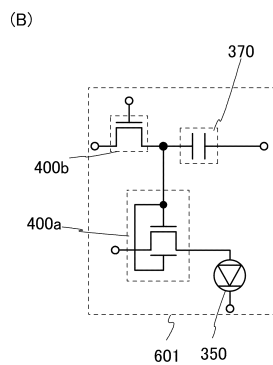
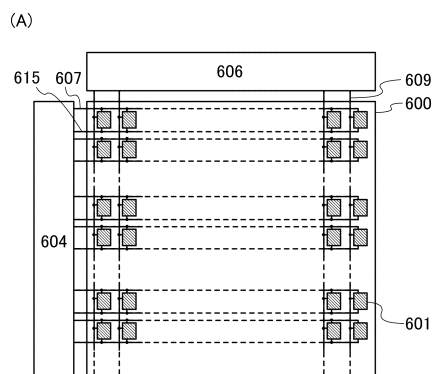
3 1	ゲート電極	
3 2	電極	
3 3	破線	
3 4	破線	
4 1	開口部	
4 2	開口部	
4 3	開口部	
5 1	ゲート電極	
6 1	開口部	
6 2	導電膜	10
6 3	開口部	
6 4	ゲート電極	
7 1 a	酸化物絶縁膜	
7 1 b	酸化物絶縁膜	
7 2 a	酸化物絶縁膜	
7 2 b	酸化物絶縁膜	
7 3 a	窒化物絶縁膜	
7 3 b	窒化物絶縁膜	
7 4 a	絶縁膜	
7 4 b	絶縁膜	20
7 5	開口部	
7 6	ゲート電極	
7 7	電極	
8 3 a	酸化物絶縁膜	
8 3 b	酸化物絶縁膜	
8 5 a	酸化物絶縁膜	
8 5 b	酸化物絶縁膜	
8 6	窒化物絶縁膜	
8 7	窒化物絶縁膜	
8 8 a	絶縁膜	30
8 8 b	絶縁膜	
9 0	導電膜	
9 1	ゲート電極	
9 2	電極	
9 4 a	多層膜	
9 4 b	多層膜	
9 5	開口部	
9 6	開口部	
9 7	酸化物半導体膜	
9 7 a	酸化物半導体膜	40
9 7 b	酸化物半導体膜	
9 8 a	多層膜	
9 8 b	多層膜	
9 9	酸化物半導体膜	
9 9 a	酸化物半導体膜	
9 9 b	酸化物半導体膜	
1 0 2	開口部	
1 0 3	開口部	
1 0 5 a	トランジスタ	
1 0 5 b	トランジスタ	50

1 0 6 a	トランジスタ	
1 0 6 b	トランジスタ	
1 0 9	ゲート電極	
3 0 0 a	トランジスタ	
3 0 0 b	トランジスタ	
3 0 0 c	トランジスタ	
3 0 6 a	絶縁膜	
3 0 6 b	絶縁膜	
3 1 4	酸化物絶縁膜	
3 1 6	窒化物絶縁膜	10
3 1 8	絶縁膜	
3 2 0	ゲート電極	
3 2 2	画素電極	
3 2 4	絶縁膜	
3 2 6	E L 層	
3 2 8	電極	
3 5 0	発光素子	
3 5 2 a	開口部	
3 5 2 b	開口部	
3 5 2 c	開口部	20
3 5 4	開口部	
3 5 6 a	開口部	
3 5 6 b	開口部	
3 7 0	容量素子	
4 0 0 a	トランジスタ	
4 0 0 b	トランジスタ	
4 1 0 a	トランジスタ	
4 2 0 a	トランジスタ	
4 3 0 a	トランジスタ	
4 3 0 b	トランジスタ	30
4 4 0 a	トランジスタ	
4 4 0 b	トランジスタ	
4 4 4	電気力線	
4 5 0 b	トランジスタ	
6 0 0	画素部	
6 0 1	画素	
6 0 2	画素	
6 0 3	画素	
6 0 4	走査線駆動回路	
6 0 6	信号線駆動回路	40
6 0 7	走査線	
6 0 9	信号線	
6 1 5	容量線	
8 0 1	支持基板	
8 0 2	発光部	
8 0 3	駆動回路部	
8 0 4	駆動回路部	
8 0 5	封止材	
8 0 6	封止基板	
8 0 8	F P C	50

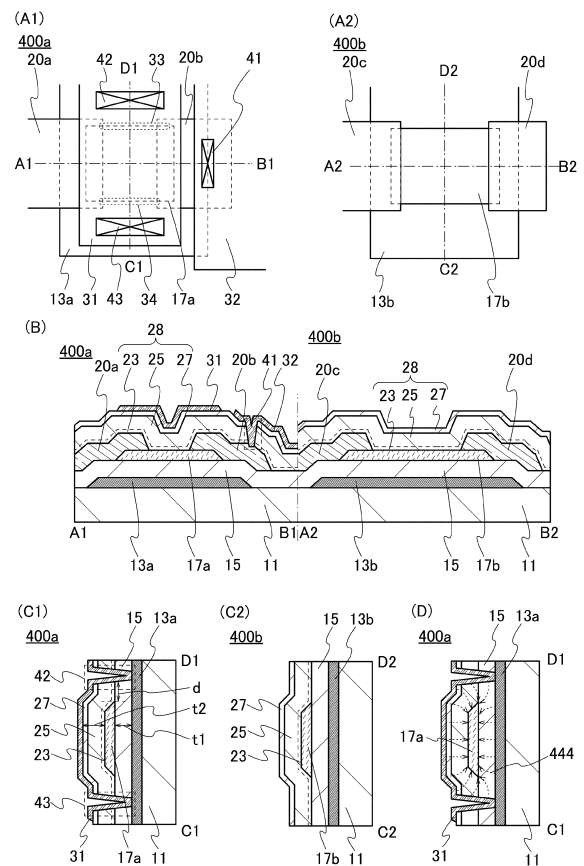
8 0 9	配線	
8 1 0	空間	
8 1 1	トランジスタ	
8 3 1	電極	
8 3 2	ゲート電極	
8 3 3	E L 層	
8 3 5	電極	
8 3 9	絶縁膜	
8 4 0	発光素子	
8 4 4	絶縁膜	10
8 4 6	絶縁膜	
8 5 2	トランジスタ	
8 5 3	トランジスタ	
8 6 4	ブラックマトリクス	
8 6 6	カラーフィルタ	
8 6 8	オーバーコート	
7 1 0 0	テレビジョン装置	
7 1 0 1	筐体	
7 1 0 3	表示部	
7 1 0 5	スタンド	20
7 1 0 7	表示部	
7 1 0 9	操作キー	
7 1 1 0	リモートコントローラ	
7 2 0 1	本体	
7 2 0 2	筐体	
7 2 0 3	表示部	
7 2 0 4	キーボード	
7 2 0 5	外部接続ポート	
7 2 0 6	ポインティングデバイス	
7 3 0 1	筐体	30
7 3 0 2	筐体	
7 3 0 3	連結部	
7 3 0 4	表示部	
7 3 0 5	表示部	
7 3 0 6	スピーカ部	
7 3 0 7	記録媒体挿入部	
7 3 0 8	L E D ランプ	
7 3 0 9	操作キー	
7 3 1 0	接続端子	
7 3 1 1	センサ	40
7 3 1 2	マイクロフォン	
7 4 0 0	携帯電話機	
7 4 0 1	筐体	
7 4 0 2	表示部	
7 4 0 3	操作ボタン	
7 4 0 4	外部接続ポート	
7 4 0 5	スピーカ	
7 4 0 6	マイク	
7 4 5 0	コンピュータ	
7 4 5 1 L	筐体	50

7 4 5 1 R	筐体
7 4 5 2 L	表示部
7 4 5 2 R	表示部
7 4 5 3	操作ボタン
7 4 5 4	ヒンジ
7 4 5 5 L	左側スピーカ
7 4 5 5 R	右側スピーカ
7 4 5 6	外部接続ポート
7 5 0 0	照明装置
7 5 0 1	筐体
7 5 0 3 a	発光部
7 5 0 3 b	発光部
7 5 0 3 c	発光部
7 5 0 3 d	発光部

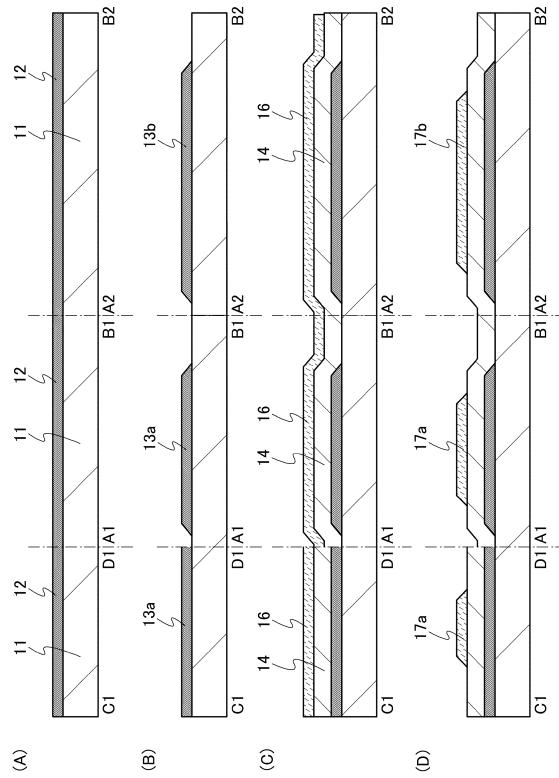
【図 1】



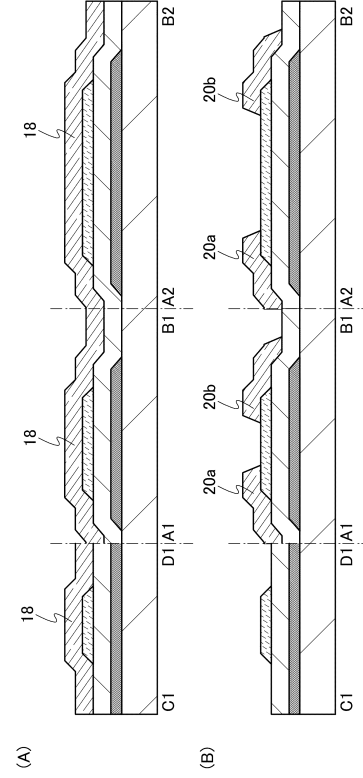
【図 2】



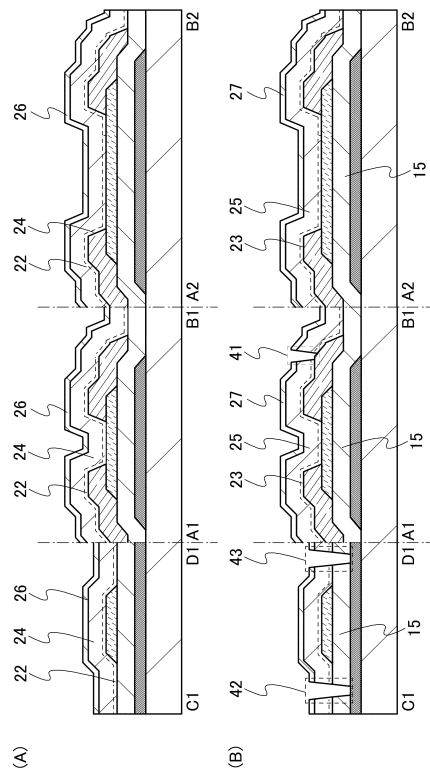
【図 3】



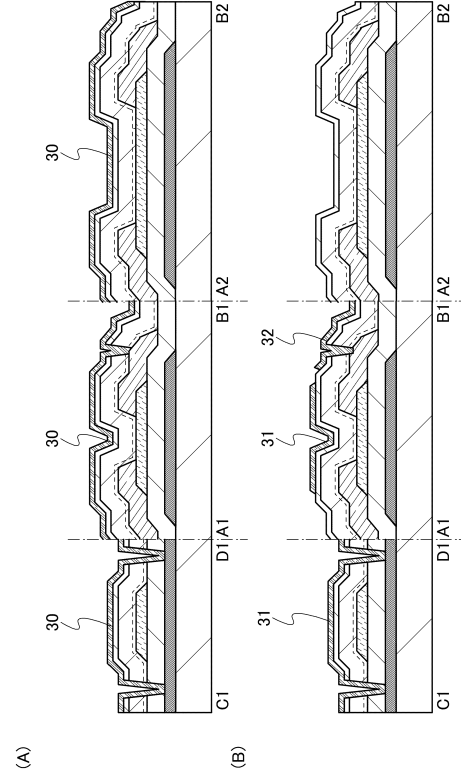
【図 4】



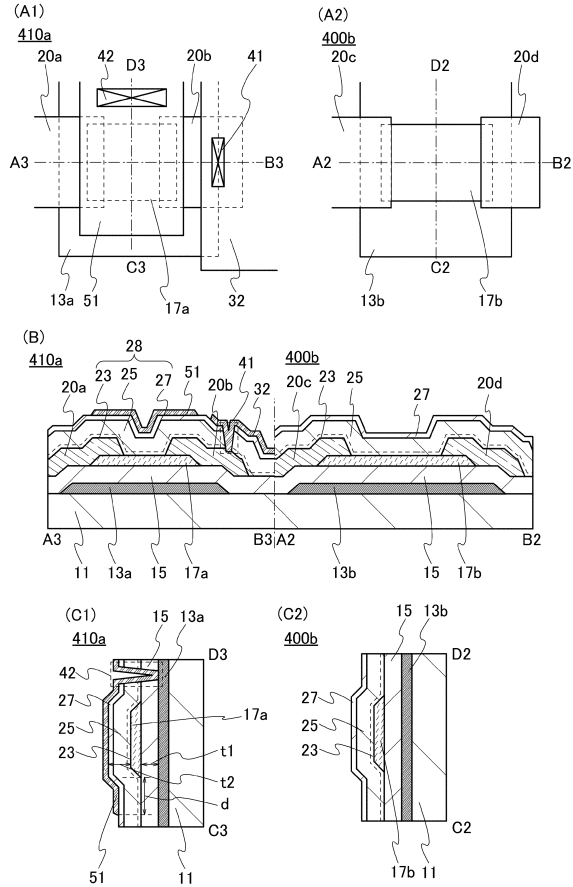
【図 5】



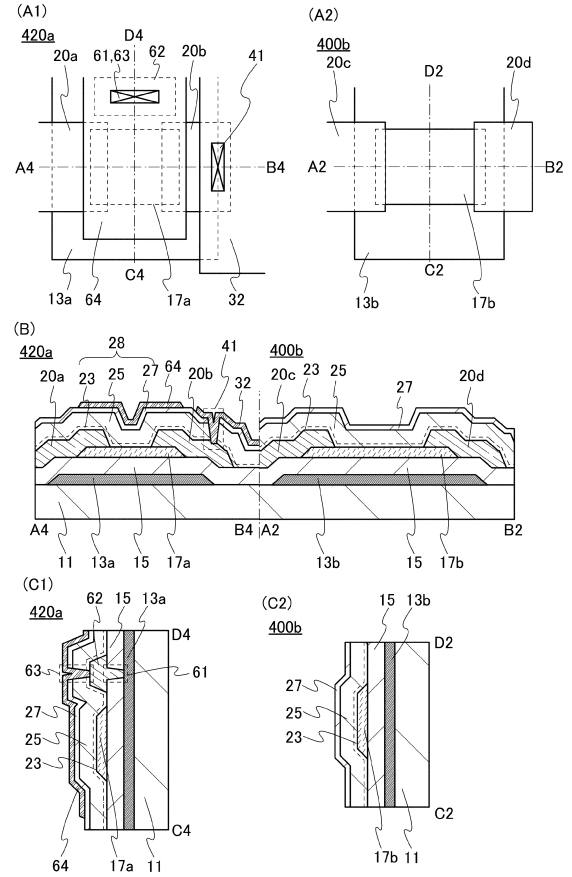
【図 6】



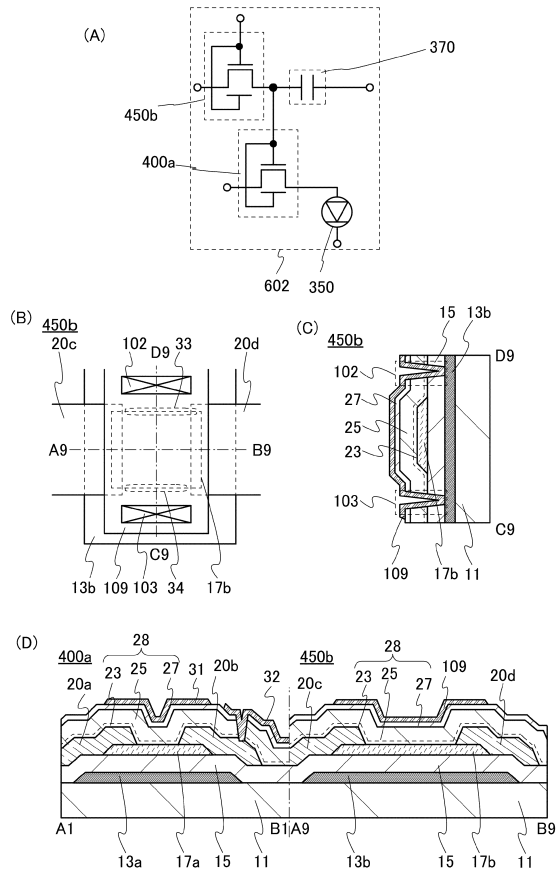
【図 7】



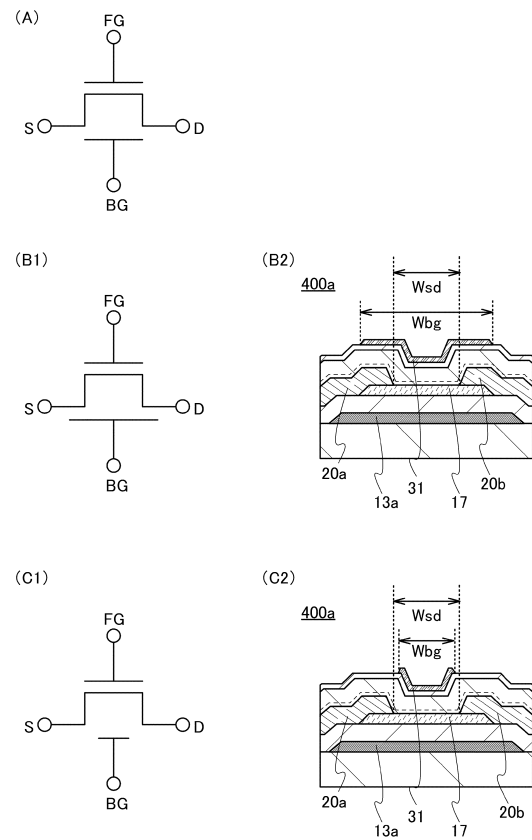
【図 8】



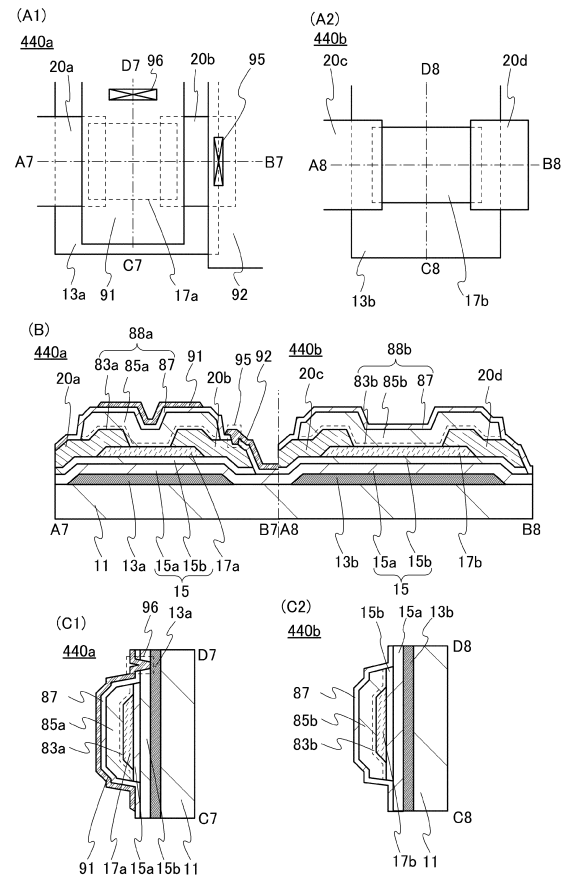
【図 9】



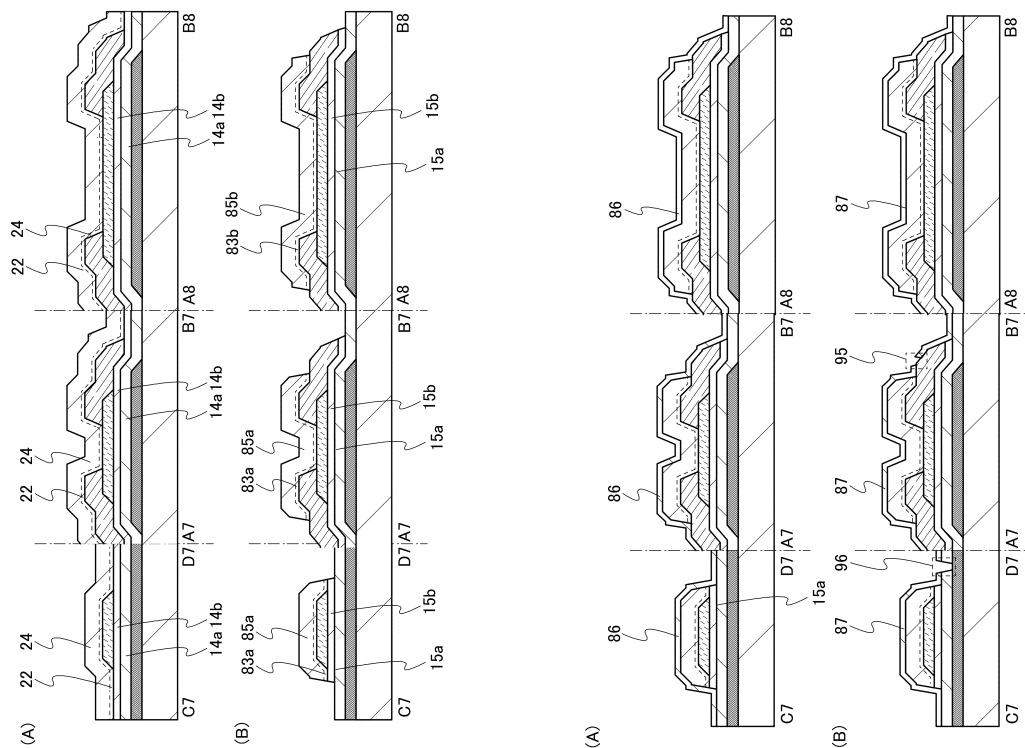
【図 10】



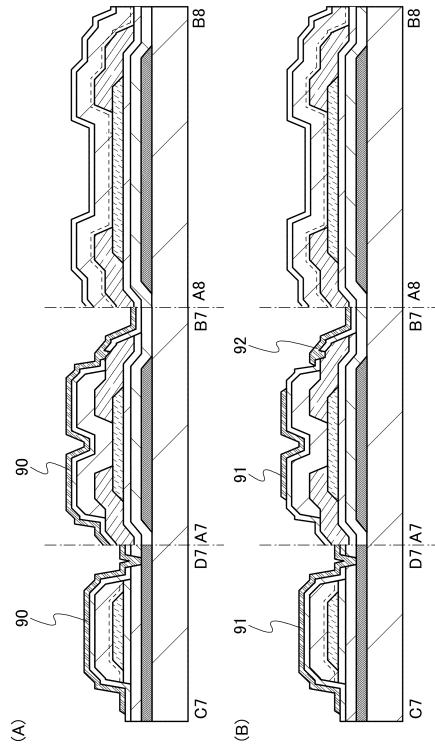
【 図 1 2 】



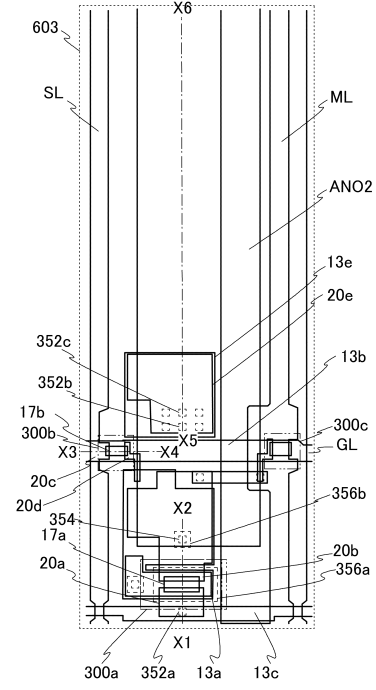
【 図 1 4 】



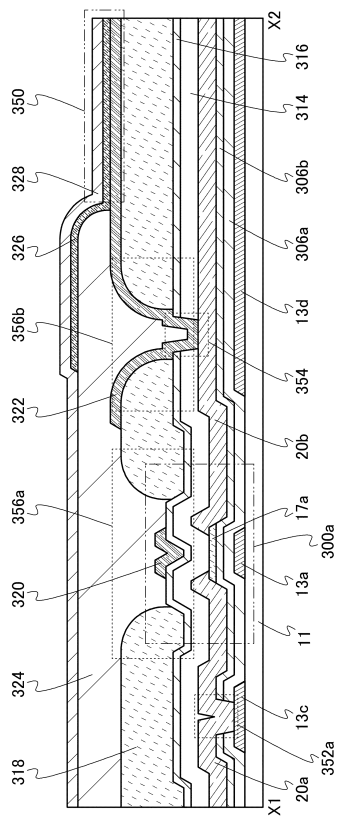
【図 15】



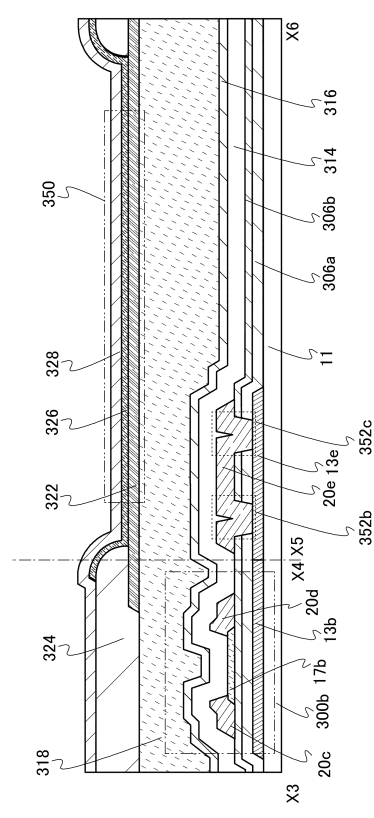
【図 16】



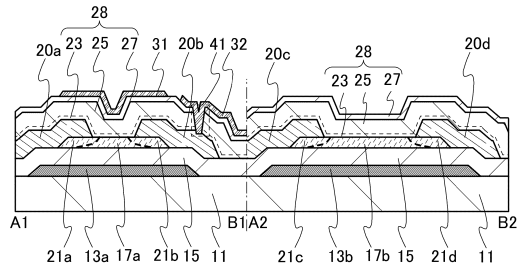
【図 17】



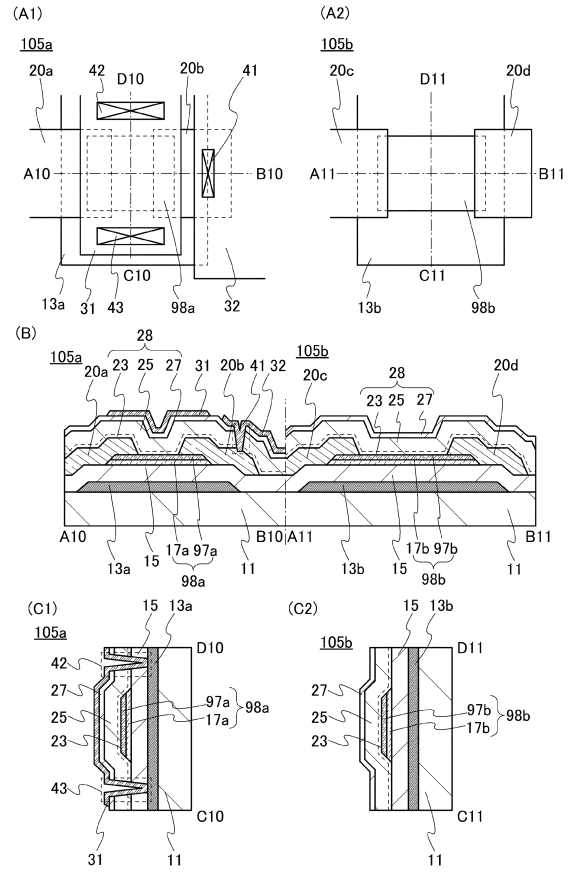
【図 18】



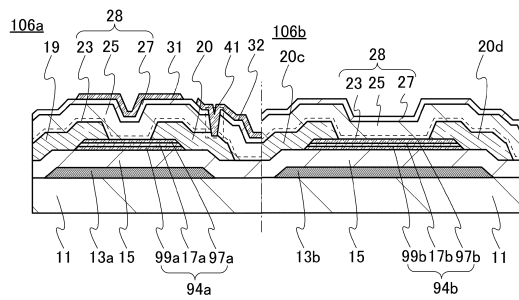
【図 19】



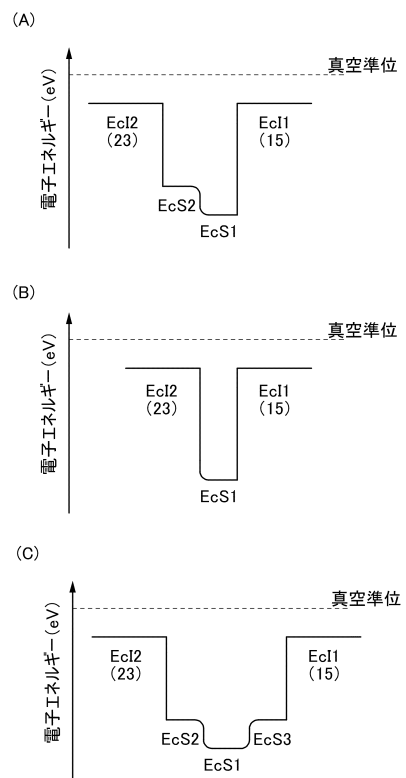
【図 20】



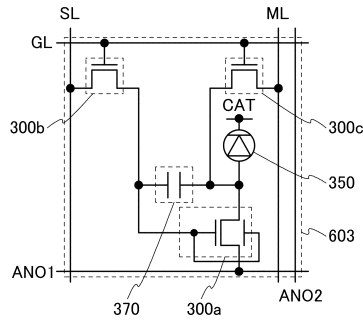
【図 21】



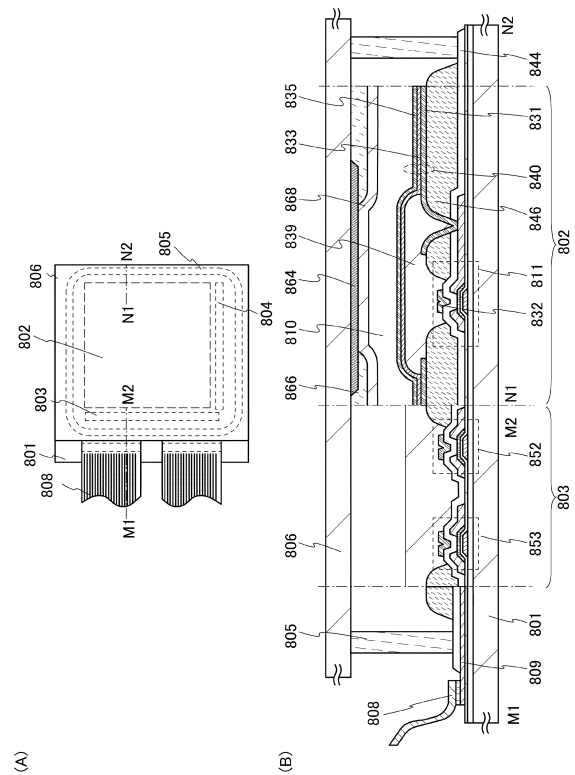
【図 22】



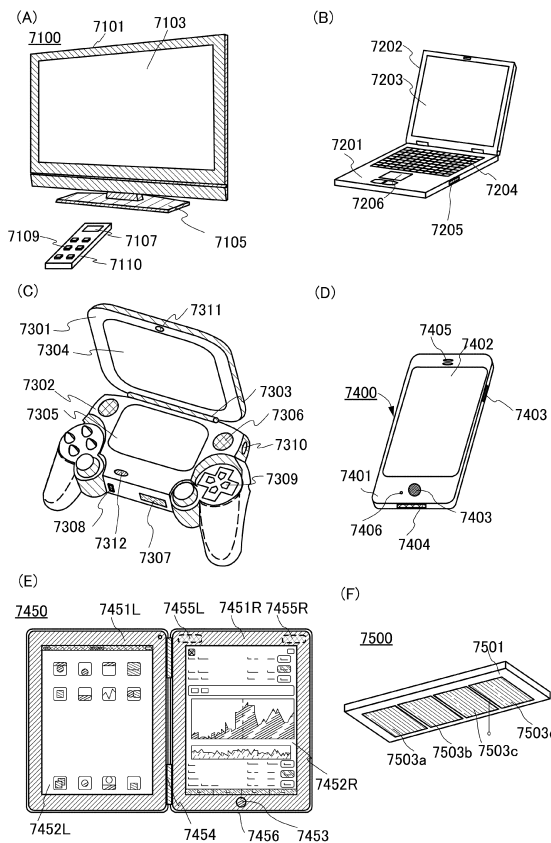
【図 23】



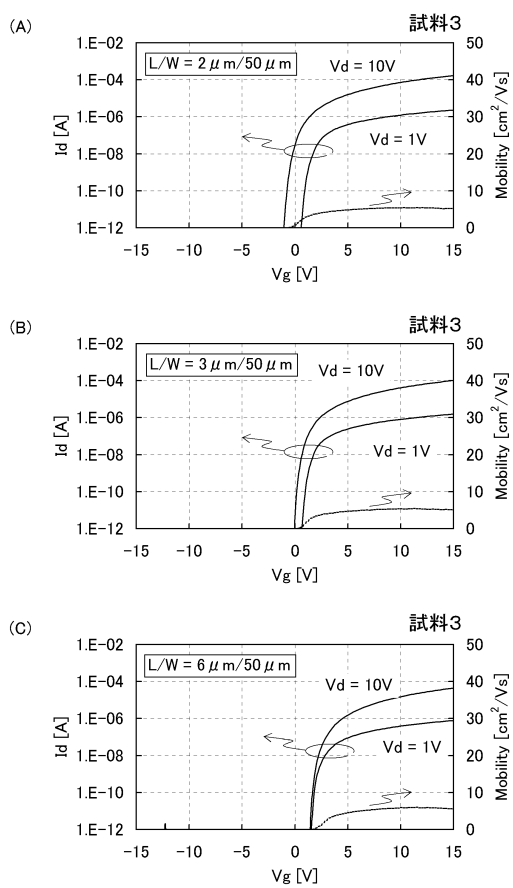
【図 24】



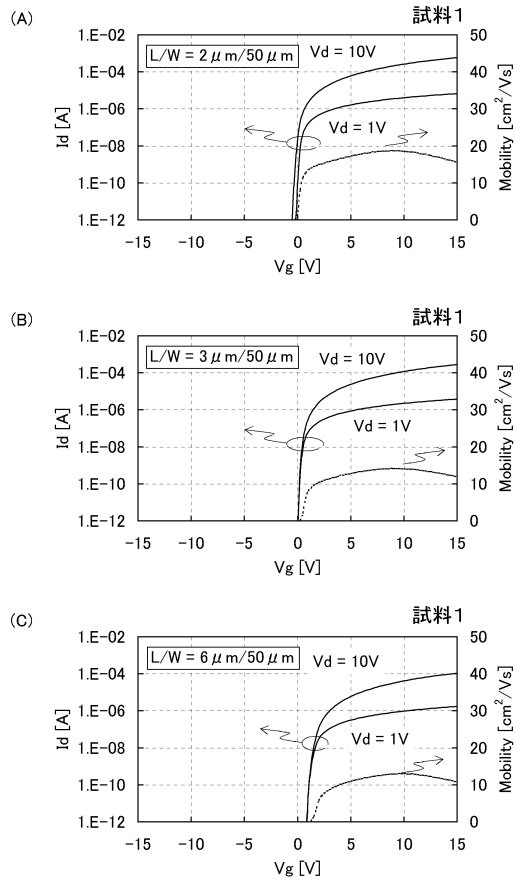
【図 25】



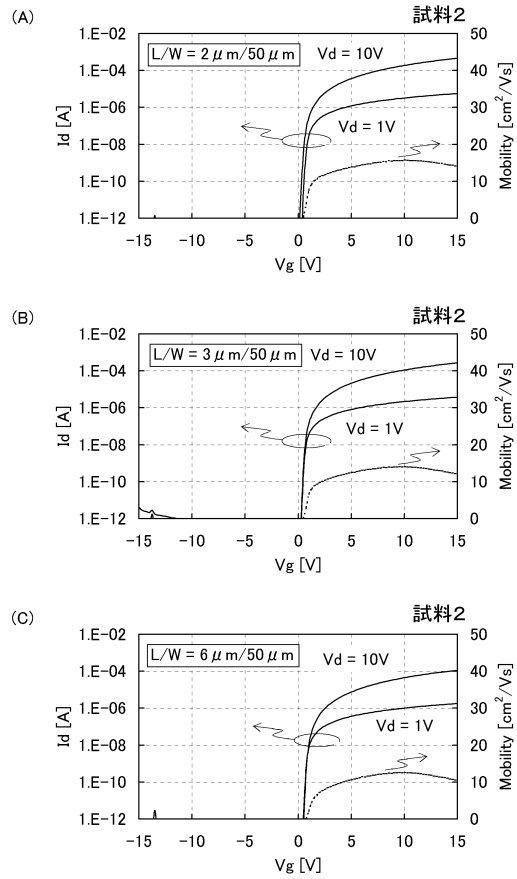
【図 26】



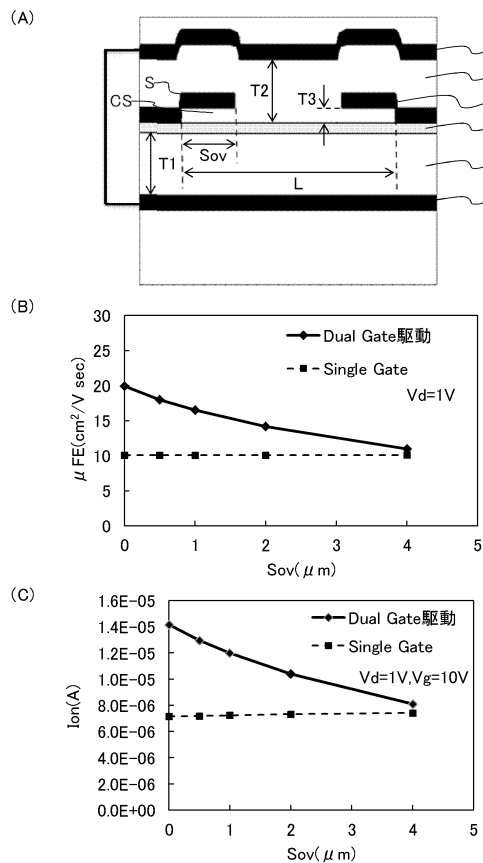
【図 27】



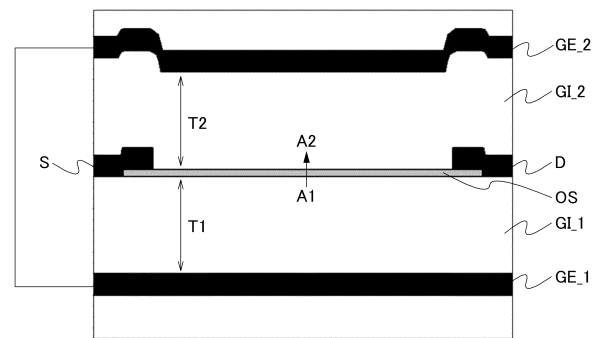
【図 28】



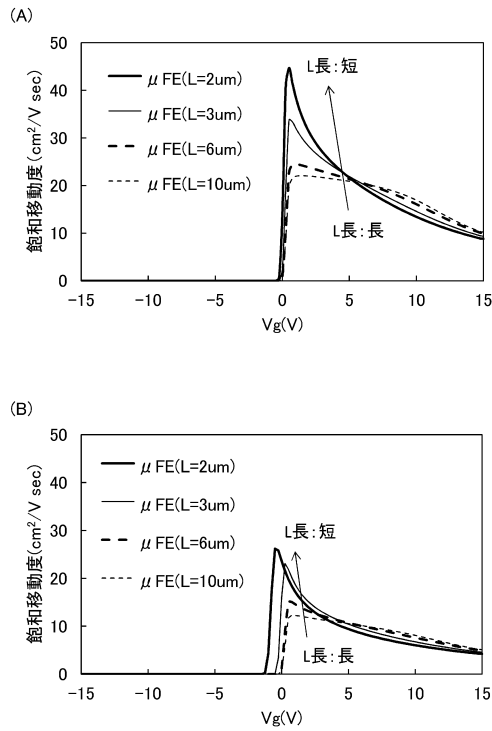
【図 29】



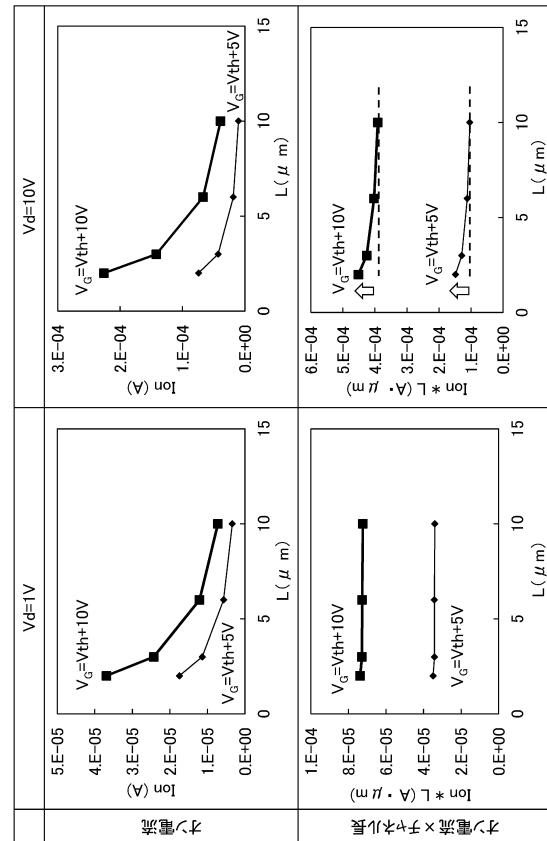
【図 30】



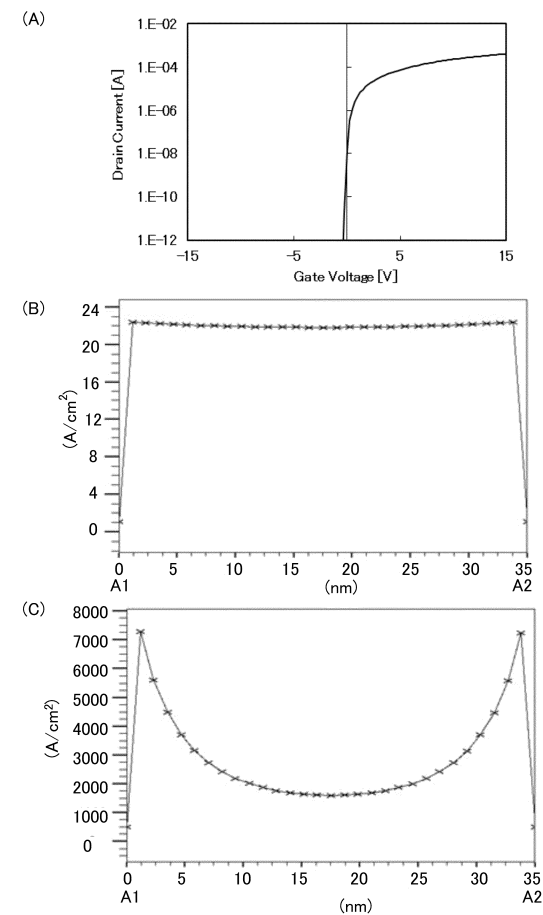
【図 3 1】



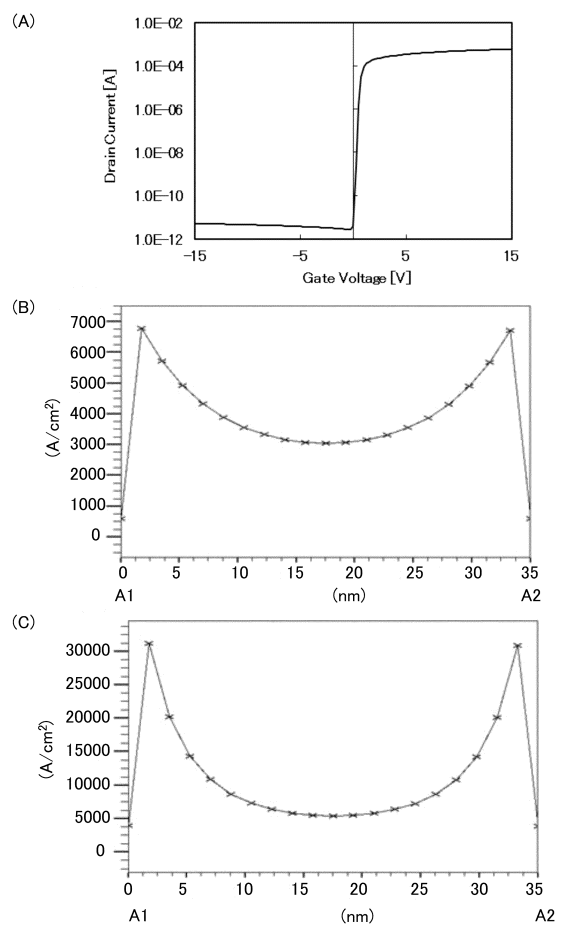
【図 3 2】



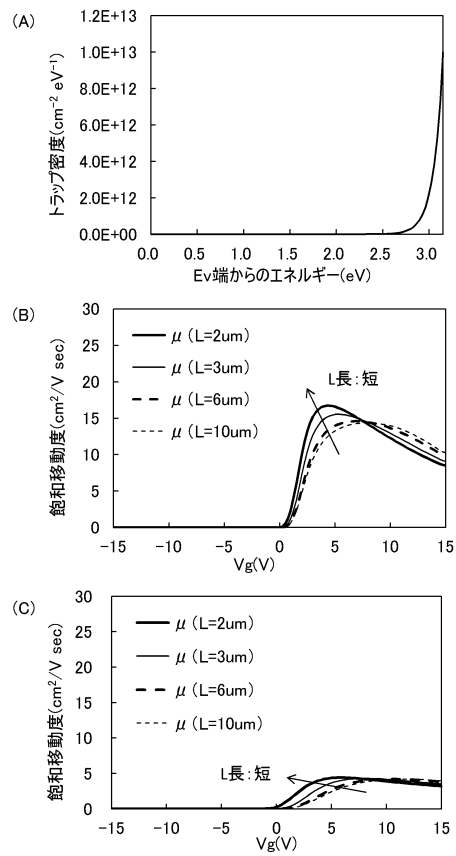
【図 3 3】



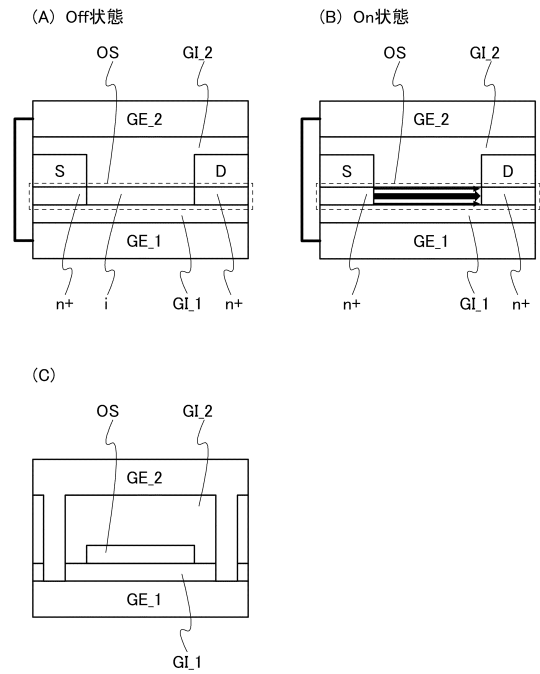
【図 3 4】



【図 35】



【図 36】



フロントページの続き

(72)発明者 松林 大介

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

(72)発明者 早川 昌彦

栃木県栃木市都賀町升塚161-2 アドバンスト フィルム デバイス インク株式会社内

審査官 綿引 隆

(56)参考文献 特開2011-049548(JP,A)

特開2010-123938(JP,A)

特開2011-181913(JP,A)

特開2011-071476(JP,A)

特開2011-076080(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01L 21/336

H01L 29/786

H01L 51/50

H05B 33/08